

第一原理擬ポテンシャル法による 電子状態計算プログラム

「Osaka2002_nano」

I 「基礎編」

第1.6版

大阪大学・産業科学研究所
白井光雲

2 November 2004

History

Rev. 0.7 04 March 2003

Rev. 0.9 18 December 2003

Rev. 1.0 04 February 2004

Rev. 1.1 02 November 2004

Rev. 1.5 29 December 2005

Rev. 1.6 06 April 2006

目 次

序論	4
第 1 章 理論	7
1.1 密度汎関数法	7
1.2 局所密度近似	9
1.3 擬ポテンシャル近似	9
1.4 平面波展開	11
1.5 平面波のカットオフ	13
1.6 k 空間上の総和	14
1.7 Kohn-Sham 汎関数における共役勾配最小法	15
1.8 高速フーリエ変換	19
1.9 Hellmann-Feynman 力とストレス	20
第 2 章 ロードマップ	22
2.1 概略	22
2.2 計算環境と準備	23
2.2.1 機種ごとの対応	25
2.3 入力パラメータ	25
2.3.1 オプション	26
第 3 章 原子擬ポテンシャル	27
3.1 入力ファイル	27
3.2 実行	30
第 4 章 結晶の作成	33
4.1 結晶データ入力	33
4.2 cryst の実行	36
4.3 制御パラメータ	37
4.4 結晶のグラフィックス表示	38
第 5 章 電子の基底状態計算 (I)	39
5.1 inip	39
5.1.1 k サンプリング法	40
5.1.2 平面波カットオフ半径	43
5.2 pwm の動作	45
5.2.1 セルフコンシスティント計算	45

5.2.2	解釈	47
5.2.3	再計算	51
5.2.4	電荷密度の表示	53
5.2.5	収束がうまくいかない場合	55
5.2.6	関係するオプション	56
第 6 章	電子の基底状態計算 (II)	58
6.1	原子位置の最適化	58
6.1.1	計算の準備	58
6.1.2	結果の読み方	59
6.1.3	力の誤差について	60
6.1.4	収束に関する議論	61
6.2	格子定数の最適化	63
6.2.1	計算の準備	63
6.2.2	結果の読み方	64
6.2.3	収束に関する議論	65
6.2.4	圧力依存性の取り方	66
6.2.5	関係するオプション	67
第 7 章	電子構造スペクトル	68
7.1	DOS 構造	68
7.1.1	準備	68
7.1.2	DOS 構造の結果	70
7.1.3	表示	72
7.1.4	フェルミ面	74
7.2	バンド構造	74
7.2.1	準備	75
7.2.2	バンド構造の結果	76
7.3	波動関数のプロット	82
付 錄 A	結晶の Mathematica によるグラフィックス表示	83
A.1	グラフィックス座標の取り方	83
A.2	電荷密度分布	86
謝辞		88
参考文献		89

序論

パッケージ「Osaka2002_nano」(略称「Osaka2002」)は密度汎関数理論に基づく固体の電子状態計算のプログラム集である。具体的な手法としては擬ポテンシャル法による平面波展開法を用いることで、固体の電子状態計算から、構造の最適化、フォノン、光学定数の計算、さらに有限温度の分子動力学シミュレーションなど広範囲の電子状態計算を行える。

今日では「第一原理計算」と呼ばれるものは、その精度ゆえかなりの信頼で受け入れられてきている。化学の分野ではもうそのようになっているような気がするが、固体物理の分野でも、実験家が得たデータの解釈や実験予測などに日常的に第一原理計算を活用することはそんなに遠くないようだ。

しかしながら現実には、固体物理の分野で実験家の人々がそのように第一原理計算プログラムを使おうとするとかなりギャップがあるのではないだろうか？たぶん多くの人にとつて一番大きな問題なのは、計算技術を取得するための障害であろう。

今日では「公開」と称されているプログラムはかなりの数に上ると思われるが、その多くはソースプログラムを公開しているだけという意味が多い。実際には使い方を伝授してもらわねばまず使うことはできない。簡単な使い方について書かれた書類が添付されているものもあるが、それらはあくまでそれが使用される研究室の環境を想定しているわけで、実際の使用に際しては適当な経験者の指導があって初めて使えるようになる。

今日の第一原理計算は、あたかも複雑な建築物のように様々な要素から構成されていて、各要素の理論はそれぞれに深く、そのためそれを使いこなすためかなりの訓練が必要となる。「非経験的計算」を習得するためには言葉とは裏腹に「経験」が必要ということである。そのような学習過程はとても簡単な取り扱い説明書で尽くされるものではない。

しかしながら今日の実験家に要請されていることを考へるに、この現状を放置しておくことはできない。ある程度理論的バックグラウンドに興味を覚える人であれば使えるようなプログラムを提供することが理論家に求められている。今回、我々はこのような時代的要請に応えるべく、擬ポテンシャルを使った第一原理計算プログラムパッケージ「Osaka2000」を開発し、一般に公開した。プログラム開発を行う上で念頭をおいたことは、「適当な指導者を想定せず、実験家が独習だけで習得できるプログラムを作ること」である。これは目指すべくして、なかなか到達し難い目標であることは十分承知の上で、挑戦している。

公開して2年以上の歳月を経て、我々としてもかなりユーザーの声を聞いてきてあれやこれや改良点のあることは十分に承知しているつもりである。特にプログラミングスタイルの点ではかなり問題があった。古いFortran77のスタイルでは計算するたびにコンパイルしなければならず、そのためのパラメータをインクルーズファイルに書き込むがこれがかなり初心者に負担になっていた。これを間違うと、コンパイルが通っても実行時に、何のメッセージも残さずコアダンプを引き起こしたりして、何が悪かったのかさっぱりわからないという苦情が寄せられることになる。

また我々開発者にとっても、プログラムのさらなる発展を目指そうとすると、古いFortran77の本源的な限界をつくづく感じるようになった。各プログラムはもともと統合化を意識して書かれていなかったため、それらを統合しようとするとますますプログラムが複雑になり、プログラム開発者にとって非常に読みにくいものとなった。当事者でさえ読むのが困難なものに誰が開発者として加わってくるだろうか？それがプログラム開発の大きな桎梏となることは開発の初期段階からわかっていたことである。しかしかといって初めから作り直そうとした時、それに要するであろう作業量を想像すると容易に決断できるものではなかった。しかしながらそれをいつまでも引き伸ばしていたのでは事の根本的解決にはならない。遂に決断した。2001年春のことである。それから全てのコードを全くクリーンな状態から書き下ろした。始めから書くと決意したこと、それまで様々な根本的制約を持っていたFortran77を捨て、f90の洗練されたスタイルを採用することが出来た。そうして出来たバージョンが「Osaka2002_nano」である。でき上がるまでは本当に苦しかった。一つの改定はまた新たな間違いを引き起こす。開発はこの類いのバグとの戦いの連続であった。f90で書き直して良かったと思えるようになったのはようやくつい最近のことである。

バージョンが進むにつれて、マニュアルを書くことの困難さにも直面している。プログラムが進化するごとに、このプログラムで可能となることやまたその詳細を記述することは変更を受けるし、だいたいどこまで記述するかに関する考え方はその度に変わる。こうした経験より、こうした手引書では動作の基本だけを記述すべきだと確信した。そのためまずプログラムのインストールのような技術的詳細は別にインストレーションマニュアルに記載することにした。また個々の応用の詳細は、応用編としてその都度別に著すことにして、それらをテクニカルレポートシリーズとして準備した。従って更なる応用を目指す読者はそれらを参照していただく。

歴史的ノート

多くのプログラムがそうであるように、このプログラムも一人の人によってのみ作成されたのではない。都合上、このマニュアルには著者一人だけの名前が出ているが、勿論先駆者の仕事があって初めてなされたものである。そこでこのプログラム群の歴史を述べることで、作者のそれらの先駆者達に対する感謝の意に代えたい。（敬称略）

まず、ポテンシャルをつくるatomプログラムは（それ自身がまた長い経験を持っているが）TroullierとMartinsがつくったものを使用している[10]。これはもともとパッケージ「Osaka2000」と独立したものである。

パッケージ「OSAKA2000」のコアとなるプログラムpwmは、Car-Parrinello法にもとづく「第一原理分子動力学シミュレーション」プログラムcpgsを元にして、作者が発展させたものである。元となったプログラムcpgsは1987年から1995年にかけて、当時東北大において吉田博の指導下で、織田望（現電総研）、佐々木泰造（現金属材料技術研）、西松毅（現東北大金研）によって開発された。このコードは当時は半導体中の不純物を研究する目的で使われていて、その目的では既に完成品であった。従って最も困難な部分を

達成した彼らこそこのプログラムの生みの親である。

但し目的がそのようなものであったため、一般的な結晶にはそのまま適用できなかった。1998年より著者が、全ての結晶に対応するように、柳瀬章によって開発された空間群のプログラム「TSPACE」[24]とのドッキングをはかり、それと同時に電子系の収束に Teter-Payne-Allan のアルゴリズム [18]を取り入れたり、原子位置、格子定数に関する最適化に共役勾配法を取り入れるなどほとんどのルーチンを書き換えた。その意味でコードに関しても著者に責任がある。

さらにその周辺のバンド計算、フォノン計算などのプログラムを開発してきたが（その出力の作画に際しては柳瀬章による ayband などを利用している）、この際各プログラムの様式などを統一して一つのパッケージにまとめたものが、「OSAKA2000」である。公開したのは 2000 年秋のことである。

その後それを発展させたものが「Osaka2002_nano」である。

引用に際して

「Osaka2002」を使用して論文を発表される場合、本文か Acknowledgment にパッケージ「Osaka2002」を使用した旨明記していただくようお願いする。「Osaka2002」はプログラム名であるので、一般的な読者がどんな計算をしているのかわからない。それで原理に関する論文の引用が必要である。どこまで引用すべきかはもちろん任意であるが、もし論文が計算を実験データの解釈に使われるくらいの類であるなら、次の 2 点くらいを推奨しておく。

使用したポテンシャルに関しては Troullier-Martins のものを [10]、計算方法に関しては Payne らによるレビュー論文 [19] がある。

バンド図に関しては、図 7.5 のような簡易的なものは構わないが、図 7.6 のような精巧なバンド図は、柳瀬章による ayband で初めて可能になったものであるので、その際、TSPACE[24] 及び同氏による ayband の恩恵にあずかったことも一言述べるべきである。

保証

この種のプログラムの配付ではいつもことながら、結果の保証について述べなければならない。私達はこれが正しい解を与えることに最大限の努力を払っているが、それにもかかわらず最終的な結果に対する社会的な責任は負わないことをご了承いただきたい。

ソースコード

ソースコードの配布は以下のサイトで行っている。

<http://www.cmp.sanken.osaka-u.ac.jp/~koun/osaka.html>

バグレポート及び、マニュアルの誤りは koun@sanken.osaka-u.ac.jp まで御願いする。

第1章 理論

初めに、第一原理に基づく擬ポテンシャル法の概略を説明する。¹ 理論の核心部分は他の教科書で勉強する方がより適切であるが、特に第1.5節から1.7節の事項は、比較的計算上の技術的なことに属し（しかしプログラム pwm を動かすうえで重要である）教科書ではあまり書かれていないので、少し詳細に述べる。

1.1 密度汎関数法

理論上、固体の性質はその系の完全なハミルトニアンの固有状態を解くことによって得られる。非相対論的ハミルトニアンは原子単位系で、

$$H = - \sum_i \nabla^2 + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} + \sum_i V_{\text{ion}}(\mathbf{r}_i) + E_{\text{ion}}(\{\mathbf{R}_n\}) \quad (1.1)$$

と表される²。ここで、 i, j の和は系の全電子について行われる。 \mathbf{R}_n は原子核の位置、 $V_{\text{ion}}(\mathbf{r}_i)$ は原子核によるポテンシャル、 $E_{\text{ion}}(\{\mathbf{R}_n\})$ は原子核間の相互作用エネルギーである。定常状態の全エネルギー、原子間力、電子密度、静電ポテンシャル等のような実際に興味の対象となる多くの性質は、定常状態の波動関数に対する Schrödinger 方程式、

$$H\Psi_0(\{\mathbf{r}_i\}) = E_0\Psi_0(\{\mathbf{r}_i\}) \quad (1.2)$$

を解くことによって得られる。固体の性質の非経験的解析の試みのひとつは、多電子系のハミルトニアン、式(1.1)に対する方程式を、直接解くことである。その際、多数の一電子波動関数の組み合わせになるスレーター行列一つで式(1.2)を展開して解くハートリー・フォック近似が一般的である。これは交換効果のみを考慮したものになるが、それを超える計算には、多数のスレーター行列を用いた展開による配置間相互作用法 (configuration interaction) や量子モンテカルロ法などが使われる。いずれにしても、これらは波動関数を基本に置いて、固体の電子状態を多数の波動関数の組み合わせで表そうとするものである。配置間相互作用法の方法では特にこの波動関数の組み合わせが膨大複雑になるため、計算負荷が大きく、扱える問題のサイズに制限が生じる。

¹ それにしても「第一原理計算」と称するものが如何に多いことか。作者は「第一原理」というからには本来それだけあれば他に何もいらないことを意味すると思うのだが、現実には、擬ポテンシャルあり、LAPW、KKR 法あり、さらに化学の分野ではハートリー・フォックや $X\alpha$ 法なども「第一原理計算」と称している。要するに非経験的電子計算を総称して「第一原理計算」というのだろう。このところは英語でははっきり First-principles calculations と「原理」が複数あることを認めている。もっともそれが、上に意味で方法が多数あるという意味なのか、それとも擬ポテンシャルに限ってもそれがこれから述べるいくつものパートからなるという意味なのだろうか。

² 原子単位では、 $e^2 = 2$ とするが、ここでは e^2 はそのまま残した。原子単位と言っても、Rydberg 単位と、Hartree 単位があるので、混乱を避けるためである。

一方、多体問題に対するこれとは全く異なるアプローチとして、電子密度を第一義的な変量として考える密度汎関数法 (Density Functional Theory) が出現した。セルフコンシスティントな一電子方程式に移し替えられた密度汎関数法の方程式を解くことは、式 (1.2) を解くよりもはるかに簡単で、相関効果を含んでおり、計算可能な系のサイズもはるかに大きい。1980 年頃以来、この方法は、固体や分子の性質を第一原理から計算する主な方法のひとつとしての地位を確立してきた。

密度汎関数理論の元となる論文は Hohenberg & Kohn [1] である。この論文では、外部ポテンシャル中の電子ガスの基底状態エネルギーは電子密度の一意的な汎関数になる、ということが示されている。そのすぐ後に Kohn と Sham [2] は、式 (1.2) の基底状態を解くことは、汎関数 $E_{\text{KS}}(\{\Psi_i\})$ を一電子波動関数 $\Psi_i(r)$ についての規格直交化条件のもとで最小化することと同じであることを示した。

$$E_{\text{KS}}(\{\Psi_i\}) = - \sum_i f_i \int \Psi_i \nabla^2 \Psi_i d^3 r + \int \rho(\mathbf{r}) V_{\text{ion}}(\mathbf{r}) d^3 r + \frac{e^2}{2} \int \frac{\rho(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r d^3 r' + E_{\text{xc}}[\rho(\mathbf{r})] + E_{\text{ion}}(\{\mathbf{R}_n\}) \quad (1.3)$$

式 (1.3)において、 E_{KS} は Kohn-Sham の汎関数で、添字 i の和はすべての一電子軌道について行われ、 f_i は状態 i での占有数、 E_{xc} は相関交換効果の汎関数である。 $\rho(\mathbf{r})$ は電荷密度であり、以下の式で与えられる。

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_i f_i |\Psi_i(\mathbf{r})|^2 \quad (1.4)$$

式 (1.4) の Kohn-Sham 汎関数を最小化する波動関数 $\Psi_i(\mathbf{r})$ は以下の固有値方程式に従う。

$$H_{\text{KS}} \Psi_i = \epsilon_i \Psi_i \quad (1.5)$$

ここで、 H_{KS} は Kohn-Sham のハミルトニアンであり、

$$H_{\text{KS}} = -\nabla^2 + V_{\text{ion}}(\mathbf{r}) + V_{\text{H}}(\mathbf{r}) + V_{\text{xc}}(\mathbf{r}) \quad (1.6)$$

$V_{\text{H}}(\mathbf{r})$ はハートリーポテンシャルで、

$$V_{\text{H}}(\mathbf{r}) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 r' \quad (1.7)$$

と表され、 V_{xc} は交換相関ポテンシャルである。

$$V_{\text{xc}}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_{\text{xc}}[\rho]}{\delta \rho(\mathbf{r})} \quad (1.8)$$

ϵ_i, Ψ_i はそれぞれ、Kohn-Sham 方程式の固有値、波動関数を表す。

式 (1.5) で計算される波動関数は、ハートリーポテンシャルや交換相関ポテンシャルをつくる電荷密度と同じ電荷密度を作り出さなければならない、という意味で、Kohn-Sham 方程式はセルフコンシステントである。

式 (1.6) は一見、それまでの一電子波動関数に関する波動方程式と代わり映えしないように見えるが、そこに込められている思想が違うのである。ハートリー・フォックの場合

は、波動関数が第一義的量で、密度はそれから導かれる二次的量とみなされる。一方密度汎関数理論では、密度こそ第一義量で、波動関数の方は、密度を出すための一種の方便で、同じ密度を与えるものならどのように取ってもよい。

密度汎関数理論、及び次節で述べられる局所密度近似についてはたくさんの良いレビューがある（文献 [3, 4, 5]）。

1.2 局所密度近似

多電子問題を一電子問題に置き換えることによる密度汎関数法の数学的単純化は、一方では未知の電荷密度の汎関数、すなわち交換相関エネルギーを導入しなければならないという厄介さを合わせ持つ。幸い、 E_{xc} についての簡単な近似が存在する。最も一般的な E_{xc} の形は局所密度近似 (The Local Density Approximation, LDA) を使うことで得られる。すなわち、知られている自由電子ガスに対する交換相関エネルギーを利用する。この近似では、系の空間の各点での交換相関エネルギーは、その電荷密度での一様な自由電子ガスの交換相関エネルギーに等しい、とされる。

$$E_{xc} = \int \epsilon_{xc}(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} \quad (1.9)$$

交換相関ポテンシャル $V_{xc}(\mathbf{r})$ は、

$$V_{xc}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_{xc}}{\delta \rho(\mathbf{r})} = \frac{\partial \{\rho(\mathbf{r}) \epsilon_{xc}(\mathbf{r})\}}{\partial \rho(\mathbf{r})} \quad (1.10)$$

そして、 $\epsilon_{xc}(\mathbf{r})$ は

$$\epsilon_{xc}(\mathbf{r}) = \epsilon_{xc}^{\text{hom}}[\rho(\mathbf{r})] \quad (1.11)$$

で、 $\epsilon_{xc}^{\text{hom}}$ は一様な電子ガスにおける交換相関エネルギーである。局所密度近似の範囲内で、交換相関ポテンシャルは電荷密度の局所的な関数となる。この近似の有効性と正確さは、固体や分子などの系での多くの計算結果が証明してくれている。ここでは、密度の関数としての交換相関エネルギーは量子モンテカルロ法 [6] から得られる結果をパラメータ化したものを用いている [7]。

1.3 擬ポテンシャル近似

局所密度近似に続く第二の近似は擬ポテンシャルの使用 (The Pseudopotential Approximation) である。後で述べられるが、固体の波動関数はここでは平面波で展開される。平面波展開は局在化された状態を表すのに非常に不経済な表現である。コアの部分で激しく振動している内殻状態を記述するのには適切ではない。幸い、物質の多くの物理的、化学的性質は主に広がった価電子状態により決まり、原子核付近に局在している内殻状態には鈍感である。そこで物質の結合状態などを記述する上で、価電子状態だけで近似し、それゆえポテンシャルとしては、急激に変化する元のポテンシャルに比べて遙に緩やかな変化を持つポテンシャルで価電子状態をシミュレーションしようという考えが生まれた。これ

が擬ポテンシャル法である [8]。それに伴う価電子状態をシミュレートする波動関数は擬波動関数と呼ばれる。

擬ポテンシャルは、化学的に重要である原子の外側領域において全電子原子の電子散乱特性にできるだけ似せて作られる。このように作られた良い擬波動関数は「transferable である」と言われる。一般的に、擬ポテンシャルはそれぞれの角運動量成分で異なる散乱ポテンシャルを持ち、かつ非局所的である。すなわち擬ポテンシャルはオペレータとして、

$$\hat{V}_{NL} = \sum_l |lm\rangle V_l \langle lm| \quad (1.12)$$

ここで $|lm\rangle$ は球面調和関数で、 l, m はそれぞれ角運動量、方位角運動量である。全電子ポテンシャルは局所ポテンシャルである。真の波動関数と擬波動関数はコア半径の外側で一致するため、擬ポテンシャルの非局所性は原子コア領域内に限られる。実際には、軽い原子では擬ポテンシャルに $l = 2$ 以上の非局所項を加えることは必ずしも必要ではない。

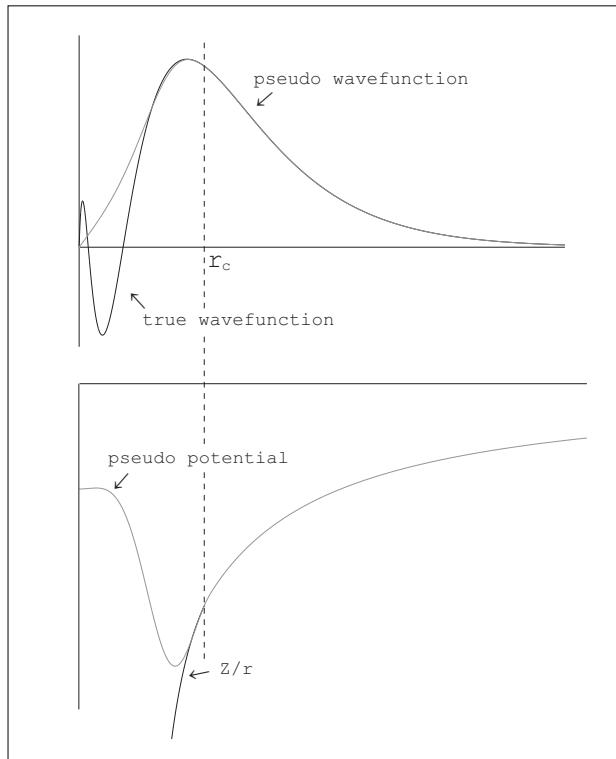


図 1.1: 擬ポテンシャルの概略 振動する真の波動関数（実線）は節のない擬波動関数（破線）に置き換えられる。全電子、擬原子それぞれの波動関数、およびポテンシャルはコア半径 r_c より外側の化学的に重要な領域で一致する。

擬ポテンシャルを生成するため、過去多くの方法が編み出されてきたが [8]、重要な進歩は Hamann らによる波動関数の「ノルム保存」という概念でもたらされた [9]。これにより擬ポテンシャル法が固体の問題を解く方法として、今日では最も一般的に用いられるようになったと言って過言ではないだろう。このアイデアでは、節のない擬波動関数はコア半径 r_c より外では真の波動関数と一致するように取られる。その他いくつかの条件を加

えて、擬ポテンシャルが作られるのであるが、その様子を図 1.1 に示す。滑らかな擬ポテンシャルが得られていることがわかる。

ここでのプログラムでは、擬ポテンシャルとして、「ノルム保存」型で、より計算効率を改良した Troullier-Martins 型を採用している [10]。

式 (1.12) で定義された擬ポテンシャルは semi-local と呼ばれることがある。位置の角度成分に関しては非局所的であるが、動径方向成分に関しては局所的であるからである。それに対して、Kleinman、Bylander は動径方向成分も非局所的に扱う full-nonlocal 型を提唱している [11]。それによると、

$$V_{\text{ion}} = V_L + \sum_{lm} \frac{|\Phi_{lm}^0 \Delta V_l\rangle \langle \Delta V_l \Phi_{lm}^0|}{\langle \Phi_{lm}^0 | \Delta V_l | \Phi_{lm}^0 \rangle} \quad (1.13)$$

ここに Φ_{lm}^0 は擬ポテンシャルを作るときの原子の擬波動関数で、

$$\Delta V_l = V_{l,\text{NL}} - V_L \quad (1.14)$$

となる。これにより、非局所ポテンシャルの計算が早くなるだけでなく、 V_L の任意性を利用すると、非局所ポテンシャル行列と波動関数の積の計算も加速される。

1.4 平面波展開

マクロな結晶では $\sim 10^{23}$ 個の原子がある。このようなほとんど無限次元とも言える自由度を持つ系に対してまともに KS 方程式を解くことは適切でない。そこで編み出されたのが、Born-von Karman の境界条件という人為的だが非常に便利な数学的道具である。それに付随してもう一つ重要な数学的定理が Bloch の定理である [13]。

平面波法に限らず、全ての固体の計算法はこの周期境界条件の恩恵にあずかっている。格子欠陥を持つ結晶や表面、さらにアモルファスなど周期性のない固体の場合、もちろん基本単位格子というものは存在しないが、人為的な巨大な単位格子を取るスーパーセル法によって計算可能となる。

結晶の数学的モデルは、実空間での三つの基本並進ベクトルで作られる。すなわち、

$$\mathbf{t} = n_1 \mathbf{R}_1 + n_2 \mathbf{R}_2 + n_3 \mathbf{R}_3 \quad (1.15)$$

で与えられる。 n_1, n_2, n_3 は任意整数である。このように基本並進ベクトルで作られる格子をブラバー格子という。結晶はブラバー格子と単位構造 (basis) の組み合わせで表現される。

この格子に対して、逆格子空間が定義される。逆格子空間の基本並進ベクトルは

$$\mathbf{R}_i \cdot \mathbf{G}_j = 2\pi \delta_{ij} \quad (1.16)$$

を満たすように取られる。 i, j はそれぞれ 1 から 3 をとる。 \mathbf{G}_1 は以下のようになる。

$$\mathbf{G}_1 = 2\pi \frac{\mathbf{R}_2 \times \mathbf{R}_3}{\mathbf{R}_1 \cdot (\mathbf{R}_2 \times \mathbf{R}_3)} \quad (1.17)$$

$\mathbf{G}_2, \mathbf{G}_3$ も同様の形で与えられる。逆格子空間での格子ベクトル（逆格子ベクトル）は次式のように与えられ、ここで n_1, n_2, n_3 は任意整数である。

$$\mathbf{G} = n_1 \mathbf{G}_1 + n_2 \mathbf{G}_2 + n_3 \mathbf{G}_3 \quad (1.18)$$

逆格子ベクトルは任意の周期関数のフーリエ展開に使われる。 $f(\mathbf{r})$ がプラベー格子ベクトル $\{\mathbf{R}\}$ について滑らかな関数であるとき、

$$f(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} A_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} \quad (1.19)$$

となる。 $A_{\mathbf{G}}$ は逆格子ベクトル \mathbf{G} に関するフーリエ展開係数である。

周期境界条件の下では電子状態は波数ベクトル \mathbf{k} とバンド指数 n を用いて指定される。そして波動関数は基本単位格子の周期関数 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ に $\exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})$ を掛けた形をしている。すなわち、

$$\Psi_{\mathbf{k}n}(\mathbf{r}) = \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}) u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (1.20)$$

と表される。³ これがプロッホの定理の主張するところであるが、このおかげで解くべき問題の自由度がほとんど無限大から、単位格子内の原子数のオーダーくらいに減少できるのである。現実の多種のバンド計算は（セル法を除いて）、式（1.20）のプロッホ関数を表す基底関数の取り方が違うと見ることができる。

式（1.20）の中で、 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ は格子の周期関数であるから、式（1.19）に従って逆格子ベクトルで展開できる。つまり、

$$\Psi_{\mathbf{k}n}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} c_{\mathbf{k}+\mathbf{G}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}} \quad (1.21)$$

従って平面波法はそのまでプロッホの条件を満たし、かつ空間的に片寄りのない電荷密度をもたらせるので、プロッホ関数の基底関数としては自然である。そのため全エネルギーなどの物理量の表式が一筋で書けるという利点がある。最大の欠点は収束が悪いということである。（現実的なポテンシャルで如何に平面波展開が効率の悪いものであるかの例は、例えば文献[8]の第2章で挙げられている。）

平面波で展開された、全エネルギーの表式（1.3）は

$$\begin{aligned} E_{\text{tot}} = & \sum_{i, \mathbf{G}} |c_{\mathbf{k}_i + \mathbf{G}}|^2 (\mathbf{k}_i + \mathbf{G})^2 + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{G}} \rho^*(\mathbf{G}) V_{\text{H}}(\mathbf{G}) + \frac{3}{4} \sum_{\mathbf{G}} \rho^*(\mathbf{G}) V_{\text{xc}}(\mathbf{G}) \\ & + \sum_{\mathbf{G}} \rho^*(\mathbf{G}) S^*(\mathbf{G}) V_{\text{L}}(\mathbf{G}) + \sum_{i, l, \mathbf{G}, \mathbf{G}'} c_{\mathbf{k}_i + \mathbf{G}}^* c_{\mathbf{k}_i + \mathbf{G}'} \\ & \times S(\mathbf{G}' - \mathbf{G}) V_l^{\text{NL}}(\mathbf{k}_i + \mathbf{G}, \mathbf{k}_i + \mathbf{G}') + E_{\text{ion}}(\{\mathbf{R}_n\}) \end{aligned} \quad (1.22)$$

となる[14]。 $S(\mathbf{G})$ は構造因子である。さらに後に述べる Hellmann-Feynman 力やストレスなどもこの平面波展開により、評価しやすい形になる。

³ 指数部を $\exp(-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})$ と取ることもできる。このプログラムでは TSPACE を利用するため、式（1.20）のように指数部は正と取り決めている。

式(1.22)の最後の項は、イオン-イオン間直接クーロン相互作用で、Ewald和と呼ばれているものである。それは

$$E_{\text{ion}}(\{\mathbf{R}_n\}) = \frac{e^2}{2} \sum_{\kappa, \kappa'} Z_\kappa Z_{\kappa'} \gamma_{\kappa, \kappa'} \quad (1.23)$$

で、 κ は単位格子中の原子のインデックスで、 $\gamma_{\kappa, \kappa'}$ は

$$\begin{aligned} \gamma_{\kappa, \kappa'} = & \sum_{l'}' \frac{\operatorname{erfc}(\eta |\mathbf{R}(\frac{l'}{\kappa'} \kappa)|)}{\mathbf{R}(\frac{l'}{\kappa'} \kappa)} \\ & + \frac{4\pi}{\Omega_c} \sum_{\mathbf{G} \neq 0}' \frac{1}{G^2} \exp \left[- \left(\frac{G}{2\eta} \right)^2 \right] \exp [i\mathbf{G} \cdot (\mathbf{x}_\kappa - \mathbf{x}_{\kappa'})] \\ & - \frac{2\eta}{\sqrt{\pi}} \delta_{\kappa, \kappa'} - \frac{\pi}{2\eta^2 \Omega_c} \end{aligned} \quad (1.23a)$$

で与えられる。プライムのついている和は同じ原子を除くことを意味している。 η は式(1.23a)で実空間にわたる和と、逆格子空間にわたる和での収束が良くなるように取る(例えば文献[15] p. 385)。

1.5 平面波のカットオフ

式(1.21)は無限の逆格子ベクトル \mathbf{G} についての和である。もちろん現実にはどこかで切らなければならない。実際の計算では、あるカットオフエネルギー E_{cut} (原子単位)に對して、それよりも小さいエネルギーの平面波のみが選ばれる。すなわち

$$|\mathbf{k} + \mathbf{G}|^2 < E_{\text{cut}} \quad (1.24)$$

これは、逆格子空間の球で定義され、球の半径(カットオフ半径 k_c)よりも小さな波数ベクトルの平面波が全て含まれることを意味する。図1.2参照。このときの平面波カットオフ半径は

$$E_{\text{cut}} = k_c^2 \quad (1.25)$$

で与えられる。

カットオフ半径 k_c 内の平面波の数 N_{pw} は

$$N_{\text{pw}} = \frac{\frac{4\pi}{3} k_c^3}{\frac{(2\pi)^3}{\Omega_c}} \quad (1.26)$$

と見積もれる。ここに Ω_c は基本単位格子の体積である。

計算の収束に必要とされる平面波の数 N_{pw} は基本単位格子内の原子の種類に依存する。周期表で一列目や、一列目の遷移金属を含む系は一般的に、二列目や三列目だけからなる系よりも大きな平面波のカットオフエネルギーを必要とする。

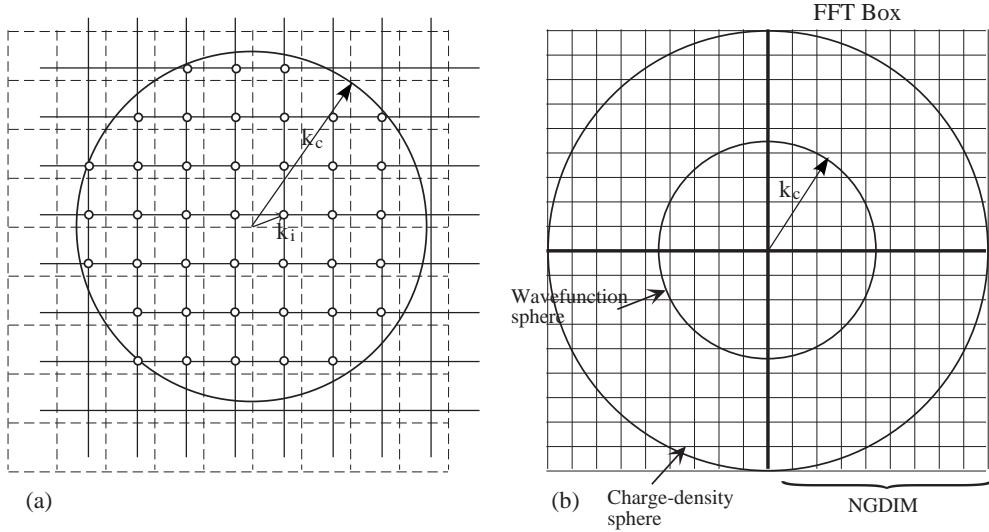


図 1.2: a) 点 k_i に対する平面波の取り方。b) 平面波球、電荷密度球、FFT の矩形の関係。

1.6 k 空間上の総和

全エネルギーや力の計算では、固体の Kohn-Sham 波動関数に作用するオペレータ \hat{Q} についての平均を知ることがしばしば必要とされる。プロッホの定理によれば、全波動関数に対する平均は、

$$Q = \frac{\Omega_c}{(2\pi)^3} \int_{BZ} Q_{\mathbf{k}} d^3k \quad (1.27)$$

ここで $Q_{\mathbf{k}}$ は、

$$Q_{\mathbf{k}} = \langle \Psi_{kn} | \hat{Q} | \Psi_{kn} \rangle \quad (1.28)$$

と表される。例えば、 \hat{Q} が Kohn-Sham ハミルトニアンである場合、 Q_{kn} は Kohn-Sham の固有値で、 Q はバンド n でのバンドエネルギーの平均値になる。

数値計算では式 (1.27) の積分はもちろん有限メッシュ上の和に置き換えられるが、通常はそれに膨大な時間がかかる。しかしながら、 k 空間のメッシュ点である特別の点のセットを選ぶと、少数の点で多数のサンプリングをしたのと同じ精度を得ることができる。これが特別点サンプリング法と呼ばれるものである。

本プログラムでは標準的に、特別点サンプリング法として Monkhorst と Pack に依るもの [16] を用いている。 k 点のメッシュは N_1, N_2, N_3 の三つの整数を用いてつくられる。これらの整数は基本単位逆格子での k 点の密度を決定する。メッシュの一般点は次式で与えられる。

$$\mathbf{k}_{rst} = u_{1r}\mathbf{G}_1 + u_{2s}\mathbf{G}_2 + u_{3t}\mathbf{G}_3 \quad (1.29)$$

$$u_{ip} = \frac{2p - N_i - 1}{2N_i} \quad (1.30)$$

p は 1 から N_i までをとる。このメッシュはブリルアン・ゾーンでの $N_1 N_2 N_3$ 個の \mathbf{k} 点を作る。したがって、式 (1.27) の積分は不連続な \mathbf{k} 点の和に置き換えられる。

$$Q = \frac{1}{N_1 N_2 N_3} \sum_{rst} Q_{\mathbf{k}_{rst}} \quad (1.31)$$

実際には、いくつかの \mathbf{k} 点は結晶の時間反転操作あるいは点群操作によって互いに対称になる。もし複数の \mathbf{k} 点が対称ならば、Kohn-Sham 方程式は対称な点のうちの一点でのみ解けばよく、残りは対称操作から導くことができる。この対称性のおかげで計算時間は大幅に削減される。プログラム中では自動的に結晶の空間群についての情報を用いて、計算に使う \mathbf{k} 点の数を可能な限り減らしている。

\mathbf{k} 点の特別点サンプリングがどれくらい良いものであるか、その質は実空間のカットオフベクトルの中で見積もられる。 $Q_{\mathbf{k}}$ のような逆格子空間の周期関数は実空間のフーリエ級数表現を持つ。

$$Q_{\mathbf{k}} = \sum_{\mathbf{R}} B_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \quad (1.32)$$

ここで $B_{\mathbf{R}}$ は展開係数である。ゾーン全体にわたる $Q_{\mathbf{k}n}$ の平均は B_0 である。通常はフーリエ係数 $B_{\mathbf{R}}$ は $|\mathbf{R}|$ の増加とともに急激に減少する。(1.32) を (1.31) に代入すると、

$$Q = B_0 + \sum_{\mathbf{R} \neq 0} B_{\mathbf{R}} \phi_{\mathbf{R}} \quad (1.33)$$

$\phi_{\mathbf{R}}$ は

$$\phi_{\mathbf{R}} = \frac{1}{N_1 N_2 N_3} \sum_{rst} e^{i\mathbf{k}_{rst}\cdot\mathbf{R}} \quad (1.33a)$$

と書け、サンプリング \mathbf{k}_i のセット $\{rst\}$ に対する $\mathbf{R} \neq 0$ の和は Q の誤差とみなせる。 \mathbf{R} をその大きさ $|\mathbf{R}|$ で分類すると、 \mathbf{R} の殻構造ができるが、その殻 i ごとに式 (1.33) を評価し、

$$\sum_{\mathbf{R}}^{\text{ith shell}} \phi_{\mathbf{R}} \quad (1.33b)$$

ができるだけ遠くの殻まで 0 となれば、そのサンプリングの質は良いということになる。

1.7 Kohn-Sham 汎関数における共役勾配最小法

次に、式 (1.3) を解かなければならない。従来は式 (1.5) を対角化し、出力電荷密度と、入力電荷密度が同じになるまで繰り返し、セルフコンシステント解を得ていた。この方法だと、出力電荷密度と入力電荷密度を混ぜ合わせる割合が微妙で、特に扱う形のサイズが大きくなると、収束しなくなることがしばしばあった。Kohn-Sham 汎関数における共役勾配最小法はこの難点を解決した優れた方法であるので、ここで詳しく説明する。

これまでの議論より、系の基底状態を求めるには Kohn-Sham のエネルギー汎関数 $E_{\text{KS}}(\{c_{\mathbf{k}+\mathbf{G},n}\})$ 関数を占有された波動関数の平面波展開係数 $\{c_{\mathbf{k}+\mathbf{G},n}\}$ について最小化させる問題を考えることができる。

多変量の関数 $f(\mathbf{x})$ の極小値を求める数学的技法として、共役勾配法 (Conjugate-Gradient Method) が有効であることが知られている [17]。これは特に $f(\mathbf{x})$ が

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{x} + c \quad (1.34)$$

と線形近似でき、かつ \mathbf{A} が正値行列 (positive-definitive) のとき必ず最小値を見いだすのに成功する（少なくとも原理的には）。

関数 $f(\mathbf{x})$ の点 \mathbf{x} での勾配は

$$-\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{b} - \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} \quad (1.35)$$

であるので、 $f(\mathbf{x})$ が極小値をとるときの \mathbf{x} は線形方程式

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b} \quad (1.36)$$

を満たす。

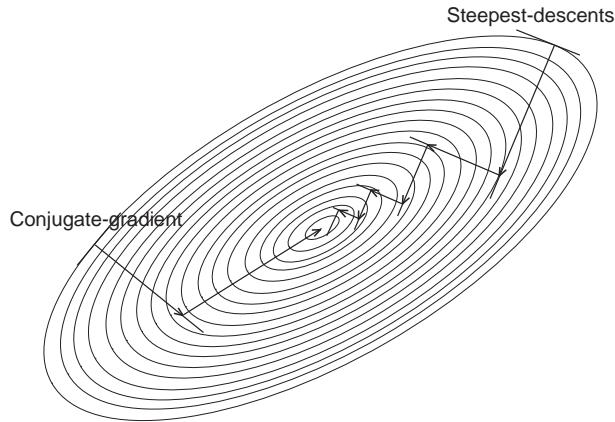


図 1.3: 最急勾配法と共役勾配法の比較。

この極小化問題に対する原始的な解法は、まず試行点 \mathbf{x}_0 で式の (1.35) を評価し勾配を求め、次にその勾配の方向に一次元最小化を行う。その線上の最小点 \mathbf{x}_1 が定まつたら、次にその点で再び勾配を求め、またその方向に最小化する。という過程を繰り返すことである。これが最急勾配法 (steepest descent method) である。これは直感的に分かりやすい方法であるが、実は図 1.3 に示されるようにポテンシャルの谷間では何度もステップを繰り返すことになり非常に効率が悪い。

この最急勾配法の欠点を良く解析すると、同じ探索方向を何度も繰り返している点が問題である。過去探索した方向は二度と繰り返さない方法がある。それが共役勾配法である。

それによると、 i 番目のステップで、探索方向 \mathbf{h}_i 上で最小点 \mathbf{x}_i が見つかったとする。次にこの点で勾配 \mathbf{g}_i を求める。 \mathbf{x}_i を始点として、新しい $i+1$ 番目のステップ探索方向 \mathbf{h}_{i+1} は

$$\mathbf{h}_{i+1} = \mathbf{g}_i + \gamma_i \mathbf{h}_i \quad (1.37)$$

と前の探索方向と、現在の勾配との混ぜ合わせとなる。混ぜ合わせる割合は

$$\gamma_i = \frac{\mathbf{g}_{i+1} \cdot \mathbf{g}_{i+1}}{\mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_i} \quad (1.38)$$

で決まる。これが共役勾配と言われるものであり、この方向で探索すると、図 1.3 に示されるように大変効率良く極小点が見つかる。

またこの方法では、行列 \mathbf{A} の完全な形をする必要はなく、 \mathbf{A} は常にベクトル \mathbf{x} との積の形で現れているので、 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x}$ の部分がうまく評価できると勾配の計算が速くなるだけでなくメモリーの節約にもなる。

密度汎関数理論により、エネルギー汎関数は真の基底状態電荷密度の時最小値を取り、それ以外の密度分布の時は必ず関数値は大きくなることを保証しているので、上の共役勾配法は Kohn-Sham エネルギー汎関数を最小化する方法としてうってつけである。しかしながら、波動関数は規格化されていてその絶対値に関する拘束がつくこと、並びに同じ k 点の波動関数同士が直交化していなければならないという拘束がつくため、事情が複雑となる。こうした困難を克服し、より効果的な共役勾配法が Teter, Payne, Allan(TPA) によって提案された [18, 19]。本プログラムはこの TPA のアルゴリズムを踏襲している。

このアルゴリズムでは、各 k 点ごとに、占有されたバンドに対して、直交規格化された初期の波動関数のセットを用意する。ここでは乱数から作られる。Kohn-Sham エネルギー汎関数はバンドごとに最小化過程を繰り返される。各 k 点の一つのバンドの波動関数の平面波展開係数に関して共役勾配最小化が適用される。その間他のバンドは固定される。一つのバンドに対して数回の共役勾配過程がなされ、そして次のバンド、次の k 点に移り、全体をさらに何回か繰り返す。

以下一つのバンド n に対する共役勾配過程を図 1.4 を参照しながら、もう少し詳しく説明する。

1. バンド n の波動関数 $\{c_{k+G,n}\} = \mathbf{C}_n$ に関する Kohn-Sham のエネルギー汎関数 E_{KS} の偏微分が、式 (1.6) の一電子に関するハミルトニアン H を与える。 m 番目のステップでのバンド n の波動関数 \mathbf{C}_n^m に関する期待値は

$$\lambda_n^m = \mathbf{C}_n^{m*} \cdot \mathbf{H} \cdot \mathbf{C}_n^m \quad (1.39)$$

で、これによりこのハミルトニアンに対する残留誤差 \mathbf{R}^m 、すなわち最急勾配の方向が定まる。

$$\mathbf{R}^m = -(\mathbf{H} \cdot \mathbf{C}_n^m - \lambda_n^m \mathbf{C}_n^m) \quad (1.40)$$

この \mathbf{R}^m の絶対値自乗をもって波動関数の残留誤差 ξ^m と称している。

2. この残留誤差ベクトル \mathbf{R}^m が、 k 点内の他のバンドと直交するように修正する。すなわち、

$$\mathbf{R}'^m = \mathbf{R}^m - \sum_{r \neq n} (\mathbf{C}_r \cdot \mathbf{R}^m) \mathbf{C}_r \quad (1.41)$$

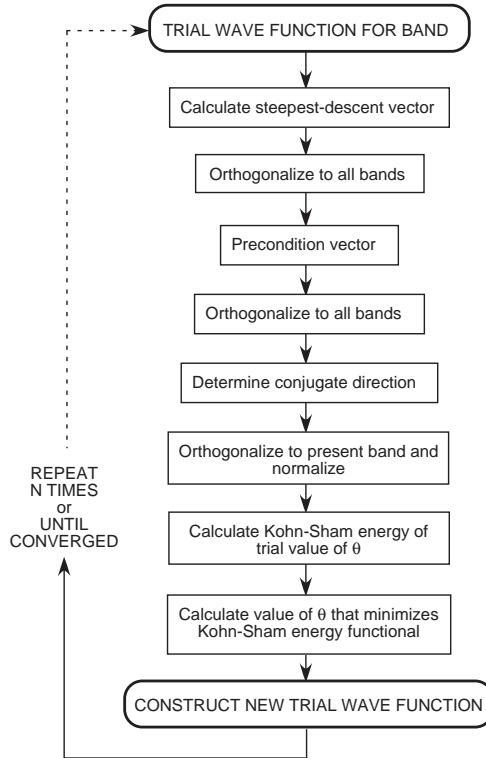


図 1.4: 直接最小化法のフローダイアグラム。

3. 収束を速めるため、この修正された残留誤差ベクトル \mathbf{R}''^m に対して前処理 (preconditioning) をする。すなわち適当な行列 \mathbf{K} を掛け、 \mathbf{R}''^m の各成分の大きさをおおまかに揃える。

$$\mathbf{R}''^m = \mathbf{R}''^m \cdot \mathbf{K} \quad (1.42)$$

行列 \mathbf{K} の取り方として、対角行列を持ってきて、だいたい \mathbf{R}^m の逆数になるようにすればよい。

4. \mathbf{R}''^m を改めて、自分自身を含む全てのバンドに対して直交するよう修正する。

$$\mathbf{G}^m = \mathbf{R}''^m - \sum_{r \neq n} (\mathbf{C}_r \cdot \mathbf{R}''^m) \mathbf{C}_r - (\mathbf{C}_n^m \cdot \mathbf{R}''^m) \mathbf{C}_n^m \quad (1.43)$$

5. この \mathbf{G}^m を使って、共役勾配を求める。つまり

$$\mathbf{F}^m = \mathbf{G}^m - \gamma^m \mathbf{F}^{m-1} \quad (1.44)$$

が求める共役勾配である。混ざりの係数 γ^m は式 (1.38) に従って \mathbf{G}^m から求めることができる。初期条件として $\gamma^0 = 0$ と取れば良い。

6. 再び \mathbf{F}^m を現在のバンドと直交化させかつ規格化する。それを \mathbf{D}^m とする。こうすることで、 \mathbf{D}^m 方向の一次元最小化探索が、波動関数

$$\mathbf{C}_n^{m+1} = \mathbf{C}_n^m \cos \theta + \mathbf{D}^m \sin \theta \quad (1.45)$$

に対する θ を変数としたときの全エネルギー $E_{\text{KS}}(\theta)$ 最小化問題に帰する。

7. $E_{\text{KS}}(\theta)$ は密度の関数で、密度は波動関数の自乗で与えられるので、もし考えている変数範囲で、 $E_{\text{KS}}(\theta)$ が密度に線形で近似できるならば、良い精度で、

$$E_{\text{KS}}(\theta) = \text{const} + A \cos 2\theta + B \sin 2\theta \quad (1.46)$$

とできるであろう。

式 (1.46) には 3 つの未知数が含まれているので、3 つの方程式が必要である。既に $\theta = 0$ での値 $E_{\text{KS}}(0)$ は評価してあるし、またその微分も容易に得られる。すなわち、

$$\left. \frac{\partial E_{\text{KS}}}{\partial \theta} \right|_{\theta=0} = 2f_n \text{Re}(\mathbf{D}^{m*} \cdot \mathbf{H} \cdot \mathbf{C}_n^m) \quad (1.47)$$

である。 $\mathbf{H} \cdot \mathbf{C}_n^m$ はすでに評価されているので、式 (1.47) は単にベクトルの内積を取ることで得られる。式 (1.46) の B は式 (1.47) の半分の値である。

8. 残りの一つは、 $E_{\text{KS}}(\theta)$ を 0 でない他の点 θ_1 で評価するか、あるいは $\theta = 0$ での $E_{\text{KS}}(\theta)$ の 2 次微分を求めて得れる。ここでは後者を使っている。これにより、 A は $A = (1/4)\partial^2 E_{\text{KS}}/\partial\theta^2$ で与えられる。これらより、式 (1.46) を最小にする θ_{\min} は

$$\theta_{\min} = -\frac{1}{2} \tan^{-1} \left[-\frac{\frac{\partial E_{\text{KS}}}{\partial \theta} \Big|_{\theta=0}}{\frac{1}{2} \frac{\partial^2 E_{\text{KS}}}{\partial \theta^2} \Big|_{\theta=0}} \right] \quad (1.48)$$

で決定される。

1.8 高速フーリエ変換

共役勾配法における重要な計算部分は Kohn-Sham ハミルトニアンを波動関数にオペレートするときである。プログラムではこのステップは高速フーリエ変換 (FFT) を使って実行される。そこでは、運動エネルギーと局所ポテンシャルが逆空間、実空間のそれぞれで対角化されている、という事実を利用している。一つのバンドでの基底関数の総数が N_{pw} であると、式 (1.22) の形から、全係数において逆格子空間での運動エネルギーを計算するには $\mathcal{O}(N_{\text{pw}})$ の演算を要求することがわかる。

一方、逆格子空間でのローカルポテンシャルを用いた計算は $\mathcal{O}(N_{\text{pw}}^2)$ の演算を必要とする。なぜならばローカルポテンシャルは完全な行列だからである。ここではローカルポテンシャルの演算を書き換えることによってこの演算を加速化する。

$$\sum_{G'} V_L(\mathbf{G} - \mathbf{G}') c_{\mathbf{k}+\mathbf{G}',n} = \frac{1}{\Omega_c} \int e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} V_L(\mathbf{r}) \sum_{\mathbf{G}'} e^{i\mathbf{G}' \cdot \mathbf{r}} c_{\mathbf{k}+\mathbf{G}',n} d^3 \mathbf{r} \quad (1.49)$$

式 (1.20、1.21) より、 \mathbf{G}' についての足し合わせは

$$u_{\mathbf{k}n}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}'} e^{i\mathbf{G}' \cdot \mathbf{r}} c_{\mathbf{k}+\mathbf{G}',n} \quad (1.50)$$

と実空間の波動関数（の格子周期部分）となる。従って、式 (1.49) の評価は、

1. 逆格子空間で展開された波動関数 $c_{\mathbf{k}+\mathbf{G},n}$ を実空間表現 $u_{\mathbf{k}n}(\mathbf{r})$ に変換する。
2. 実空間で $u_{\mathbf{k}n}(\mathbf{r})$ と $V_L(\mathbf{r})$ の積をとる。
3. その結果を逆格子空間上の表現に戻す。

こうして式(1.49)の評価は、3段階の演算になり、かえって大変になったようにも見えるが実は逆である。2の演算は実空間の格子点での対角和であるからおよそ $\mathcal{O}(N_{pw})$ の演算で済み、1と3はFFTを用いると $\mathcal{O}(N_{pw} \log(N_{pw}))$ の演算で済み、結果として全体でも $\mathcal{O}(N_{pw} \log(N_{pw}))$ のオーダーの演算で済むことになる。CarとParrinelloにより擬ポテンシャル計算に対するこの技法が普及した[20]。

FFTを行う領域について述べておく必要がある。波動関数は、図1.2(a)のように半径 k_c の球内の N_{pw} 格子点で展開される。ところが電荷密度は波動関数の自乗で与えられるので、波動関数の変化を密度変化(そしてポテンシャル)に忠実に反映するにはその2倍の半径の逆格子点が必要である。同図(b)参照。その結果、FFTを行う矩形領域は一边の長さが $4k_c$ となる。逆格子空間におけるFFTメッシュと、実空間におけるそれとはだいたい同じであるから、結局式(1.26)より、実空間のFFTメッシュ点の数 N_{FFT} は

$$N_{FFT} \cong 16N_{pw} \quad (1.51)$$

となる。

1.9 Hellmann-Feynman 力とストレス

Hellmann-Feynmanの定理のおかげで原子間力とストレスを効果的に計算することができる。

結晶における、ある原子における力は、原子位置 \mathbf{R}_I に関する全エネルギーの微分で与えられる。

$$\mathbf{F}_I = -\frac{dE_{tot}}{d\mathbf{R}_I} = -\frac{d}{d\mathbf{R}_I}\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle \quad (1.52)$$

この定義によると、数値的に原子間力を求めるには、全エネルギーを原子位置に関して何点か(最低2点)で評価しなければならないことになる。

ところが、Hellmann-Feynmanの定理によると、式(1.52)は、

$$\mathbf{F}_I = -\langle\Psi|\frac{\partial V(\{\mathbf{R}\})}{\partial\mathbf{R}_I}|\Psi\rangle \quad (1.53)$$

と変形できる(引用としては当然HellmannとFeynman両方をするべきであるが、作者はFeynman[21]のものしか持っていないのでHellmannさんごめんなさい)。一見、式(1.52)と(1.53)はちょっとした違いにしか見えないかもしれないが、実は大変な違いがある。式(1.52)の中で、波動関数 Ψ は原子位置 \mathbf{R} に陰に依存する。原子位置が変わると、 Ψ は改めて評価し直さなければならない。それに対し、式(1.53)の中では、波動関数 Ψ は平衡位置のものである。従って平衡位置での Schrödinger 方程式を一回解けば十分である。一般

にはポテンシャルの位置微分を取り空間積分するほうが、別の位置における Schrödinger 方程式を改めて解くよりはるかに簡単である。

力とストレスは特に平面波を用いた擬ポテンシャル近似で効果的に評価できる。基底関数が空間に固定されているからである。その平面波展開の具体的表式は、力は [14] に、ストレスは [22, 23] に与えられている。(文献 [23] の式 (2) に現れている運動エネルギーの前の符号は – のタイプミスである。)

力の情報はエネルギーを最小にする単位格子中の原子位置決定に使われる。同じようにストレスは格子定数の最適化に使われる。

系の全エネルギーの計算よりも力やストレスのほうが収束が遅いことに注意すべきだ。全エネルギーはセルフコンシステント解に到達したとき最小値になり、その時波動関数の変位に対して変分量となる。すなわち、1次の波動関数の変位に対して、全エネルギー変化は2次となる。この意味では力やストレスは変分量ではなく、波動関数の変位の1次として変化する。

第2章 ロードマップ

2.1 概略

擬ポテンシャル平面波法電子状態計算プログラム「Osaka2002」は多くのプログラムの集合体である。それらの間の関係は次のようにになっている。

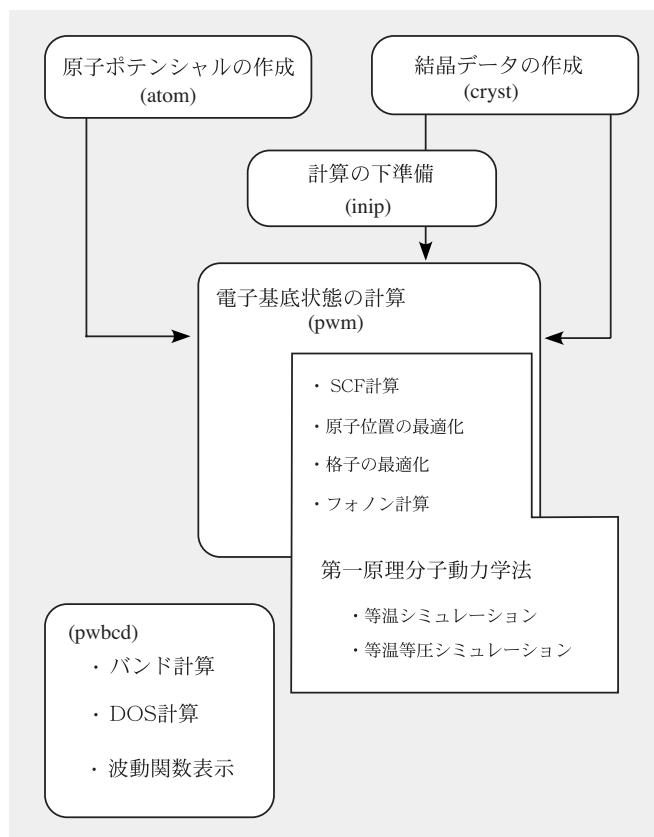


図 2.1: パッケージ Osaka2002 で行う計算

簡単に言って、atom で計算に必要な原子種のポテンシャルを作り、cryst で結晶を作り、pwm でセルフコンシステント (SCF) 計算を行う。inip は pwm の計算の下準備をする。

パッケージ「Osaka2002」の中核は pwm で、この中 SCF 計算が完成すればそれからさまざまな発展が出来る。それらの中に格子構造の最適化、フォノン計算、さらに第一原理分子動力学シミュレーションなどがあるが、それらは pwm の中に一部として実行される。旧バージョンの第一原理分子動力学シミュレーション mds はこの pwm の中にいくつかの

ジョブの一つとして含まれるようになった。

電子状態の詳細スペクトルが必要であればバンド計算、DOS 計算などを行うことになるが、それは pwbcd が担う。pwbcd は旧バージョンで別々となっていたバンド計算、DOS 計算、波動関数表示のプログラムを統合したものである。

atom は擬ポテンシャル生成プログラムでこれ自身、独立したものである。cryst は結晶を作るプログラムである。

全体を通じて、結晶の対称性を利用する部分は TSPACE[24] と呼ばれるライブラリーが支える。

2.2 計算環境と準備

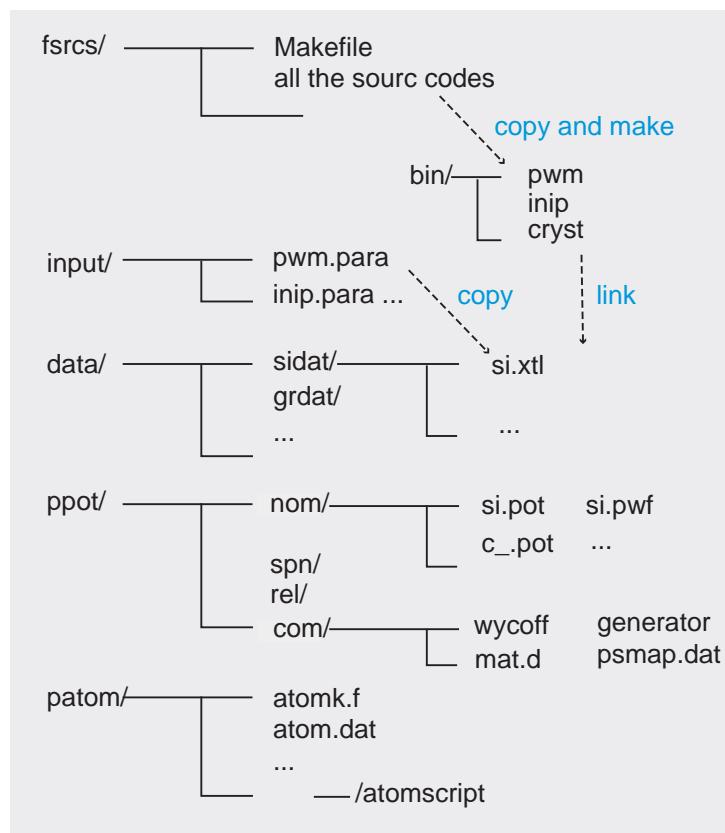


図 2.2: パッケージ Osaka2002 のディレクトリ構造

ファイル構成

ソースプログラムを持ってきた後、適当なディレクトリで解凍する。ファイルは図 2.2 で示されるように、解凍した時点で 4 つのディレクトリができる、さらにユーザーが/bin ディレクトリを作成しここに実行可能プログラムを格納する。この図に載っていないがその他/drivers というディレクトリがある。ここに機種依存を持った特別のファイルや、機種ごとの Makefile が収めされている。

全てのソースコードは Makefile とともに、ディレクトリー/fsrcts に置かれている。それを /bin ディレクトリにコピーしこのディレクトリでコンパイルし実行可能ファイルを作成する。実行可能ファイルができれば、あとはそれらを計算したいデーターディレクトリ、例えば sidat/ にリンク、コピーして使うことになる。

ディレクトリー/input にはプログラムの入力ファイルのテンプレートが置かれている
ユーザーから見て Osaka2002 の前バージョンと一番大きな違いは、pwm を初めとしてほとんどのプログラムが市販のアプリケーションプログラムと同じように一度コンパイルするとそれで十分で、結晶ごとに再コンパイルの必要がないことである。以前はプログラムに使われている配列のディメンジョンを include ファイルで指定する必要があったので結晶ごとに作り直さねばならなかった。今回では作られたバイナリープログラムは /bin にまとめておいて、どのような結晶でも共通して使うことができる。

コンパイル

まず /drivers から自分の機種に合った Makefile、drivs.f90 (必要に応じてさらに fft ルーチンなど) を取り出しソースディレクトリー fsrcts に入れる。そして drivs.f90 に対して後で述べるような編集をする。更なる機種ごとの対応については「Osaka2002 のインストレーションマニュアル」を参照されたい。

Makefile ファイルを /bin ディレクトリにコピーし

```
% make prep
```

とコマンドを打つ。これにより必要な全てのソースコードがディレクトリ bin にコピーないしはリンクされる。

コンパイルが終わったら、

```
% make clean
```

ないしは

```
% make clobber
```

として、不必要的ファイルを消しておく。

Makefile に必要な情報が書き込まれておればコンパイルはコマンド一つで済む。inip であれば

```
% make inip
```

pwm であれば

```
% make
```

となる。

バンド計算、DOS 計算、波動関数計算のプログラム pwbcn のコンパイルは

```
% make pwbcd
```

である。

原子ポテンシャルは、ディレクトリ patom/で作成し、作られたデータファイルは ppot/ のディレクトリにその種類ごとに格納しておく。

2.2.1 機種ごとの対応

ディレクトリに必要なファイルを準備したら、機種ごとの設定を行う。ディレクトリ fsrccs/の drivers/に機種ごとに作ってある Makefile や drivs.f90 が入っている。適当なものを fsrccs/のレベルに取りだし、編集する。

自分の機種に会った drivs.f90 を取り出し、サブルーチン potdirを見つけ、その中の

```
CHARACTER(LEN=15) :: datadir = '/home/user/ppot'
```

の部分を自分の環境のポテンシャルデータディレクトリに変える。

lapack などの数値計算ライブラリーは当然、使用するシステムごとに違うので、そこは各自ユーザーが調べて Makefile 中にリンク方法を指示する。その他、TSPACE はコンパイラによって対処方法が異なるので「Osaka2002 のインストレーションマニュアル」の付録に述べる。また高速フーリエ変換の部分のサブルーチンは標準のものがついてくるが、様々なライブラリーのものを利用したければやはり「Osaka2002 のインストレーションマニュアル」の付録を参照のこと。

TSPACE の既存ユーザーへ

本パッケージに添付している TSPACE は文献 [24] に付属しているものと同じだが、ただし取り扱う原子数などのパラメータを柔軟に変えられるようするため、いくつかのパラメータは別ファイル TSPARAM として用意し (4.3 節参照)、それを TSPACE.F が読み込むようにしている。そのため本パッケージに添付しているものを使うべきである。

2.3 入力パラメータ

Osaka2k を構成するどのプログラムも、それぞれの専用入力パラメータが必要である。それらは一般に*.para の名前のファイルで用意される。それらの書式はそれらが現れる順に説明していくが、ここでどの場合にも共通の事項について述べる。

これまでのプログラム開発の経験で明らかになったことは、プログラムの仕様が拡大されるにつれ、それらの入力パラメータが変わってしまい、違ったバージョンのプログラムを使うと動かなくなるということである。またそのような追加されたパラメータは多くの場合上級者のためのもので平均的なユーザーはほとんど使わないことが多い状況がある。そこで*.para に常時書き入れるパラメータは平均的ユーザーが良く使うものを使い、後は必要に応じてオプション入力にするという方法に変えた。

2.3.1 オプション

オプションはユーザーの特別な要請に応じて追加するものである。これらの拡張機能はプログラムの改良とともに進化するので、個々の使い方はケーススタディとして付随するテクニカルレポートなどで述べるとして、以下に一般事項としての規則を述べる。

まず大文字 / 小文字の区別を守る。つまり case sensitive である。

一般条件が終わった後、1行を空け、

OPTION BEGIN

で始まり

OPTION END

で終わる。この間に余計な空白行は入れない。

オプションには2種類のタイプがある。

1. トグル変数

fermi_broadening ON

のように変数名の後、空白を一つ置き、ON/OFF をおく。

2. 値変数

pressure=

1.5

のように変数名の後、続けて=を置き、改行した後、少なくとも一つ以上の空白をおいた後、数値を入力する。1行目から値を入れてはいけない。実数タイプの数字では、たとえ 300 とぴったり整数値であっても、300. と表す。

現在このオプション指定で有効な変数のリストは(刻々変わるので) 実際のソースファイル auxinp.f90 を参照してもらう。あるいはその入力部分をまとめた opts.list が参考になる。

以上でファイル構成の準備は終了で、後は結晶を作る原子全てのポテンシャルを作りディレクトリ ppot/に格納する必要がある。次章ではその作り方について説明する。

第3章 原子擬ポテンシャル

擬ポテンシャル法の特徴はポテンシャルを作る部分と、それを使う部分とが独立していることである。現在擬ポテンシャルを作るプログラムはいくつか流布されているが、Osaka2k パッケージは擬ポテンシャルについてはそのようなポテンシャル作成プログラムを利用させてもらって、それをもっぱら利用する立場に立っている。したがって Osaka2k パッケージにあって、擬ポテンシャルを作成する部分のプログラム atom は著者らが直接責任を負えない唯一の部分である。

もっともほとんどのユーザーにとってその内部原理は問題でなく、使えばそれで十分であろう。その意味では Barkley 版をもとに Troullier、Martins が開発したこの atom は非常に完成度の高いプログラムで、ほとんどバグがとれていると言われているだけあって、著者らもこのプログラムにはかなりの信頼を置いている。Osaka2k の開発途中で、問題を atom まで遡って調べる必要の起きることはほとんどなかった。

このプログラムの用途は非常に広いが、ここでは pwm に用いることに限って解説する。

ソースコードは patom ディレクトリーにある atomk.f である¹。atomk.f を

```
f77 atomk.f -o atom
```

とコンパイルした後、扱いたい原子に対しつつ一つ擬ポテンシャルを作る²。

3.1 入力ファイル

まず入力ファイル atom.dat を編集するが、そのフォーマットは以下のようになる。

Table 3.1: atom.dat のフォーマット

<i>itype</i>	<i>ititle</i>				
<i>ikerk</i>					
<i>nameat</i>	<i>icorr + ispp</i>				
<i>znuc</i>	<i>zsh</i>	<i>rsh</i>	<i>rmax</i>	<i>aa</i>	<i>bb</i>
<i>ncore</i>	<i>nval</i>				
<i>n</i>	<i>l</i>	<i>zo_↓</i>	<i>zo_↑</i>	<i>evd</i>	
...					
<i>r_{cs}</i>	<i>r_{cp}</i>	<i>r_{cd}</i>	<i>r_{cf}</i>	<i>cfac</i>	<i>rcfac</i>

¹オリジナルのコードは atom.f だが、atomk.f はその出力の部分だけを変えたものである。

²完成度が高いとはいえやはり機種依存がある。著者らが経験した範囲内での対処法はインストレーションマニュアルに書かれている。

それぞれの行の意味を書くと、

一行目 計算種 (*itype*) とタイトル (*ititle*)。計算種としては

itype=

- ae: 全電子計算
- pg: 擬ポテンシャル生成
- pe: 交換項に関する内殻補正をした擬ポテンシャル生成
- ph: ハートリー項まで含めた内殻補正をした擬ポテンシャル生成
- pt: 擬ポテンシャルテスト
- pm: 擬ポテンシャルのテストと価電子の修正

二行目 擬ポテンシャルの種類 (*ikerk*)

ikerk=

- tm2 Improved Troullier and Martins
- bhs Bachelet, Mamann, Schuter
- oth generate data file
- van Vanderbilt
- tbk Troullier and Martins
- yes Kerker
- no Hamann, Schluter, Chiang

三行目 原子名 (*nameat*) と計算オプション (*icorr + ispp*)。*nameat* は原子記号で与える。*icorr + ispp* は連続した 3 文字である。初めの 2 つは *icorr* で、電子相關関数の種類を与える。選択肢としては

icorr=

- ca Ceperly-Alder (Perdew-Zunger parameterization)
- xa $X\alpha$ method
- wi Wigner interpolation scheme
- hl Hedin-Lundqvist
- gl Gunnarsson-Lundqvist-Wilkins
- bh von Barth-Hedin

がある。

3 文字目の *ispp* は、

ispp=

r relativistic calculation

s spin polarization

□ none

を選択する。

四行目 核の電荷数 ($znucl$)、内殻の電荷数 (zsh)、内殻半径 (rsh)、最大半径 ($rmax$)、動径方向の刻みのパラメータ (aa 、 bb)。

五行目 内殻軌道の数 (n_{core}) と価電子軌道の数 (n_{val})。

六行目以下 n と l で指定される価電子軌道ごとの電子占有数 (zo)、オプションとして 軌道エネルギー (evd)。

最終行 擬ポテンシャル生成のカットオフ半径 (r_c)。およびオプションとして、内殻補正パラメータ ($cfac$ と $rcfac$)。

原子軌道はスピンを考慮しなければ、本来は主量子数 n と角運動量子数 l と共に、方位量子数 m も与える必要があると疑問に思われるかもしれない。開殻原子に対しては本来その通りだが、このプログラム（他のものもほとんどそう）では、ポテンシャルは電子の寄与も含めて完全な球対称を仮定している。すなわち、三つある p 軌道、 p_x 、 p_y 、 p_z に電子が一個しかない場合でも、電子は例えば p_x だけを占めていると考えるのではなく、 p_x 、 p_y 、 p_z それぞれを平等に $1/3$ づつ占めると仮定している。でなければ問題は本質的に 3 次元問題となり解くことが急速に難しくなる。従って m は考慮しない。

以下 Si 原子を例にとりその書き方を説明する。

```
pg      Silicon
       tm2
n=Si c=ca
      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0
      3      2
      3      0      2.00      0.00
      3      1      2.00      0.00
     2.13     2.57     1.50     1.50
```

第一行目は、計算の種類コードと、原子の名前、第二行目には、擬ポテンシャルの種類が来る。ここでは

pg 擬ポテンシャル計算

tm2 Improved Troullier and Martins

を選択しておく。

第四行目は無視。このままにする。

第五行目は、主量子数 n 、角運動量子数 l で区別された内殻軌道の数、価電子軌道の数が来る。Si の例では、中性原子の基底状態の電子占有は $(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^2$ のようになっている。つまり内殻軌道は $1s$ 、 $2s$ 、 $2p$ の 3 つ、価電子軌道は、 $3s$ 、 $3p$ の 2 つので例のような入力となる。

次に価電子軌道の状態が、一行に、 n 、 l 、スピンドウン、アップの占有数の順で記述される。今はスピンを考えないので、スピンドウンのみの占有数を使う。今の Si の例では、 $3s$ に 2 個、 $3p$ に 2 個の電子を占有させている。

最後の行が擬ポテンシャルをつくるときのカットオフ半径の値を s 、 p 、 d 、 f 軌道の順で並べる。単位は原子単位である。

3.2 実行

ここでは最も基本的な使い方を説明する。さらに進んだ取り扱いについては下巻参照。

1 全電子計算 入力データで計算の種類コードは擬ポテンシャル生成 pg とし³、atomk を実行。

また最後の行のカットオフ半径のデータは初めは適当な値にしておく。atom.dat ファイルを atomk と同じディレクトリに入れ、atomk を実行。

2 出力ファイル atom.out を読む 全電子計算の結果が出てくる。各軌道エネルギー値とともに、動径方向軌道の形に関する情報も書かれている。この時点で実際に軌道の図を見ることを勧める。それにはファイル fort.11 を適当なプロッティングソフトで読めばよい。

ファイル atom.out では

```
radial grid parameters
```

の後、各軌道の動径方向軌道の特徴が数値データで示されている。例として、

```
n = 2  l = 0  s = .0
      a extr          .634  -1.373
      r extr          .057    .458
      r zero          .153
      r 90/99 %       .903   1.348
```

を見る。これは $2s$ 軌道に関するものである。この軌道は、2 つの極値をもち、原点以外に零点が 1 つある。零点の位置が r zero で与えられる。 r extr は 2 つの極値点の位置（原子単位）、 a extr はその極値である。ユーザーはこのように各軌道関数が期待どおりの振る舞いをしているかチェックすべきである。

次に、価電子軌道の形に注目してカットオフ半径を決める。カットオフ半径 r_c の選択には任意性があるが、だいたいの目安として、最外殻の極値点の 1.1 ~ 1.6 倍くらいをとれば良い。波動関数のノード点に近くなればその値が 1 より小さくても構わない。一般に、 r_c が大きくなればなるほど、ポテンシャルは緩やかになり収束は早くなるが、その代わり transferability は悪くなる。Troullier-Martins タイプの擬ポテンシャルはこの r_c の値が他のタイプのもの（例えば Bachelet らのもの [12]）に比べて大きく取れることが特徴である。このようにして決められたカットオフ半径を改めて atom.dat に書き込む。

³全電子計算は本来 ae の選択をすべきだが、pg でも計算の前段で全電子計算をするので結果は同じ。

3 擬ポテンシャルの生成 出力ファイル atom.outなどを全て消してから再度 atom を実行。これで擬ポテンシャル、および付随する擬波動関数が生成される（ファイル fort.10）この時点で両方ともグラフ化して眺めてみることが望ましい。

fort.10 のフォーマットは波動関数、ポテンシャルの順に、そしてその各々の中で、軌道として s 、 p の順で、各データが r 座標、波動関数/ポテンシャルの値の 2 行にわたりリストされる。冒頭には r のセグメントの数が書かれている。出力される擬ポテンシャルは電子密度の寄与を除いた裸のイオンポテンシャルで、この動径波動関数 $u(r)$ はそのままで規格化されている。すなわち

$$\int_0^\infty |u(r)|^2 dr = 1 \quad (3.1)$$

であり、 $\int \cdots r dr$ となっていないことに注意。

4 ファイルの名付け 最後に、こうしてできたデータファイルはたくさんあるが、そのうちポテンシャルを記述する pseudo.dat01 および擬波動関数を記述する fort.13 を以降の計算で用いる。それぞれ原子の名前に変えてディレクトリ ppot/nom に格納する。名前はポテンシャルが（元素記号）.pot で、波動関数が（元素記号）.pwf である。今の場合は si.pot および si.pwf となる。全て小文字にすること。C のように一文字の場合は、c_.pot のように_をはさむ。

5 くり返し 以上のステップを欲しい原子だけ繰り替えす。その際出力ファイルは atom が動作するディレクトリーから取り除いておくこと。でないとエラーを起こす。

価電子の取り方

ポテンシャル生成の時、どこまで価電子とみなすかという問題がある。Si のように、 s 、 p 軌道のみでなる原子では単純であった。原子基底状態そのままの軌道を取ることで良かった。

しかしその場合でも Na だと価電子が s 軌道一つで、そうすると生成される擬ポテンシャルは s 軌道に対するもの一つとなってしまう。これでは上の軌道に対する精度が悪いので、この場合は価電子占有数として、 s 軌道に 0.75、 p 軌道に 0.25 というふうに入力し、 s 、 p 軌道両方に対する擬ポテンシャルを生成するほうが望ましい。

遷移金属など d 、 f 電子が入った場合の取り扱いは、ポテンシャルの生成で特別な注意が必要である。それに関しては別巻で取り扱うことになる。

改定 1 / 2 0 0 5

擬ポテンシャルを作るプログラムは、この間にも発展しており、atom はバージョン 5 へと改定された。一番大きな変更点は GGA が取り入れられたことである。この取り扱いが一般的になるにつれ、このポテンシャルを使うことの要請が大きくなつたので、今回のバージョンでは組み入れている。

このバージョンのものはディレクトリー/patom5に収められている。オリジナルに比べてファイルの入出力の部分だけをOsaka2kに合うように直してある。使い方はGGAに関する入力の部分の他は、これまで述べたことと変わりない。したがってGGAを使おうとしないならば、旧バージョンで十分である。

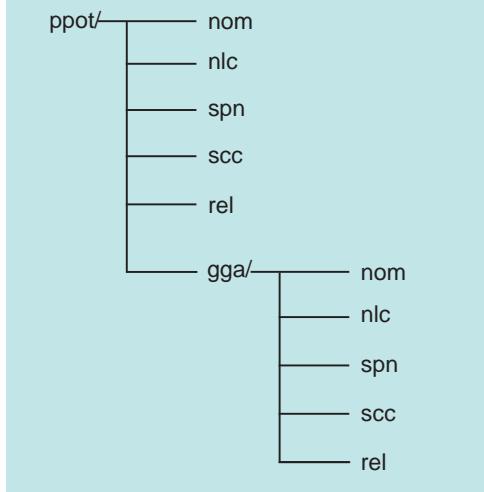


図 3.1: 改良されたポテンシャルディレクトリ

GGAは別としても、Osaka2kも取り扱うポテンシャルの型が、内殻補正、スピン偏極、相対論効果などと増えるにつれ、ポテンシャルディレクトリの整理が必要となった。従来はポテンシャルの種類としては、スピン、内殻補正、相対論補正の3つを区別してきた。それに応じたポテンシャルデータはspn、nlc、relと三通り用意してきたが、しかしそれらの組み合わせも出てくるし(例えばスピンと内殻補正)、さらにGGAも取り入れるとその組み合わせの数は途端に膨れ上がる。また、取り扱う原子が複数の時、どれが優先されるかの指針も明確にしないと混乱に陥る。

そこで今回の改定で、図2.2で示されるポテンシャルディレクトリは図3.1のように階層構造を導入し再構築した。それぞれのディレクトリには表3.2のような役割を持たせている。

Table 3.2: Potential directories.

dir	potential type
nom	normal potential
nlc	nonlinear core correction
spn	spin polarization
scc	spin polarization with nonlinear core correction
rel	relativistic effects

第4章 結晶の作成

4.1 結晶データ入力

結晶はその単位格子、およびその中の原子位置によって記述される。単位格子は、その中で最小のものは基本単位格子 (primitive unit cell) と呼ばれるが、実際にはいろいろな理由で慣用単位格子 (conventional unit cell) が多く用いられる。primitive unit cell は通常その単位並進ベクトルを \mathbf{R}_1 、 \mathbf{R}_2 、 \mathbf{R}_3 と表すのに対し、conventional unit cell はその単位並進ベクトルを \mathbf{a} 、 \mathbf{b} 、 \mathbf{c} と表す。座標 (h, k, l) というとき、何も書かれていないと、それが $h\mathbf{R}_1 + k\mathbf{R}_2 + l\mathbf{R}_3$ を意味するのか $h\mathbf{a} + k\mathbf{b} + l\mathbf{c}$ を意味するのかわからない。そこで、ここでは前者を primitive base 表現、後者を conventional base 表現と呼び区別することにする。それにともない、逆格子も、primitive base では \mathbf{G}_1 、 \mathbf{G}_2 、 \mathbf{G}_3 、conventional base では \mathbf{a}^* 、 \mathbf{b}^* 、 \mathbf{c}^* と表す。

一般的な結晶データは、この意味で conventional base で表され、3つの基本ベクトルの長さ a 、 b 、 c 、それらの間の角 α 、 β 、 γ で表される (α は b 、 c 軸の間の角。以下同様)。cryst では、 a 、 b 、 c 、 α 、 β 、 γ を用いて慣用単位格子のベクトルを直交座標系で、

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= a\hat{x} \\ \mathbf{b} &= b(\cos\gamma\hat{x} + \sin\gamma\hat{y}) \\ \mathbf{c} &= c(\cos\beta\hat{x} + r\hat{y} + \sqrt{1 - \cos^2\beta - r^2}\hat{z})\end{aligned}\tag{4.1}$$

ここで

$$r = (\cos\alpha - \cos\beta\cos\gamma)/\sin\gamma$$

と取っている。ただし菱面体結晶に関しては、式 (4.1) のようにとったのでは、3回軸が z 方向とならない。それでこの場合は例外として、3回軸を z 方向に持ってくるように座標系を取っている。その取り方を図示しておく (図 4.1)。2回回転軸は x 方向に取っている。

基本的には計算結果はこの特定の座標系の取り方に依存しない。しかしフォノンの固有ベクトルや弾性定数など、ともかくも座標系を指定しないことには記述不可能なものもある。これらに関する座標系は今述べた取り方をしている。

ところで TSPACE は基本的には conventional base で書かれているが、pwm はもともと TSPACE とは独立して開発されたため primitive base の記述が基本となっている。このため Osaka2k のソースコードにはいたる所、座標系変換のコードが入れられていて非常に読みにくくなっている。

結晶データは、name.xtl というファイルに書かれている。例として挙げると、GaAs を記述したファイル gaas.xtl は、

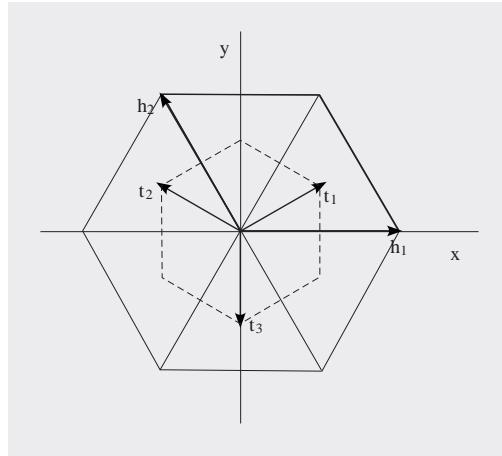


図 4.1: 菱面体結晶の軸の取り方。2回軸はx軸、鏡映面はy軸にとっている。

```

TITLE GAAS
DIMENSION 3
CELL
      5.65315      5.65315      5.65315    90.00000    90.00000    90.00000
SYMMETRY NUMBER 216 QUALIFIER ORIGIN_1

```

```

ATOMS
NAME      X          Y          Z      POT  CHARGE     TEMP   OCCUP  SCAT
GA1      0.00000    0.00000    0.00000  ga    3.0000  0.5000  1.0000  GA
AS1      0.25000    0.25000    0.25000  as    5.0000  0.5000  1.0000  AS

```

となる。このフォーマットは MSI 社の INSIGHTII の入力フォーマットに従ったものである。従ってこのデータは INSIGHTII でそのまま表示できる。

ファイルフォーマットは、TITLE、DIMENSION 3 の後、格子定数パラメータが続く。標準的な格子定数の記述の仕方に従って、

$a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$

の値が、 \AA あるいはdegの単位で並べらる。標準的という意味は、conventional 表現を用いるということである。

続いて、空間群の番号が書かれ、必要に応じて後で述べる QUALIFIER をつけることができる。

その後各原子の座標が、相対座標 (conventional unit cell に対して) で書かれる。大抵の結晶データは conventional base での相対座標で表されているので、この処置は適切であると信じているが、三方晶の場合はしばしば混乱があるので注意が必要だ。三方晶の場合の問題は文献 [26] で整理されているので参考になると思う。プラベー格子が菱面体のものは QUALIFIER を Rhombohedral とすることが基本であるが、その座標を六方晶として取っているものもあるので、その場合は QUALIFIER を Hexagonal とする。

ここで単位格子内の原子数に関するいくつかの量を区別する必要がある。¹

N_{at} : 全原子数

N_{spe} : 原子種類数

N_{ka} : 既約サイト数 すなわちその結晶の対称性では結ばれない原子の数

N_{spe} と N_{ka} の違いは、元素として同じものは前者では一つとして数えるのに対し、後者では対称性で結ばれなければ別種として数えるということである。例としてグラファイトを考えると

$$N_{\text{spe}} = 1, N_{\text{ka}} = 2, N_{\text{at}} = 4$$

となる。

ファイル*.xtlでリストされているものは、単位格子内の全ての原子ではなく、既約サイト N_{ka} の原子に対するものだけで良い。残りの原子はこれらの既約サイトから空間群の対称操作により作られる。これらの量の識別は、付属するサンプル結晶データファイルで練習すると良い。

NAMEは原子の名前とは必ずしも一致する必要はなく適当につけてかまわない。次に相対座標が書かれ、その後使うポテンシャルデータの名前が来る。この名前が実質使う原子を指定している。この名前により前章でつくったポテンシャルのファイル名を探すので、小文字であるべきである。つまり Si に対しては si とし、C に対しては c と空白を入れる。

それ以降のデータはここでは読まないので無視する。²

空間群の QUALIFIER としては、"International Tables for Crystallography" (ITC) [25] の記述に従う。出てくるものは、

ORIGIN_1 か ORIGIN_2

三方晶に関しては

RHOMBOHEDRAL か HEXAGONAL

対称性が低い結晶では、

UNIQUE_b か UNIQUE_c

の選択の他、それに加えて

UNIQUE_b,CELL_1 or 2 or 3

がある。ただしこのパッケージの空間群を受け持つ TSPACE の制限より、底心中心の場合は C center しか受け付けないから、そうなっていないものは自分で焼き直す必要がある。そして ITC をみて C center となっている CELL_n を選ぶべきだ。

¹ 基本的にはインクルーズファイルが無くなった今では以下のパラメータを陽に指定することは無くなっただが、依然そのパラメータの意味を知ることは重要なので、以下にその記述を残した。実際のところ本体プログラムからはインクルーズファイルは無くなったが、TSPACE は依然インクルーズファイルを使っている。

² 以前のバージョンではこの後の値電子数も指定する必要があったが今はその必要がなくなった。それらの値はポテンシャルデータから読まれる。

4.2 cryst の実行

次にこの*.xtl を用いて cryst を実行する。その結果*.prim が outputされる。以降の全ての計算において、結晶データは*.xtl を参照するのではなく、この*.prim を参照する。またこれ以降の計算内部では、単位は基本的には原子単位になることも記憶しておいたほうが良い。出力時のみ必要に応じて他の単位系も用いられるが、何も表示のないものは原子単位である。

使い方は、今の例では、si.xtl をディレクトリ sidat/に置き、cryst を実行する。結晶名を聞かれるので、

```
input the crystal name with a period at the end.  
> si.
```

と入力する。ピリオドを忘れずに。

出力されたファイル si.prim を必ずチェックすること。タイトル、日付データの後、conventional unit cell、primitive unit cell、逆格子ベクトルのそれぞれの 3 軸が直交座標で表示される。

```
TITLE GAAS  
date: Fri Jan 5 17:56:20 2001  
DIMENSION 3  
LATTICE PARAMETERS (A,B,C,CA,CB,CC) in a.u.  
10.6829045 10.6829045 10.6829045  
0.0000000 0.0000000 0.0000000  
Space group  
216 Td2 F-43m ORIGIN_1  
IL NG NC  
2 24 1 ORI  
The conventional vectors  
10.6829045 0.0000000 0.0000000  
0.0000000 10.6829045 0.0000000  
0.0000000 0.0000000 10.6829045  
The primitive vectors  
0.0000000 5.3414522 5.3414522  
5.3414522 0.0000000 5.3414522  
5.3414522 5.3414522 0.0000000  
The primitive reciprocal vectors without 2Pi  
-0.0936075 0.0936075 0.0936075  
0.0936075 -0.0936075 0.0936075  
0.0936075 0.0936075 -0.0936075
```

IL、NG、NC は TSPACE のパラメータで、それぞれ格子のタイプ、結晶点群のオーダー、座標原点の選択数である。

入力された空間群の番号に基づいて、primitive unit cell の情報が計算されるが、それが予想通りになっているかチェックすべきである。次に N_{spe} とその原子情報が現れる。そのあと、原子の既約サイト数 N_{ka} が来て、それについてのワイコフ位置の記述が続く。

```
Number of atom species  
2
```

```

No      Name     Zat     Zval
1       ga        31      3
2       as        33      5
KIND OF ATOMS
2
Wycoff Positions
ATM (      x,      y,      z)    Nos    Wycof      Code
1 ( 0.00000, 0.00000, 0.00000)  1/ 1    4a      0 0/1  0 0/1  0 0/1
2 ( 0.25000, 0.25000, 0.25000)  3/ 1    4c      0 1/4  0 1/4  0 1/4
NUMBER OF ATOMS
2
L.L. AND U.U.      VALENCE      ELEMENT
1       1       3.0000      1       ga
2       2       5.0000      2       as
POSITIONS RELATIVE TO A UNIT CONVENTIONAL CELL      SPECIES      SYM(IG)
1       0.0000000   0.0000000   0.0000000   1       ga       1
2       0.2500000   0.2500000   0.2500000   2       as       1

```

その後、総原子数 N_{at} に続き、L.L. AND U.U. の見出しの後、既約サイト毎に、それに属している原子の区切り番号をリストしている。番号 L.L. から U.U. までの原子がその行の原子種類であることを示している。その行に表れる価電子数をチェックすべきだ。そして各原子位置の相対座標が現れる。

注意 `cyrst` は入力データからワイコフ位置を解読するが、230 もの空間群の複雑さのため今のプログラムでは完全には解読できない。³解読に失敗すると `cryst` は常にその位置に一般点を当てる。従ってこの部分はユーザーが常に注意しなければならない部分である。間違ったワイコフ記号が割り振られていたら、手でその部分を直さなければならない。ワイコフ記号は ITC に従う。その位置コードは、TSPACE[24] の記号に従っている。すなわちそれは 3 つの組で表され、それぞれの組では、整数 + 分数が来ている。整数部分は 0 は相対座標が 0、1 は相対座標が一般値 x 、2 は y 、3 は z 、マイナスが付けば負の値を意味し、その後の分数はそのまま相対座標を示す。例えば、{1 0/1 2 1/4 -2 1/4} とあれば、 $(x, y + \frac{1}{4}, -y + \frac{1}{4})$ を意味する。

4.3 制御パラメータ

これまでのところ、ユーザーが変更すべきパラメータはほとんどなかった。たいていの目的には、TSPARAM と xtl.inc は初期値のままで問題ないと思う。しかし非常に大きなサイズの結晶などを使う場合にはこれでは間に合わず、ユーザーが変更しなければならないことがあるのでここで説明しておく。

TSPARAM は直接的には TSPACE が使うが、それ以降の `cryst`、`inip`、`pwm` などのほとんどの include ファイルがその設定値を伝承するので重要である。

```
PARAMETER (LMNATM=50, LMNKAT=20)
```

³この解読がどれくらい大変なことが考えても見てくれ。例えば、相対座標で 0.5 の点がワイコフ座標で特種点 $1/2$ になるのか、それとも一般点 x でたまたまその値が 0.5 であったのか、それを 230 もの空間群の中で判定するのはどれくらい大変なことか。

PARAMETER (MAXNPW=4854)

LMNATM はセル内の全原子数 N_{at} の上限、LMNKAT は同じく既約サイト数 N_{ka} の上限である。従って、実際に使う数よりも大目に取っておく。

MAXNPW は平面波の数の上限であるが、これは TSPACE の中で使われる平面波の数で、後の pwm で使われる平面波数と別の量である。

4.4 結晶のグラフィックス表示

ここまで来ると、ユーザは結晶データが本当に正しいかを数字でなく図で確かめたいと思うだろう。これまでの数値データからだけで頭に結晶図が描ける人は幾何学能力がすば抜けて優れている人のみで、大抵の人は絵を見なければ想像もできないだろう。結晶が間違っているとこの後の計算が全て無駄となるので、結晶のチェックは必ず行う。`*.prim` のデータは Mathematica のノートブック Crsytnal.nb でグラフィックス表示することができる。ファイル名`*.prim`を入れればだいたい自動的に結晶を描くようになっているが、実際の結晶の複雑さのためユーザーはどうしても描く範囲などを調整する必要はある。

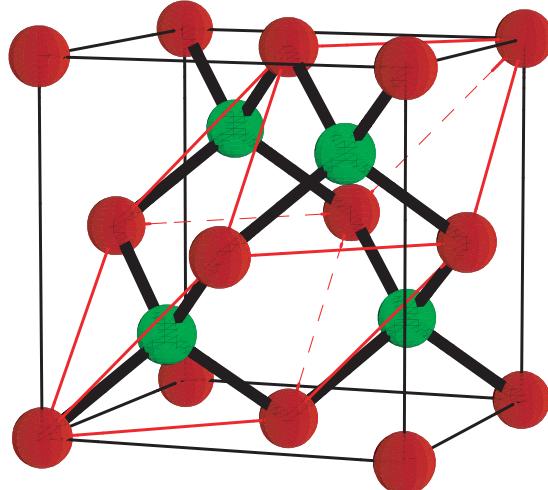


図 4.2: GaAs 結晶。赤線は基本単位格子を示す。

ここにその使い方の詳細を書くことは控えまるが、だいたいノートブックのタイトルに沿いながら、ユーザーが判断できると思う。またグラフィックス座標の取り方は付録 A を参照していただく。

CrstAnal.nb は結晶を描くばかりでなく、ボンド間の距離、角度の計算などの解析に有用である。図 4.2 に CrstAnal.nb による結晶図の例を示す。

第5章 電子の基底状態計算 (I)

5.1 inip

電子状態の計算プログラム pwm に入る前に、計算の前準備をいくつかしておく必要がある。それが inip である。¹

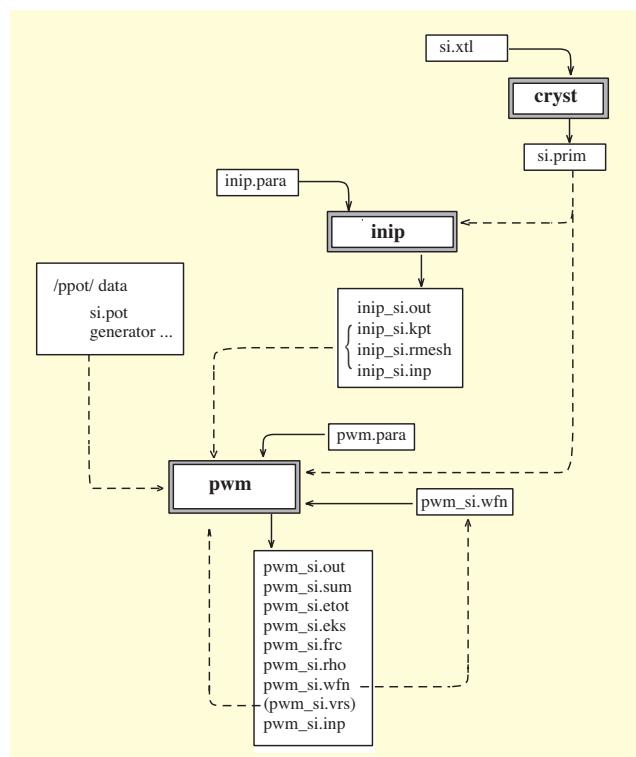


図 5.1: pwm を中心とするファイル依存性

inip の具体的な目的は、一つに逆格子空間でカットオフ半径 k_c を与え、その球内で平面波基底を展開すること。平面波数 N_{pw} を数え、それから適切な FFT 領域を割り出す。 k_c と FFT 領域を指定する NGDIM や NG3 の間の関係は図 1.2 のようになる。FFT 領域の一辺が $2^*NGDIM+1$ で、実空間では NADIM= 2^*NGDIM となる。

¹旧バージョンでは inip の一番大きな目的はあらかじめプログラムサイズを見積もり、include ファイルの中のパラメータ指定をすることであった。新しいバージョンでは基本的に include ファイルを廃止しているので inip は必要ではなくなるが、しかしながら inip の役割はそれだけでなく、pwm での計算に必要ないろいろな下準備をする。これらは以前と同じく本体 pwm と切り離して行うことにしている。

inip のもう一つの目的は、 k サンプリング点を決定することである。これについては次節で述べる。

入力ファイル inip para は以下のようになる。

```
Input file name (period is needed at the end)
si.
Parameters about k points
Cutoff k radius (AMAX) given by lattice index without 2Pi
3.1
way to give sampling points (0:given manually, 1:calc)
1
number of k-sampling points
2
potential type (spin, NLCC, relativistic)
0      0      0
```

以下にそれぞれのパラメータの意味を順に説明する。

まず計算しようとする結晶の名前がピリオドとともに書かれる。その後、

- 平面波カットオフ半径 (AMAX)
平面波カットオフ半径 k_c を、逆格子ベクトルの中で最小の大きさ g_{\min} を単位に入力。
- k サンプリング点の与え方
1 で自動的に計算する。0 は手入力。
- k サンプリング分割数 (NKDIV)
自動計算のときの分割数。
- ポテンシャルに対する補正
ポテンシャルに対するオプションで、スピン、内殻補正、相対論的效果のオプションを付けるかどうかを指示する。1 は付ける、0 は付けない。これは擬ポテンシャル作成の atom に対するオプションと同じで、当然両者で一致すべき。

となる。

5.1.1 k サンプリング法

k サンプリング点の決め方には以下の方法がある。

(i) 自動計算 (一様サンプリング = デフォルト) 自動計算の場合は、1.6 節で述べられたように Monkhorst-Park の方法によりサンプリング点が決められる [16]。デフォルトではゾーンの 3 方向とも、 M を正整数として、 $(-M+1)/2M$ から $(M-1)/2M$ まで M 分割する ($2\pi/a$ 単位)。

つまり $M = 1$ で Γ 点のみ、 $M = 2$ で $(1/4, 1/4, 1/4)$ とそれらの符号を変えた計 8 点となる。実際には結晶の対称性のためサンプリングに必要な数はこれよりずっと少なくて済む。

図 5.2 にこの取り方の特徴を初心者の良くやる取り方と比較して示している。初心者であれば、まず差し当たり区切れの良い中心、次に両端、そしてそれらの間を等分することを考えるだろう。Monkhorst-Pack の方法のミソは境界点をなるべく避けていることである。その方がより少ないサンプリング点でも精度が保てるのである。

M の値としては、 $M = 1$ の場合を除き、偶数になることを推奨する。

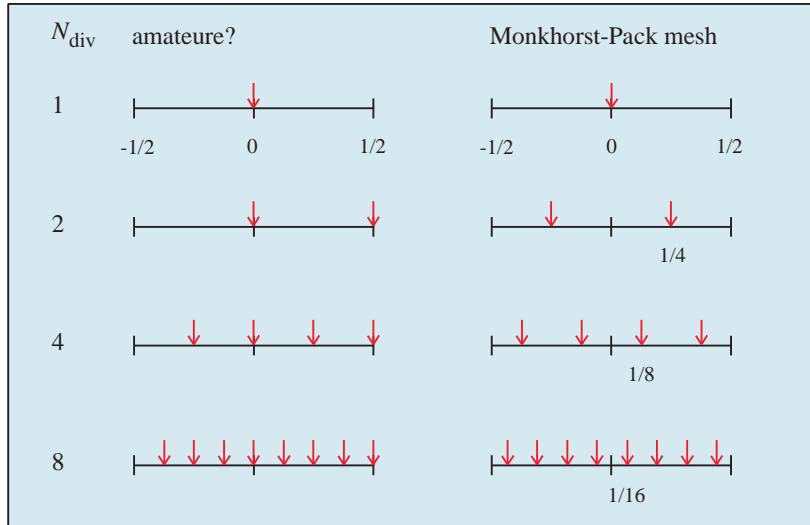


図 5.2: Monkhorst-Pack の方法によるサンプリング点の取り方と、初心者の取り方の比較。Monkhorst-Pack 法ではなるべくゾーン中心や、境界点が避けられるような取り方となっている。

この分割数 M の値を NKDIV に入力する。最終的なサンプリング点とその総数は、inip の出力ファイル inip_*.inp に書き出される。その部分は、

```

nkpts
2
Sampling point in p
LD    -1   -1   -1/  4      WTK=  0.250000
XY      1   -1   -1/  4      WTK=  0.750000

```

のようになっている。つまり、 $M = 2$ に対して最終的なサンプリングの総数 n_{kpt} はたった 2 点で済んでいる。それらは、primitive base で $(-1/4, -1/4, -1/4)$ と $(1/4, -1/4, -1/4)$ で、それぞれの重みは $1/4$ と $3/4$ であることがわかる。

(ii) 自動計算（非一様サンプリング） 超格子など異方性が著しい結晶では先の等方的サンプリングでは非効率となる。このようなときは異方性を考慮したサンプリングを取るべきである。そのような場合は、inip para の基本データが入力し終わったところで 1 行空け、

```
OPTION BEGIN
```

```

anisotrop_ksample=
 1   1   4   4
OPTION END

```

のようにオプション指定をする。anisotrop_ksample=と与えることで、以前に指定した一様分割数 NKDIV の指定を無効にする。次の行で与えられる初めの 3 つの数字は基本ベクトル g_1 、 g_2 、 g_3 の方向の分割点数、最後の数字はその 3 つの分割点数の最小公倍数を与える。inip は与えた数字が最初の 3 つの最小公倍数であるかチェックしないので、これが間違うと後の計算は誤ったものとなる。

(iii) 手動入力　自動計算は便利だが、一方こうした自動的な一様分割では扱えない場合がある。その場合はサンプリング点は自分で考え、手入力する。次がその手入力の例である。手動入力 k 点サンプリングの場合は上のリスト 6 ~ 9 行目のところを

```

way to give sampling points (0:given manually, 1:calc)
0
number of k-sampling points
4
KB(3), ICB
-1   -1   -1   4
 1    0    0   4
 0    1    0   4
 0    0    1   4

```

のように置き換える。これは primitive base で $(1/4, 1/4, 1/4)$ と $(1/4, 1/4, -1/4)$ の 2 点を与える。

六方晶などの場合は Chadi-Cohen アルゴリズム [30] に従ったサンプリングが有効な場合もあるので、このときは手入力にする。

k 点の数が少ない場合は、サンプリングの取り方は重要で、例えば同じ物質のさまざまな結晶多形を比較する場合、それらの多形間で「等価のサンプリング」をする必要がある。超格子構造や SiC がその良い例である [31]。

どちらの方法にしろ、その k サンプリングの質がどれくらい良いものかを、式 (1.33b) で評価する必要がある。inip_*.out の

```

=====> Final report for k-point sampling <=====
のセクションで、

```

```

Quality of sampling by 2-points...
list only nonzero shells up to 41 shells
Sh No      shell sum
     8      ( -1.00000,  0.00000)
    15      (  1.00000,  0.00000)
    23      ( -1.00000,  0.00000)
    26      ( -1.00000,  0.00000)
    28      (  1.00000,  0.00000)
    32      ( -1.00000,  0.00000)
    36      (  1.00000,  0.00000)
    38      (  1.00000,  0.00000)

```

とリストされている。ここでは式 (??) の値が 0 でないものだけを表示している。すなわちこのサンプリングでは第 7 近接の格子点までの和は 0 となるということだ。

その他のオプション k 点サンプリングに関しては、これまで述べられたもの以外に、時々使うものがいくつかある。それらを列挙すると、

1. k 点の原点の選択

Monkhorst-Pack 法では k 点サンプリングの原点はデフォルトでは 1 点サンプリング以外は、 $k = 0$ を取らない。しかし時々 $k = 0$ を取りたいときがある。そのときは

```
KPorg=1
```

とする。

2. ダブル k 点の選択

これは主に、電子数が奇数の時のためものである。電子数が奇数の時このオプションを設定してやると、同じ k 点に対して、電子数を 1 個増やしたときと 1 個減らした場合の計算を実行する。

```
double_k ON
```

とする。

5.1.2 平面波カットオフ半径

次に重要なパラメータは平面波カットオフ半径 (AMAX) である。この無次元 AMAX によりカットオフ半径 k_c は、

$$k_c = \text{AMAX} * g_{\min} \quad (5.1)$$

で、カットオフエネルギー E_{cut} (原子単位) は式 (1.25) で与えられる。 g_{\min} は 3 つの基本逆格子ベクトルの大きさの中で最小のものである。

それぞれのサンプリング点 \mathbf{k}_i について式 (1.24) を満たす全ての \mathbf{G} が平面波展開として取られる。従って平面波の数、 N_{pw} はサンプリング点ごとに少し違うことになる。具体的には、出力ファイル `inip_*.out` の中で、

```
=====> Final report for k-point sampling <=====  
For cutoff energy in Ry = 4.959185  
NHDIM = 59  
NGDIM = 4  
nkpts= 2  
Name: LD -1 -1 -1/ 4 NSTR= 8 WTK= 0.250000 NPW= 55 INV= 6  
Name: XY 1 -1 -1/ 4 NSTR= 24 WTK= 0.750000 NPW= 50 INV=18  
Sum over WTK 1.000000
```

の部分に書かれている。これから $(-1/4, -1/4, -1/4)$ と $(1/4, -1/4, -1/4)$ の 2 点では、 N_{pw} は 55 と 50 点と違った値となっていることがわかる。それぞれの点の全平面波のデータはファイル `inip_*.kpt` に収められる。`inip` はこのような情報などから、 N_{pw} の最大値としての NHDIM を 59 になるように指示している。この NHDIM とともに、pwm で使うパラメータの値は `inip_*.out` の最後の部分にまとめられている。

Passed parameters

NEPC	8	NEDIM	4	
NKPTS	2	NHDIM	59	
NGDIM	4			
Then, ...				
LIN SEG	NGLIN	9	NADIM	8
VOL SEG	NG3	729	NA3	512

このほか、inip は実空間の対称点に関するデータをファイル inip_*.rmesh に格納する。
ただし結晶の対称性が全くない(すなわち空間群 P1)場合は、このファイルは出力しない。

5.2 pwm の動作

「OSAKA2000」の核心部分 pwm は与えられた結晶に対して、セルフコンシスティント計算を行い電子の基底状態を求めるために用いる。理論の 1.7 節のところで述べられたように、それはエネルギー汎関数を直接繰り返し法により最小化することで達成される。

実行可能コード pwm を make で生成したあと、計算するディレクトリーにコピーあるいはリンクを取る。

5.2.1 セルフコンシスティント計算

pwm の入力パラメータはファイル pwm.para で記述される。ここにユーザーが制御すべき基本的パラメータが書き込まれる。実際には pwm は他に多くの計算制御パラメータを持っているが、それらを全て pwm.para にリストすることは止めた。はじめに述べたように、それらの付加的なパラメータはオプションにより指定する方式を採用した。そうすることによって上級ユーザーの高度な要求にも応えれるようなものにした。

入力ファイル pwm.para の典型的な例は以下のようになるであろう。

```
Input file name
si.prim
Job (0:SCF Calc. 1:Atom optimize 2:Cell optimize 3:Phonon 4:MDS)
0
atom movement (0: OFF, 1: ON    valid only when cell optimization)
0
number of iteration for electrons (maxIter0wfn)
15
conjugate-gradient paths (npath)
5
wftol
1.0D-11
ftol
8.0D-5
etol
1.0D-12
iread (previous WFs)
0
imoni,irhout,iwfout
0      1      1
Resume atom relaxation
0
max number of iterations for atoms (maxIter0atom)
4
Resume cell relaxation
0
max number of iterations for cell (maxIter0cell)
2
```

以下にそれぞれのパラメータの意味を順に説明する。

xtl.name	結晶名
Job	ジョブタイプ 0 : SCF 計算 (デフォルト) 1 : 原子位置の最適化、 2 : 格子の最適化、3 : フォノン計算、4 : MDS
atomMove0ctrl	原子位置の緩和 0 : しない (デフォルト) 1 : する
maxIter0wfn	波動関数に関するエネルギー汎関数の最小化過程の 繰り返し数の最大値
npath0wfn	一つのバンドに関する共役勾配繰り返し数
wftol	波動関数の収束までの許容値 (Ry ² 単位)
ftol	HF 力に関する収束許容値 (Ry/a _B ² 単位)
etol	エネルギー収束の許容値 (Ry 単位)
iread_wfn	初期波動関数の選択 0 : 入力なし (デフォルト)
imoni0ctrl	モニターオプション 0 : なし (デフォルト)
irhout	電荷密度ファイルの出力 1 : あり (デフォルト)
iwfout	波動関数ファイルの出力 1 : あり (デフォルト)
atomMove_resume	原子位置緩和の再開 0 : なし (デフォルト)
maxIter0atom	原子位置緩和の最大繰り返し数
cellMove_resume	結晶格子緩和の再開 0 : なし (デフォルト)
maxIter0cell	結晶格子緩和の最大繰り返し数

この中で最も重要なものは収束条件に関するパラメータである。理論のところ (1.7 節) で述べたように、電子の基底状態はエネルギー汎関数を繰り返し法によって最小化する。まず繰り返しの最小単位として、ある k_i 点において一つのバンドが取り上げられる。そのバンドにつき npath0wfn 回、共役勾配過程が繰り返される。それを全てのバンドについて一つ一つ繰り返す。そしてそれを全ての k_i 点で繰り返す。その全体の過程を maxIter0wfn 回だけ繰り返す。

この中でユーザーが最も頻繁に変えるものは maxIter0wfn であろう。npath0wfn は差し当たり 5 くらいの設定で良い。セルフコンシスティント計算は繰り返しが maxIter0wfn を越えるか、波動関数の誤差が wftol 以下、あるいはステップごとのエネルギー変化が etol 以下になったときにストップする。

電子系のセルフコンシスティント計算だけをもくろみたいときは、ジョブタイプは 0 とする。このときは atomMove_resume 以降のパラメータは無視される。

ある結晶に対して初めて計算するときは、iread_wfn=0 とする。このとき波動関数の初期値としては乱数を使われる。

出力制御として、モニタリング (imoni0ctrl)、電荷密度 (irhout)、波動関数 (iwfout) がある。デバッグ時以外は imoni0ctrl=0 とする。電荷密度、波動関数データファイルは必要なときは 1、不必要なときは 0 とする。大きな結晶では、これらのデータファイルが膨大になるので必要時以外は出力しないほうが良い。

これだけを準備できたら後は pwm の実行である。計算の短いものは、

```
% pwm
```

だけで良い。プログラムが立ち上ると計算経過がモニタに流れてくる。計算の長くかかるものは、バックグラウンドで流すべきである。

```
% pwm>stdout &
```

pwm は標準出力にいくつかの情報を打ち出すので、バックグラウンド時にはこのように出力のリダイレクトを行ないとエラーになる。大型などでキューシステムに乗せるには、そのマニュアルに従ってもらう。

問題とする結晶で、どれくらいの計算時間になるかを知ることは重要である。その目安を与えるものがディレクトリ becmrk/にある例である。これは8ヶの Si からなるダイヤモンドセルの計算を様々なマシンで実行したベンチマークが入っている。自分のマシンで比べてみて欲しい。

5.2.2 解釈

pwm は計算が終わると図 5.1 のように様々なファイルを出力する。

pwm_*.out: 計算経過

pwm_*.eks: KS エネルギーレベル

pwm_*.frc: Hellman-Feynman 力

pwm_*.etot: 全エネルギー変化を中心とした計算の中核部

pwm_*.sum: 更なる要約

pwm_*.rho: 電荷密度分布

pwm_*.wfn: 波動関数。これはバイナリーファイル

このうち一番重要なのは pwm_*.etot である。その中身は、はじめに

```
===== CALCULATION PARAMETERS =====
```

JOB Type:

Self-consistent Electronic Calculation

Potential Type:

spin = 0 nlcc = 0 relativ = 0

KLEINMANN-BYLANDER TYPE FULLY SEPARABLE FORM

Ceperly-Alder type electron-correlation functional

maximum l = 1

...

のように計算条件の記述があり、その後結晶の記述が続く。それらに一応目を通しチェックすべきだ。

その後、

```
=====
          Selfconsistent Calculation =====
=====
iter      Eel           deE           Xsi           nst/bk       aglmax
      (Ry/cell)     (Ry/cell)     (Ry^2/cell)
=====
1       1.1167068599 -7.3979E+00  2.4698E-02   5/ 0       0.637356581
2       0.9919043641 -1.2480E-01  4.3798E-05   5/ 0       0.128972346
3       0.9916634496 -2.4091E-04  5.6158E-08   5/ 5       0.003105065
4       0.9916631217 -3.2783E-07  3.6162E-10   4/ 11      0.000173636
5       0.9916633948  2.7304E-07   2.3709E-11   2/ 6       0.000009096
CG process is stopped because increase in Eel  2.7304E-07
=====
.
.
.
Etot      Eel           delta E       resid      iter
=====
-15.8051160963 0.9916633948  2.730E-07   2.371E-11   5
```

などと、電子系の収束の経過がリストされる。

各繰り返しごとに、

- iter: 繰り返し番号
- E_{el} : 電子系の全エネルギー。
- ΔE : 電子系の全エネルギーの前の繰り返しからの変化。
- ξ : 残留波動関数誤差 (式 (1.40) 参照)
- パス数: 実際実行した共役勾配のパス数/内バックした回数。共役勾配のパス数は各バンドごと npath 回繰り返されるが、繰り返しが進むと npath 回繰り返す前に他の収束条件のためストップする。ここで現れる回数はバンドごとの値のうち最大値を示す。バックした回数というのは、共役勾配過程でエネルギーは基本的に減少するはずだが、時には失敗しエネルギーが増加することもある。そのようなときは、そこでそのバンドの共役勾配過程を止めて次のバンドに移る。バックした回数とは、全てのバンドに関するそのような事が起きた全回数である。
- θ : 波動関数更新時の新旧波動関数の混ざり具合を示す θ (式 (1.45) 参照)。各バンドの θ の内で最大値を示す。

が表示される。 E_{el} が減少し、それにつれ ΔE の絶対値、 ξ 、 θ が小さくなる様子がわかる。繰り返しは、 $|\Delta E| < \text{etol}$ となったため 5 回目でストップしている。このときの電子系のエネルギー E_{el} にイオンの Ewald エネルギー E_{ewald} を加えて、全結晶エネルギー E_{tot} が最後に出力される。

その次には、この全エネルギーの内訳が

```
component of Etot
kin           5.97858894
hart          1.08391474
exc           -4.78172988
```

```

loc      -1.80253465
nonloc   0.51342418
ewald    -16.79677949
-----
total    -15.80511616

```

のようにリストされる。これは全エネルギーを式(1.22)のように分解したときのそれぞれの成分である。これによりどの項が全エネルギーに効いているかを知ることができそれなりに有用である。しかしながら、こうした項に分けることはある程度数学的な便宜上のことで、それにあまりに過大な物理的意味を持たせようすることは危険である。

例えば、一番物理的意味がはっきりしていそうなイオン-イオン直接相互作用のEwald項(式(1.23))でさえも、他の項との独立性がそう自明ではない。文献[23]では、Si結晶を圧縮したとき、全エネルギー変化を上のように分解し、Ewald項は減少していることを示している。Si結晶では、全ての原子が+4価のイオンになっているわけだから、それらがお互いより密集したときクーロンエネルギーは上がると思うのが普通であろう。それはEwald項でさえも式(1.22)のように分解したときの第4項の、イオンポテンシャルと電子の相互作用項と独立でないからである[27]。

最後にストレスが

```

total stress (Ry/Bohr^3)
S(1,1)= -2.24759E-05    S(2,3)= 3.17724E-10
S(2,2)= -2.24759E-05    S(3,1)= 2.52820E-10
S(3,3)= -2.24756E-05    S(1,2)= -1.10795E-10

```

のように出力される。結晶の変形に対するストレスを求めて、弾性定数を求めることができる。ストレスに関しても、エネルギーのように各成分に分解することは可能で、それはファイルpwm_*.frcに書き出されている。しかしこの分解にあまりに多くの物理的解釈を持ち込むのは、エネルギーの場合と同様(もしかしたらそれ以上)危険である。

例えば、全エネルギーの式(1.22)の第一項は運動エネルギーを表すが、それに「対応する」ストレスの表式は文献[23]の式(2)の中で、

$$\sum_{i,\mathbf{G}} |c_{\mathbf{k}_i+\mathbf{G}}|^2 (\mathbf{k}_i + \mathbf{G})_\alpha (\mathbf{k}_i + \mathbf{G})_\beta \quad (5.2)$$

となっている。この対応自身に何の問題もないが、しかしこの式(5.2)が、文字通り、歪みに対する全エネルギーの式(1.22)の運動エネルギー項の変化を与えるものと考えるのは誤りである。つまり両者は数値的に等しくないのである。Hellmann-Feynmanの定理は、基底状態のセルフコンシステント解が求まったとき、「全」エネルギーの変化が、原子位置や格子定数などの「陽の」微分で与えられることを保証しているが、エネルギーの個々の成分については成り立たない。であるからストレスの表式も結局全体としてだけ意味を持つものである。

このほか、各原子に働くHellmann-Feynman力の値は、pwm_*.frcに出力される。

		ATOM			X	Y	Z
ITER=	1	1	1	-0.230775E-08	-0.154249E-07	-0.573629E-07	
		1	2	0.637597E-07	0.428339E-07	0.299777E-07	

力の3成分は、直交座標を用いて表されているが、その座標系はもちろん結晶の並進ベクトルを取ったときの座標系である。

エネルギーの精度

ここで、電子エネルギー E_{el} の値は小数点以下12桁まで落ちている。そしてこの値は同じ計算条件で行えばどのマシンでもだいたい8桁以上までぴったり一致することに驚かれるのではないだろうか。しかし残念ながらこの桁がそのまま E_{el} の精度というわけではない。これはあくまで数値計算の上の安定性の問題で、 E_{el} の精度は別問題であるからだ。

E_{el} の精度が何で決まるかは難しい問題で、平面波カットオフエネルギーがこれしかじかの条件のとき E_{el} の誤差がかくかくしかじかになるという明確な判定基準があらかじめ予測できれば良いのだが、それを見つけるのが作者の悩みでもある。

数値計算における誤差の一般論から pwm の数値精度を評価してみよう。まず、 E_{el} の精度と言う場合、まず何をもって誤差というかがをはっきりさせなければならない。入力側にでは(i)入力データの誤差、そして計算中では(ii)計算機の数値精度、丸め誤算、(iii)近似誤差、例えば積分における離散化誤差(discretization error)が挙げられる。これらの誤差が計算中に増幅し、最終結果の誤差として現れる。これは誤差の伝播(error propagation)と呼ばれているものであり、数値的安定性(numerical stability)とともに数値計算上重要な概念である(詳しくは文献[29]の第一章で説明されている)。

まず、入力誤差として、結晶構造データや、ポテンシャルデータの誤差が考えられるが、ここではそれらは一切考慮せず、入力した数値きっちりの精度、すなわちFORTRANの倍精度で表されているとする。

(iii)の離散化誤差を評価してみる。全エネルギーの表式(1.22)には様々な項があり、それらを全て調べる必要はあるが、簡単のため、イオン-電子間相互作用の部分だけで代表させよう。それは実空間積分 $\int \rho(\mathbf{r})V(\mathbf{r})d^3\mathbf{r}$ で与えられるが、積分はもちろん有限和として評価される。一般に微小区間 $\{-h, h\}$ での積分 $\int_{-h}^h f(x)dx$ を単に $2hf_0$ として与えたときの相対誤差は、

$$\frac{1}{6} \frac{f''_0}{f_0} h^2 \quad (5.3)$$

で与えられる。積分 $\int \rho(\mathbf{r})V(\mathbf{r})d^3\mathbf{r}$ で、非積分関数は、ポテンシャルと、電荷密度で与えられるが、ここでは簡単にポテンシャルだけと考える(ρ は実効的ポテンシャルをより滑らかにする働きをすると考えられる)。Si結晶の場合、その積分はボンドの中心領域が支配するとして、そこでポテンシャルの値とその2次微分の値を使うと、式(5.3)の h^2 にかかる係数は ~ 0.05 と見積もられる。実空間でのメッシュ幅 h は格子定数を a_0 としたとき a_0/NADIM となる。Siでは $a_0 \sim 7$ であるので、NADIM=16の時、相対誤差は 1×10^{-2} と評価できる。NADIM=40でようやく相対誤差は 1×10^{-3} と一桁上がる。

実際に、Si結晶に対して、 E_{cut} を変えてみて、 E_{el} がどれくらい落ち着くかを見てみる。表5.1にその数値実験結果が出ている。

このように、NADIM=16では E_{el} は小数点以下2桁目が、NADIM=40では E_{el} は小数点以下4桁目が収束することがわかる(Ry/cell単位)。上の評価で使われた大胆な切り捨てを考えると、まあまあの予測一致といつていいだろう。式(5.3)によると、相対誤差は h^2 に比例するので、NADIMを3倍に取ることで1桁精度が上がることになる。しかしそれと同時に、 N_{pw} は三乗で増えるので計算負荷の方がより早く増大するということになる²。

いずれにせよ、式(5.3)に従うと、ポテンシャルの勾配が急になればなるほど、かつそこに電子密度集中していると(つまり電子がポテンシャルの谷間に局在していると)離散化誤差は大きくなる。その時は平面波数に関する収束は遅くなることになる。

空間の有限分割による誤差はこれでわかったが、では例えば $E_{\text{cut}} = 10$ [Ry] くらいでは小数点2ヶタ目以下の数字は信用できないのだろうか? 絶対値という点ではその通りだが、しかし前述し

²全エネルギー表式に現れる積分に対して、より精度の良いSimplonの公式を使うと少ない平面波により収束が早くできる期待がある。平面波の増大に伴う計算負荷を考えると、やってみる価値がある。

Table 5.1: Si における平面波数と E_{el} の関係

A_{max}	E_{cut}	N_{pw}	NADIM	E_{el}	ΔE	CPU time
2.1	4.959	59	8	1.171122727	0e+0	2
2.6	7.601	113	12	1.043273992	0e+0	10
3.1	10.806	169	16	0.991663345	-8.8e-16	35
4.1	18.903	377	20	0.979594976	0e+0	53
5.1	29.249	725	24	0.974301525	-1.7e-15	106
6.1	41.843	1243	28	0.973366347	0e+0	200
7.1	56.687	1949	32	0.973159222	1.7e-15	365
8.1	73.780	2896	40	0.973127119	0e+0	658

たように多くの場合興味ある物理量はエネルギーの差である。有限分割によるポテンシャル分布、密度分布もそれらを与えられたものとして考えるなら、それらは誤差ではなくなる。つまり展開平面波の数を揃えるならば、エネルギーの相対比較はもっと下の桁まで可能である。その場合どの桁まで信用して良いのであろうか？それはこの計算の数値的安定性が決める。つまり (ii) の計算機の数値精度、丸め誤算に伴う誤差の伝播がどれくらい最終的な結果に影響するかということだ。

文献 [29] を参考にすると、(簡単のため 1 变数関数で考え) 入力 x に対する最終結果 y は $y = \varphi(x)$ で計算されるが、入力 x の計算機精度による誤差 (浮動小数点誤差) を相対誤差 ε_x で表すと、出力の相対誤差 ε_y は

$$\varepsilon_y = \frac{x}{\varphi(x)} \frac{\partial \varphi(x)}{\partial x} \varepsilon_x \quad (5.4)$$

となり、式 (5.4) の $(x/\varphi(x))\partial\varphi(x)/\partial x$ は誤差の増幅率を表し、条件数 (*condition number*) と呼ばれている。この条件数を今の場合解析的に表すのは不可能だから、実験で評価してみる。具体的には、平面波数を固定し、原子配置 x をわずかに違えた系でのエネルギー比較 ($y = E_{\text{el}}$) をしてみる。Si₈ の結晶で、(0, 0, 0) 位置の原子を x 方向にわずかに動かしてみて E_{el} の変化を調べる。 $E_{\text{cut}} = 13.94$ [Ry] で $N_{\text{pw}} = 958$ と取る。その結果を図 5.3 に示す。この図からわからることは、位置のずれ u に対して非常に広範囲にわたり、条件数は 1 より十分小さく、数値的安定性があるということだ。位置の相対誤差 ε_u が 10^{-7} までの領域で全エネルギーについての相対誤差 ε_E との傾きから、 $\varepsilon_E \sim \varepsilon_u^2$ となることがわかる。これはもちろん平衡位置からのポテンシャル変化が調和近似になっていることの反映である。

こうして、pwm のプログラムは非常に数値的安定性が良いことがわかったので、条件さえ揃えておけば、先程の小数点 2 衔以下の数字でも十分意味があるということになる。但し今の Si の例は最も安定性の良い例と見るべきで、一般にはこれほどの安定性は望めない。だいたいにおいて収束性の悪いものは数値的安定性にも欠けると考えるべきだろう。

このエネルギー精度の問題は後で (6.1.3 節) また議論する。

5.2.3 再計算

一回の計算で十分な収束が達成されていないときは、今出力された波動関数を入力に返して再度計算する。出力ファイル pwm_*.wfn を inip_*.wfn とリネームし、pwm para の中の iread を 1 とセットする。これで再計算 OK である。

エネルギー評価

こうして得られた全エネルギーはどう評価したら良いだろうか。全エネルギーの定義は式 (1.22) で与えられているが、この式の中のポテンシャルは擬ポテンシャルで、電荷密度は

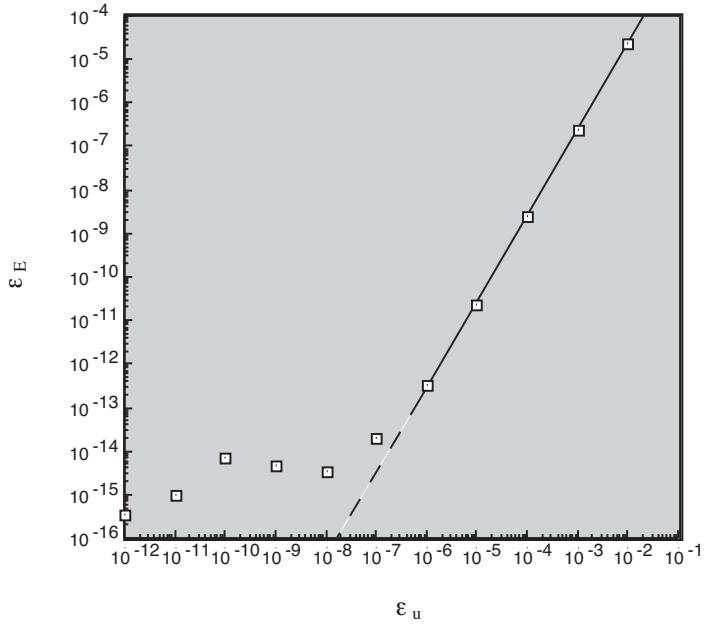


図 5.3: 原子位置に関する入力誤差 ε_u に対する、全エネルギーの出力誤差 ε_E

価電子のものである。従って、これから評価されるエネルギーは結晶のエネルギーといつても、内殻電子の寄与は全く入っていない。それでも物質の化学的性質はほとんどが価電子で決まるという擬ポテンシャルの精神にのっとり、様々な興味あるエネルギーはこの全エネルギーの差で計算できることになる。

代表的なものは、凝集エネルギー、形成エネルギーなどである。固体 A の凝集エネルギー $E_{\text{coh}}(A)$ は

$$E_{\text{coh}}(A) = E(A^{(\text{gas})}) - E(A^{(\text{sol})}) \quad (5.5)$$

で、また化合物 $A_m B_n$ の形成エネルギー $E_{\text{form}}(A_m B_n)$ は

$$E_{\text{form}}(A_m B_n) = mE(A^{(\text{sol})}) + nE(B^{(\text{sol})}) - E(A_m B_n) \quad (5.6)$$

で計算できる。ただし、形成エネルギーの場合は、固体どうしの比較なので問題はないのだが、凝集エネルギーの場合は、孤立原子と固体との比較になるので、交換相關エネルギーの取り扱いに問題が生じる。この問題の取り扱いにはたくさんの議論があるが、ここでは擬ポテンシャルによる初期の文献 [28] を一つ引用するにとどめる。この問題は擬ポテンシャル固有の問題ではなく、LDA そのものの問題である。

5.2.4 電荷密度の表示

計算が無事終わったあと、pwm が出力する初めての物理量は上でみた全エネルギーである。しかし前節で述べたようにエネルギーの絶対値は意味がないので、この値だけからこの計算がもっともらしいものかどうかを判断することはほとんど不可能である（なんだ、さんざん計算した揚げく解ることはたったこれだけかとがっかりするかもしれません）。計算がもっともらしいものかどうかは、大抵の場合は電荷密度分布を見ることで判断することになると思う。であるので電荷密度分布を可視化することは是非必要だ。

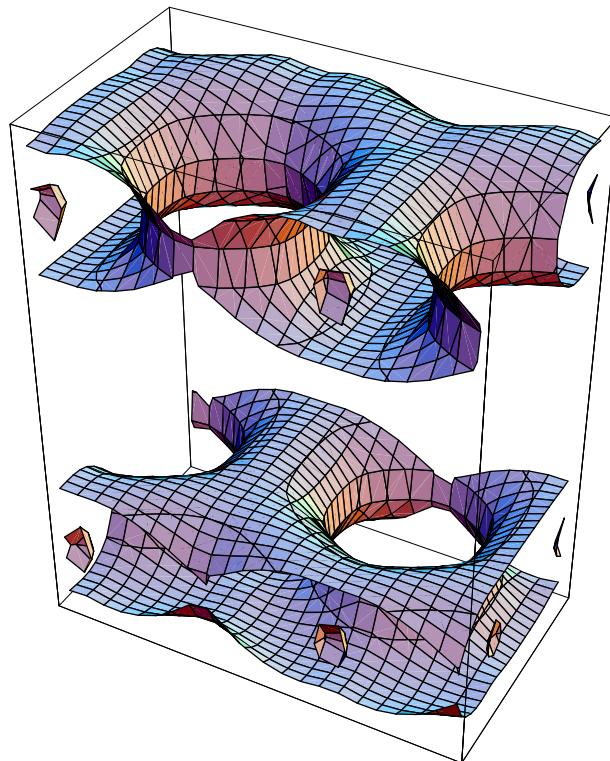


図 5.4: グラフアイトの等電荷密度面

実空間での全電荷密度の分布は `pwm_*.rho` に書き出される。データは、実格子の基本単位格子について、一方向について NADIM で一樣間隔で取られたメッシュ点で記述される。

`pwm_*.rho` のフォーマットは、最初にディメンジョンとして、実空間でのメッシュ数 NADIM が書かれ、以下電荷密度 $\rho(\mathbf{r}) = \rho(i, j, k)$ が、 i が一番内側、 k が一番外側のループで書き出される。

このデータの可視化には、Mathematica のノートブック `ChgDnst.nb` が使われる。入力として、結晶データ`*.prim`と電荷密度分布データ `pwm_*.rho` を用いる。その使用例として、3 次元の電荷密度をグラフアイトの計算例で図 5.4 に示す。

これから蜂の巣のボンドが層状にできていることがわかる。このように 3 次元の等電荷密度面図は差し当り電荷分布がどうなっているか素早く見たいとき有効である。

3次元の電荷密度は見掛け上アピールするものであるが、それに含まれる情報量はあまり細かくはない。むしろ2次元の切断面での等高線の方が結合の詳細を見るうえで必要である。その例が図5.5に示されている。今の入力データでは、 $z=1/4$ 面に2個のC原子が

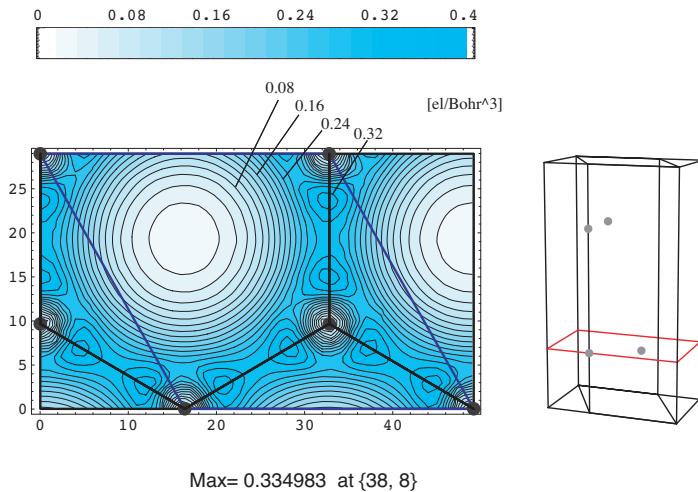


図 5.5: グラファイトの単位格子の $z=1/4$ 面での電荷密度分布

ある。太い線が基本単位格子の境界で、グレーの点が原子である。等高線は黒い方が電子密度が高くなる。このように原子間に強い共有性結合ができていることが読み取れる。

もちろん、この2次元の切断面での等高線は電荷密度の詳細を与えるかわり、文字通り全体の一面の情報しか与えないので、それ一枚だけを見たのでは「群盲象を評す」類になりかねないということは常に念頭に置くべきだ。

なお、この部分の出力に関してだけは、その重要性に鑑み、Mathematica のノートブック ChgDnst.nb の使い方を付録Aで説明する。

得られた電荷分布がもっともらしいかどうかの判断には、最終的には物理的素養が物を言う。というと、「予測が付かないから計算に頼んでいるのであって、予測が付くくらいなら計算などしない」と言われそうである。かくいう作者自身も実はどれがもっともらしいのか判断に苦しむことが度々である。そうなると、その先は「素養」が違ってもやることは皆同じである。パラメータを変えたり、類似物をいろいろ調べたりと、そこからが物理が始まるという他ない。³

電子相関が効いている場合はこの方法では所詮限界があることも覚えておかなければならない。何しろ我々は $\sim 10^{23}$ 個の原子を相手にしているのだから。これは問題の解決に何の助けにもならないが、Callaway が密度汎関数法についてみじくも述べている言葉を引用して締めくくる（文献[32]のp. 106）

これで（密度汎関数法のこと）多体問題が解けたと思ってはいけない。そのようなものは存在しない。もし誰かがそれを魔法のように成し遂げたとしたら、その時は物理は全くつまらないものになるであろう。

³類似物における電子分布の例をたくさん知っている人が、この世界では、所謂「専門家」と呼ばれ、少ししか知らない人が「素人」と呼ばれるのであろう。

5.2.5 収束がうまくいかない場合

大抵の場合今述べた方法で十分収束するが、そうならない場合にも遭遇するかもしれない。奇数の電子数の場合それが起こり得る。この場合、価電子バンドのトップが電子占有数が他のバンドのものと異なるため、共役勾配法における一次元最小化の過程で、放物線外挿法が成功する保証がなくなる。また本質的に準位間での準位交差が起こり収束が不安定になる要因になりうる。

この場合取るべき対処として、第 5.1.1 節で説明されたが、 k 点を倍にとり、一つは電子数は一つ増やし、もう一つは 1 つ減らすというダブル k サンプリング法がある。どちらの場合も電子数は偶数になり、奇数の問題はなくなる。これは絶縁体の場合有効である。

似たような状況は金属で起きうる。金属の場合、価電子上端のバンドはゾーンのどこかでフェルミ面が横切るので、 k 点ごとにそのバンドの占有数が異なる。これが収束が安定化しない原因となりうる。

この場合の対処法はケースバイケースで万能の対処法は無い。個々のケースでの対処法に頼らざるを得ない。ゆえにそれらの対処法は詳細となるので、場合場合についてテクニカルシリーズを参照していただくとして、ここでは著者の経験からの基本の方針について述べる。

まず最初に認識して欲しいことは、電子数が奇数であるから、あるいは金属であるからという理由で必ず不安定になるということは無いということである。収束の悪かったことを何でも奇数個電子数のせいにしてはいけない。著者の経験では最高電子占有状態に縮退があるとき問題が起き、縮退が無ければ奇数電子数あるいは金属ということはほとんど問題とならない。

そこで収束に問題が生じたとき、まずそれが KS 準位の縮退によって起きたものかを調べる必要がある。まず、インプットファイル pwm para で

```
allow_posE ON
```

とオプション指定し、エネルギーが多少増加してもエネルギー最小化過程を強制的に進めて、エネルギー変化がどうなるかを見る。⁴

ところで「状態が縮退」という場合、以下の事項に注意を払う必要がある。

- 縮退は対称性の理由により厳密に言うことができるものであるが、しかし数値計算の世界では数値だけが決め手である。数値には当然誤差があるので、縮退とはある数値範囲内での一致と理解される。
- 一つの k 点内の状態間での縮退だけでなく、異なる k 点での状態間での縮退もある。これらは通常バンド理論では縮退しているとはいわないが、今の場合では縮退である。

より具体的には pwm ではバンドを一本一本更新しているが、その間は占有数は固定しているので、エネルギー的に近いバンドではその線形最小化の過程での放物線外挿法がバ

⁴ というより、これによって初めてエネルギーが振動、発散したことがわかるのであり、そうしなければ振動したことさえも気づかないだろう。

ンドの順番を変えるかもしれない。放物線外挿法が失敗してストップした時点でそれが最低エネルギーを与えるものかどうか保証がない。

その他収束しない場合

以上述べた以外に収束がうまくゆかないことがあり得る。6.1.4節で詳しく議論するが、共役勾配方向を決めたとの一次元最小化が失敗する場合である。理論の1.7節で説明したが、一次元最小化は式(1.45)について実行される。このとき全エネルギーの θ 依存性は式(1.46)のように、 2θ の関数で与えらるとしているが、これはあくまで近似でもっと高次項も存在する。多くの場合この近似は良い近似だが[18]、時々悪い場合があり、その場合は必ずしも収束しない。全エネルギーのほとんどの項は密度の線形近似で十分であるが、交換・相関項は密度の低次のべき乗では与えられないので、時として(特に平面波数が極端に少ない場合)この項の変化が主要項となり、上の近似が破綻することが起こる。

5.2.6 関係するオプション

- diagonalize OFF
デフォルトでは価電子帯のつくる部分空間の中で行列を対角化するが、それをしない。
- allow_posE ON
エネルギー最小化過程の途中でエネルギーが増加する場合でも繰り返しを続ける。
- ran_wfn=
1
初期波動関数の型。デフォルトの1で乱数から作られる。特定の平面波だけから作りたいときはこれを0とセットする。
- vary_occ ON
占有数を可変とする。(デフォルトでは固定)
- energ_deg_Ef=
1.0E-4
縮退かどうかの基準値。
- nel_add=
1
電子を与えられた数だけ加える(減じる)。整数値。
- rnel_add=
0.9
電子を与えられた数だけ加える(減じる)。実数値。
- nband_extra=
1
バンド数をデフォルトより与えられた数だけ増やす。

- mix_occ=
 - 1.0D-1
占有数を可変としたとき、更新のときの古い値と、新しい値を混ぜ合わせる度合い。
(デフォルト値 1.)
- fermi_broadening ON
電子の占有数をフェルミ分布関数により与える。
- T_elec_start0fermi=
 - 0.1
フェルミプロードニングを掛けるときの初期電子温度。
- T_elec_end0fermi=
 - 0.1
フェルミプロードニングを掛けるときの最終電子温度。

このように多くのものは電子占有数の変化に関するパラメータである。これらの使い方の実例は Technical Report シリーズにある。関係するものは、

- No. 14 「電子数の制御 - エネルギーギャップへの応用 - 」
- No. 17 「半導体中の不純物準位」
- No. 37 「奇数個電子数の場合の電子占有数の扱い」

などである。

第6章 電子の基底状態計算 (II)

pwm で電子系の収束が達成した後、pwm でできることにいくつかの選択ができる。

6.1 原子位置の最適化

結晶の全エネルギー E_{tot} は原子の配置 \mathbf{R}_i の関数とみなせる。基本単位格子に N 個の原子があれば $E_{\text{tot}}(\{\mathbf{R}_i\})$ は $3N$ 個の変数の関数となる。原子の平衡位置はこのエネルギー関数を最小にする配置で求まる。ただし原子位置に関するエネルギー関数はいくつもの局所的極小値があることが知られているので、こういう場合に大局的な最小値を求めることは困難か、あるいは不可能となる。

ここでは線形近似での局所的な極小値の探索を行うことを目的とする。従って、極小位置は原子位置の初期値に依存することを念頭に置くべきである。多変数関数の極小値探索のアルゴリズムはいろいろあるが、ここでは線形近似の¹共役勾配法を用いる。pwm では Hellmann-Feynman 力、すなわちエネルギー関数の勾配が計算できるので、この方法が特に有効である。

共役勾配法の適用により、基本単位格子内の全ての原子を一度に動かし、構造の最適化を図ることができる。しかしながら pwm では、原子の変位は与えられた結晶の対称性を破らない範囲内で与えられる。つまりワイコフ位置は変わらない。従って、たとえば空間群 O_h^7 の Si 結晶では、2 つの原子が結晶の対称性により一意的に決められているので、この方法では全く動かないということになる。もちろん Si 結晶に対しても、対称性を落とせばこの方法が適用できる。

6.1.1 計算の準備

5.2.3 節のときの手続きと同様に前のセルフコンシスティント計算の結果 $\text{pwm-*}.wfn$ を用意し²、それから $\text{pwm}.para$ を編集する。

```
Job (0:SCF Calc. 1:Atom optimize 2:Cell optimize 3:Phonon 4:MDS)
1
.....
number of iteration for electrons (maxIter0wfn)
7
.....
```

¹これは、共役勾配が決定された後の一次元最小化は放物線による外挿を用いることを意味する。

²絶対必要というわけではない。初めから原子位置を動かす場合は、初期波動関数としてあまり厳密に収束させるより、ラフな収束あるいは全くランダムな初期波動関数からスタートする方が全体としては計算効率は良い。

```

ftol
8.0D-5
.....
Resume atom relaxation
0
max number of iterations for atoms (maxIter0atom)
4

```

と Job Type の選択を 1 とする。原子位置に対する共役勾配法の繰り返し数の上限 maxIter0atom を適当な値にセットする。また 1 回の原子位置に対する波動関数の収束までの繰り返し数 maxIter0wfn は波動関数だけのセルフコンシステント計算のときのように多く取る必要はなく、だいたい上の値くらいでよいだろう。初期波動関数として、前の結果を使うのであれば iread を 1 とする。しかし波動関数データファイルは inip_*.wfn とリネームすることも忘れずに。これで pwm を走らせる。

計算は原子位置に関する繰り返し回数が maxIter0atom を超えるか、残留原子間力が ftol (Ry/a_B) 以下になるかで終わる。

一度の計算で十分な緩和が行われなかったときは Resume atom relaxation を 1 とセットすると、前の計算で達成した原子位置を初期条件としてもう一度最小化過程を始める。このときの原子位置情報は pwm_*.var により引き継がれる仕組みにしてあるので、*.prim まで書き換える必要はない。引き継ぐためには pwm_*.var のファイルを inip_*.var とリネームする。波動関数のデータも前の出力 pwm_*.wfn を inip_*.wfn とリネームする。

6.1.2 結果の読み方

ここで、わざと原子位置を次のように少しずらした Si₈ 結晶を例に取り、原子位置の最適化の計算をしてみる。

POSITIONS RELATIVE TO A UNIT CONVENTIONAL CELL				TYPE	SYM(IG)
1	0.0200000	0.0000000	0.0000000	1	si 1
2	0.0000000	0.5000000	0.5000000	1	si 1
3	0.5000000	0.0000000	0.4900000	1	si 1
4	0.5200000	0.4800000	0.0000000	1	si 1
5	0.2500000	0.2500000	0.2500000	1	si 1
6	0.7500000	0.7500000	0.2500000	1	si 1
7	0.7400000	0.2500000	0.7100000	1	si 1
8	0.2500000	0.7700000	0.7500000	1	si 1

このように相対座標が小数点以下 2 ケタ目で平衡位置からずれている。

これに 5 回の共役勾配過程をかけてみる。

STEP	Etot	dele	resid	rsf	frgr	dx/at
1	-63.22541398	0.0000E+00	0.2255E-08	0.2446E-01	-0.1957E+00	0.0000E+00
2	-63.27071131	-0.4530E-01	0.7378E-09	0.5797E-02	-0.4506E-01	0.5911E-01
3	-63.27328165	-0.2570E-02	0.1119E-10	0.2139E-02	-0.1607E-01	0.1425E-01
4	-63.27383294	-0.5513E-03	0.1495E-10	0.1819E-02	-0.1077E-01	0.8547E-02
5	-63.27454325	-0.7103E-03	0.1223E-10	0.1662E-02	-0.8373E-02	0.1648E-01

リストは、原子位置に関する共役勾配法のステップ数、全エネルギー (Etot)、エネルギー変化 (delE)、残留波動関数誤差 (resid)、残留 Hellmann-Feynman 力の平均値 (rsf)、各ステップでの共役勾配の方向の Hellmann-Feynman 力成分 (frgr)、原子あたりの移動量 (dx/at) の順に出力される。全エネルギー、残留力、それに伴い原子移動量が順調に減少していることがわかる。

その結果原子の相対座標は

```
Relative coordinates in a conventional cell
 1   0.0034588   0.0012806   -0.0060836   1   si   1
 2   0.0033400   0.5016982   0.4951692   1   si   1
 3   0.5013677   -0.0003884   0.4929211   1   si   1
 4   0.5052825   0.4977746   -0.0068789   1   si   1
 5   0.2536370   0.2497403   0.2445048   1   si   1
 6   0.7548898   0.7498467   0.2436450   1   si   1
 7   0.7533980   0.2489169   0.7411160   1   si   1
 8   0.2546224   0.7511310   0.7456130   1   si   1
```

のように、小数点以下 3 ケタ目まで平衡位置と一致していることがわかる。

ここで Hellmann-Feynman 力に関して注意したいのは、Hellmann-Feynman 力を単位格子内全原子について足しあわせたものは 0 となることである（つまり内力の和は 0）。その結果、単位格子内の原子が動くときその重心は不变のままである。ということは、全原子を一様にずらしても良いということだ。もちろん 0 といっても、数値計算の場合は様々な要因で有限値となっている。であるので Hellmann-Feynman 力の和がどれくらい 0 からずれているかは計算精度のチェックになる。それはファイル pwm_*.frc に各原子に働く Hellmann-Feynman 力のリストのあと、

```
Check translational invariance
 0.4647E-05   -0.2650E-05   0.5672E-05
```

のように出力されるので、この部分を見ればよい。

6.1.3 力の誤差について

理想的にはこの極小値探索アルゴリズムにより残留 Hellmann-Feynman 力を任意の大きさまでに小さくできる。しかし実際には、残留力がある値まで小さくなると、それ以上計算を繰り返してもそれ以上小さくならない。50 ページの「エネルギー精度」の項で議論したように、数値計算上の丸め誤差などが最終的にこの誤差に効いてきている。

原子間の力定数 k を仮定すると、平衡位置の付近でのエネルギー変化 ΔE は $\Delta E = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$ で近似できるので、 $f = k\Delta x$ より、力の誤差は

$$\Delta f = \sqrt{2k\Delta E} \quad (6.1)$$

と与えられる。従って力の誤差 Δf はエネルギー誤差 ΔE よりも悪くなる。問題は全エネルギーの誤差 ΔE をどう評価するかである。「エネルギー精度」の項で議論したように、有限平面波数からくる離散化誤差を主要な誤差と見ると、 ΔE は比較的大きくなるが、平面波数を揃えて計算機の数値精度からくるものだけを考えれば、 ΔE は非常に小さくなる。

実際には、個々の計算での残留誤差の起因を明らかにすることは大変難しいので、残留力の値が飽和してきた時点で（あるいは飽和しなくとも計算が終わった時点で）、それが今の場合の数値誤差と見なすのが一番手っ取り早い。

残留 Hellmann-Feynman 力が Δf のとき、原子位置の不確定性 Δx は

$$\Delta x = \frac{\Delta f}{k} \quad (6.2)$$

で見積もられる。原子間の力定数 k はもちろん物によって違う。Si の場合であれば、動径方向の（すなわち伸縮）力定数は $k_r \simeq 0.3 \text{ [Ry/Bohr}^2]$ くらいだ。それで残留 Hellmann-Feynman 力が $1 \times 10^{-3} \text{ [Ry/Bohr]}$ のとき、位置の不確定性は $\Delta x \simeq 3 \times 10^{-3} \text{ [Bohr]}$ 程度ということになる。これは Si 結晶の相対座標では、小数点以下 4 ケタ目までの精度を意味する。一方それと垂直成分は、変角力定数 k_a だけが効いてくるとすると、変角力定数 k_a は k_r のせいぜい数% であるので、位置の不確定性は 100 倍くらい大きくなることになる。実際には結晶の場合、垂直成分が k_a だけで決まることはめったになく、別の方向からの k_r が効いてきて、結局値はそれらの中間になるだろう。したがって今の Si 結晶の場合は相対座標で、小数点以下 3 ケタ目までが保証されると考えればよい。

実際には、この Si_8 の場合は、「エネルギー精度」の項で見たように数値安定性が良い例で、先程の共役勾配法によって得られた原子配置から、再度同じ共役勾配法をかけると原子位置は 7 衡くらいまで精度を上げれる。しかしこの精度は他の物質では余り期待できないと思ったほうがよい。

6.1.4 収束に関する議論

全エネルギーの局所的極小の位置を求めるには共役勾配法は有効であることが知られているが、それでもいつでも成功するとは限らない。ここでは共役勾配法が失敗するいくつかの例を議論する。

理論のところで述べたように、ここで用いている最小化法は、各ステップでの共役勾配による探索方向を決めた後、その方向での 1 次元最小化を行うのであるが、それは単純な放物線近似の最小化法を取っている。すなわちその方向ではエネルギー関数は $E(x) = ax^2 + bx + c$ と仮定される。既にある原子位置 $x = x_0$ （一般性を失わずそれを原点に取れる）でのエネルギー E_0 とその勾配（すなわち力） $f = -E'(0)$ がわかっているので、あと一点 $x = x_1$ で関数の値 E_1 がわかれれば関数 $E(x)$ の形が決定できる。そして極小位置 x_{\min} は

$$x_{\min} = -\frac{b}{2a} \quad (6.3)$$

と決定される。ここに、 a と b はそれぞれ

$$\begin{aligned} b &= -f \\ a &= \frac{1}{x_1} \left(\frac{E_1 - E_0}{x_1} - b \right) \end{aligned} \quad (6.4)$$

で与えらる。従って、この方法は最小点を求める努力は最小で済むという利点を持っているが、その代償として放物線近似にしか適用できない³。幸い多くの場合、その近似はそ

³一般的な一次元関数の最小化のアルゴリズムはいろいろあるが、最小化にかなりの点の評価を取らねばならない。一次元での最小化に時間がかかりすぎると共役勾配法の利点は台なしになる。

んなに悪くないのだが、局所的極小が複数あることを反映して、この方法が適用できない場合が出てくる。

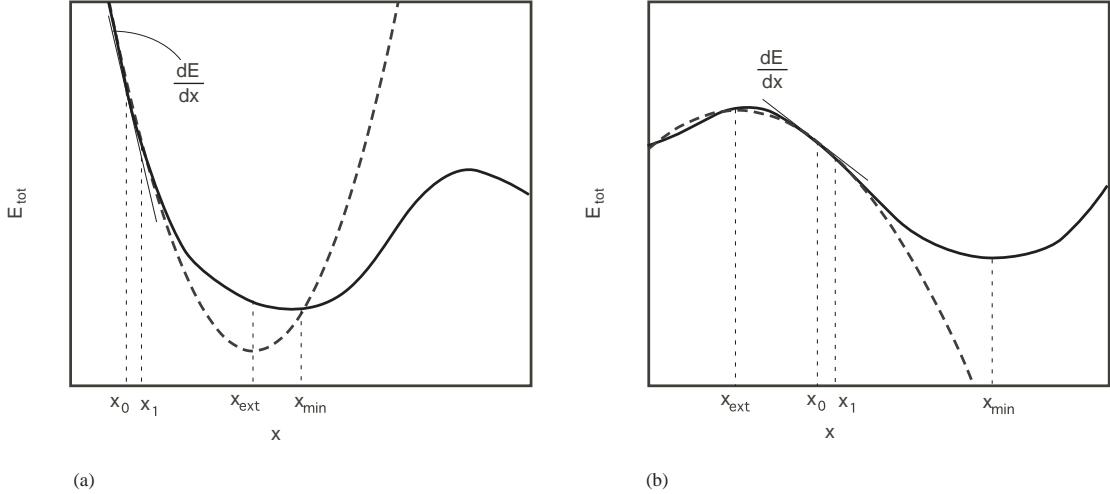


図 6.1: 放物線外挿が失敗する例。実線は真の断熱ポテンシャル。点線は放物線近似

例えば、断熱ポテンシャルが図 6.1(a) のようになっている場合がある。図からわかるように、 x_0 と $x = x_1$ からの外挿による極小点 x_{ext} は真の極小点 x_{min} から大きくずれている。それでも今度は x_{ext} を始点としてもう一度この線上で放物線近似の極小化をすればよさそうに見えるが、共役勾配法の特性として、一度探索した方向は二度と繰り返さないという思想であるので、 x_{ext} に達したあと、次の探索方向はそれとだいたい直角方向で、この方向での極小値には達することはできない。

もう一つどうにもできない場合は、断熱ポテンシャルが図 6.1(b) のようになっている場合で始点 x_0 ともう一つの試行評価点 x_1 がたまたま図のようになっている場合だ。この場合はこの放物線は上に凸な曲線と理解してしまう。上に凸な放物線には最小値はないので、この放物線近似ではどうにもできない。この場合、プログラムでは、 x_1 を新たな始点として、かつその点から共役勾配法を始めからやり直すようにしてあるだけである。

そのようなときは、本質的にこの方法では解決できない。 x_0 に対する試行評価点 x_1 までの距離を大きく取るとかして、何とか放物線近似が良いところまでいかなければならぬ。

このような場合に出くわした場合ユーザーができる（すべき）ことは、まず、一次元最小化過程が破綻したその方向に沿って断熱ポテンシャルがどうなっているか直接見ることであろう。それがもっとも確実な方法である。そのためにはソースコード `pw_relax.f` のサブルーチン `Atom_Optimize` を見る。そのサブルーチンの冒頭部分、変数宣言の部分に

```
LOGICAL :: step_flag=.FALSE. !step-by-step process
```

なる変数がある。この `step_flag` を.TRUE. とセットすると、pwm は原子位置に関する共役勾配過程を止め、与えられた原子変位方向に沿って、等間隔に点を取り全エネルギー変化を計算する。実際の計算は同じソースファイルのサブルーチン `Atom_Line_Step` で行わ

れるが、そのルーチンの中で、原子位置の単位変位、全ステップ数はそれぞれ `unit_dis`、
`u_it_max` で指定されているので、それを自分の目的に応じて設定すればよい。
 結果は `pwm-*sum` で

```
===== ION RELAXATION =====
...
STEP      Etot        delE      resid      rsf      frgr      dx/at
 1     -63.21392591   0.0000E+00   0.7951E-07   0.2444E-01  -0.1955E+00   0.0000E+00
```

の後、

STEP	Etot	delE	resid	rsf	frgr	dx/at
0	0.000000	-0.63213926E+02	-0.19549217E+00			
1	0.080000	-0.63228246E+02	-0.16235414E+00			
2	0.160000	-0.63239896E+02	-0.12886472E+00			
3	0.240000	-0.63248852E+02	-0.94986127E-01			
4	0.320000	-0.63255078E+02	-0.60610679E-01			
5	0.400000	-0.63258530E+02	-0.25618189E-01			

とリストされる。各行は、順に、回数、変位の大きさ u 、全エネルギー E_{tot} 、探索の方向の Hellmann-Feynman 力成分 f_s となっている。 $u - E_{\text{tot}}$ の関係の微分が f_s を与えるので、そうなっているかもチェックする。

いずれにせよ、原子数が多くなっても、原子位置に対する共役勾配のステップ数 (`maxIter0atom`) はせいぜい 5 回くらいにしておくのが賢明である。

6.2 格子定数の最適化

原子位置に対する最適化と同様の原理で、pwm ではストレスが計算できるので、格子定数の最適化を計ることができる。格子定数はストレスが 0 となるように自己調整する。原子位置の最適化の場合の、力に相当するものがストレステンソル σ_{ij} で、変位に相当するものが歪みテンソル ϵ_{ij} である。

6.2.1 計算の準備

前の原子位置に関する最小化の時と同様に、初期波動関数 `inip-*sum.wfn` を用意し、`pwm.para` を編集する。

```
Job (0:SCF Calc. 1:Atom optimize 2:Cell optimize 3:Phonon 4:MDS)
2
atom movement (0: OFF, 1: ON  valid only when cell optimization)
0
.....
Resume cell relaxation
0
max number of iterations for cell (maxIter0cell)
2
```

まず Job Type を 2 にセットし格子定数の最適化プロセスを起動する。このとき同時に原子位置も動かすかどうかの設定を次の行で行う。

格子定数に関する共役勾配プロセスの最大繰り返し回数を `maxIter0cell` にセットする。
 計算は格子定数に関する繰り返し回数が `maxIter0cell` を超えるか、残留ストレスが `stress_tol` (デフォルト値 2×10^{-5} (a.u.)) 以下になると終了する。

一回の計算で十分な格子緩和が行われなかった時は、Resume cell relaxation を 1 とセットして再計算する。このとき前の計算で達成された格子定数、原子位置の情報は pwm_*.var で格納され、そこから読み込まれるので、結晶データファイル*.prim を書き換える必要はない。

6.2.2 結果の読み方

ここでは、nontrivial な例として三方晶の α ホウ素（空間群 D_{3d}^5 ）を見てみる。初期の格子定数は、

```
LATTICE PARAMETERS in a.u.
 9.5563443   9.5563443   9.5563443
 0.5290309   0.5290309   0.5290309
```

と実験値を与えている。

それに対するストレスは

```
total stress (Ry/Bohr^3)
  S(1,1)= -3.88638E-04    S(2,3)= 2.30327E-10
  S(2,2)= -3.88636E-04    S(3,1)= -3.87469E-18
  S(3,3)= -9.38125E-04    S(1,2)= -3.37167E-18
```

という結果を与えている。

結果は今の場合、ファイル pwm_*.sum を見るのが良い。その中で

```
===== LATTICE MODIFICATION =====
```

の見出しを見つける。その後に格子定数最適化の条件が記述されている。

```
use Conjugate-Gradient Method
convergence criterion for stress 2.000E-05
Max iteration 3
Symmetry constraints on the cell 3
  0: triclinic, 1: monoclinic, 2: orthorombic, 3: tetragonal, 4: cubic
under pressure = 0.00000 (GPa) = 0.000E+00 (Ry/Bohr^3)
```

その後に続くのが格子定数に関する共役勾配法の計算過程である。

```
IC      Etot0      Etot      del_E      epmin      res stress      its sea comp
 0     -68.47157622 -68.47157622  0.000E+00  0.000E+00  0.109E-02  0.641E+00
 1     -68.47157622 -68.47982412 -0.825E-02  0.248E-01  0.328E-04  0.132E-01
 2     -68.47982412 -68.47983356 -0.944E-05  0.781E-03  0.244E-05 -0.643E-03
 3     -68.47983356 -68.47983356  0.000E+00  0.781E-03  0.244E-05  0.138E-02
      iteration stop
      because the change in E  0.00E+00
      became less than that allowed by RSstress  2.00000E-05

<<<<<< final results <<<<<<<<<<<<<<
STEP      Etot      dele      resid      rsf      rfm
100     -68.47983356 -0.8715E-08  0.7725E-10  0.5726E-04  0.2039E-03
Etot= -6.84798336E+01 (Ry/cell)
          -9.31717578E+02 (eV/cell)
```

ここでは、簡単のためヘッダー IC に続く箇所のみを抽出してある。IC が格子定数に関する共役勾配のステップ数である。それに続いて、各ステップでの初期の全エネルギー (Etot0) 終点のエネルギー (Etot) エネルギー変化 (del_E) 最小点の歪み位置 (epmin) 残留ストレスの大きさ (res stress) その共役勾配方向の成分 (sea comp) が表示される。

ステップが進むにつれ、全エネルギー、残留ストレスが小さくなっていく様子がわかる。

この結果、格子定数は最終的に

```
The final lattice parameters
  9.38527485      9.38527485      9.38527485
  0.52019576      0.52019576      0.52019576
```

となる。

最後に、残留ストレスのリストが打ち出される。

```
total stress (Ry/Bohr^3)
  S(1,1)= 1.33098E-06    S(2,3)= 1.39142E-10
  S(2,2)= 1.33137E-06    S(3,1)= 2.91728E-18
  S(3,3)= 1.69774E-06    S(1,2)= -1.92993E-18
```

初めのストレスと比べて 2 行小さくなっていることがわかる。

6.2.3 収束に関する議論

格子定数の最適化における収束の問題は、原理的には原子位置の最適化におけるそれ（第 6.1.3、6.1.4 節）と同じである。何か問題の起きたときは、原子位置に関するときと同じように、探索方向での一次元での断熱ポテンシャルを調べることが一番確実である。

ソースコード pw_cellrelax.f のサブルーチン Cell_Optimize の中の変数宣言部分で

```
LOGICAL :: step_flag=.FALSE. !step-by-step process
```

という変数を見つける。この step_flag を.TRUE. とすることで探索方向のスキャンを行う。実際のスキャンは同じファイルのサブルーチン Cell_StepByStep で行う。格子定数のステップ幅、ステップ数は、このルーチンの中でそれぞれ unit_step、nstep で与えられるので、適当な値に設定する。

結果は pwm_* .sum で見出し

```
===== LATTICE MODIFICATION =====
```

以下の部分を見る。

```
e= 0.00000000  Etot= -15.80512513  ssd1= 0.00153912
e= 0.00200000  Etot= -15.80511615  ssd1= -0.01048361
e= 0.00400000  Etot= -15.80508321  ssd1= -0.02244878
e= 0.00600000  Etot= -15.80502655  ssd1= -0.03430808
e= 0.00800000  Etot= -15.80494640  ssd1= -0.04610712
e= 0.01000000  Etot= -15.80484299  ssd1= -0.05779727
```

と、歪み (e) に対する全エネルギー (Etot) 、与えられた歪みの方向でのストレス成分 (ssd1) の変化をリストする。e-Etot をプロットしどういうふうにエネルギーが変化する

か、また `ssd1` は $e\text{-}E_{\text{tot}}$ の一次微分を与えるはずですので、そうなっているか確認する。

格子定数の精度は、すなわち歪みテンソル ϵ_{ij} の精度で与えらるが、弾性定数 C_{ijkl} を用いると、それは残留ストレス σ_{ij} と

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl}\epsilon_{kl} \quad (6.5)$$

の関係にある。誤差の評価のためには弾性定数のかわりに体積弾性率 (Bulk modulus) を用いれば十分だろう。

例として、先程の α ホウ素の場合の格子定数の数値精度を評価してみる。残留ストレスが $\Delta\sigma \approx 10^{-6}$ [Ry/Bohr³] である。体積弾性率 B は仮に Si と同じくらい $B = 100$ [GPa]、つまり 6.8×10^{-3} [Ry/Bohr³] とする。すると格子定数の数値精度は $\Delta\epsilon \approx 1.5 \times 10^{-4}$ 、つまり 0.01% くらいということになる。

平面波の選び方 格子定数を動かす場合、原子位置の最適化と違って特別の注意が必要である。それは平面波カットオフ半径についてである。同じカットオフ半径 k_c を用いても、格子定数が動くと、それに含まれる平面波の数が異なってくる。展開する平面波の数が異なってくると、エネルギー変化に不連続なジャンプが生じる [35]。明らかにこのような人為的なジャンプは 1 次元最小化を行うとき不都合となる。このため、pwm では格子定数の最適化を行うとき、最初与えた k_c によって選ばれた平面波のセットをそのまま通り続ける。これにより平面波数が変化することによる不連続点は避けることができる。一方、それは格子定数が変化したとき、正しい平面波の選び方をしていないという問題も持ち合わせている。

このあたりは、妥協を選んでいる。すなわち、歪みが小さい場合は、初期の平面波のセットを用いることによる誤差は無視できるであろうと考える。結果として歪みが大きく、最終的な格子定数が初期のものに比べて大きく異なるときは、改めてその点から計算をやり直すという考え方をする。ではどれくらい異なったときそうすべきかは、当然物、状況によるが、だいたい格子定数の変化で 10% くらいと思えば良いと思う。

6.2.4 圧力依存性の取り方

pwm はさらに静水圧下での格子定数の最適化も行う。pwm.para で

```
pressure_GPa=
 10.0
```

とオプション設定をする。外部圧力は GPa 単位で入力する。正の値が加圧で、負の数字が減圧を意味する。

pwm は内部ストレスが、この外部圧力と同じになるまで共役勾配法を繰り返す。このオプションは、結晶構造の圧力依存性、相転移に応用できる。

6.2.5 関係するオプション

- steepest_atom_relax ON

- steepest_cell_relax ON

原子位置にしろ、格子パラメータにしろその最適化では、デフォルトでは共役勾配法が適用されるが、自由度の数が小さいときは必ずしもそれが一番有効的な方法というわけではない。ときとして最急勾配法がより良い場合もある。その時は上のように最急勾配法を選ぶことが出来る。

- pressure_GPa=

1

格子パラメータの最適化の際、外部圧を加えたいとき用いる。

- trial_step0atps=

0.001

原子位置の最適化の一次元最小化において、放物線近似をするための試行変位の大きさ u_1 。ボーア単位。

- trial_step0cell=

0.001

格子パラメータの最適化の一次元最小化において、放物線近似をするための試行歪みの大きさ ε_1 。

第7章 電子構造スペクトル

セルフコンシスティント (SFC) 計算が終了すると、バンド計算、DOS 計算などが可能となる。これらの計算を行う時ブリルアン・ゾーンが具体的にどうなっているかの知識が必要で、例えば FCC のブリルアン・ゾーンは図 7.1 のようになっていることを知っていないといけない。それは文献 [24]などを参照していただく。ブリルアン・ゾーンを自分で描きたいのであれば Mathematica のノートブック MakeBZ.nb で書ける。

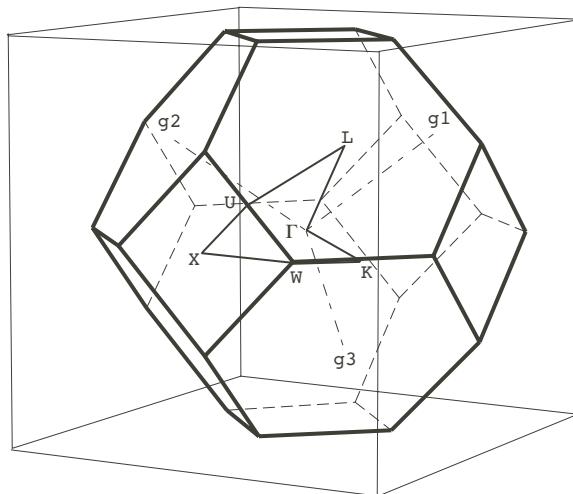


図 7.1: FCC のブリルアン・ゾーン

バンド計算、DOS 計算などはプログラム pwbcd で計算する。pwbcd に関する入出力ファイルの関係は図 7.2 のようになっている。計算の後のデータを表示するためのプログラム ayband、pdosdr は柳瀬章の作成によるものを用いている（入力部だけ Osaka2k に合わせている）。まずそれらの計算の元となっているセルフコンシスティント電荷のデータ pwm_*.rho が必要である。 k 点サンプリングのデータ inip_*.kpt などは必要ないが、ポテンシャルデータ型を規定する inip_*.inp が必要となる。バンド計算、DOS 計算とも同じ入力ファイル bcd.para を使うが、中身が違うのでそれぞれ band.para、dos.para として作っておき、計算する時 bcd.para とリネームして使うのが便利である。

7.1 DOS 構造

7.1.1 準備

DOS 計算用の入力ファイル bcd.para は

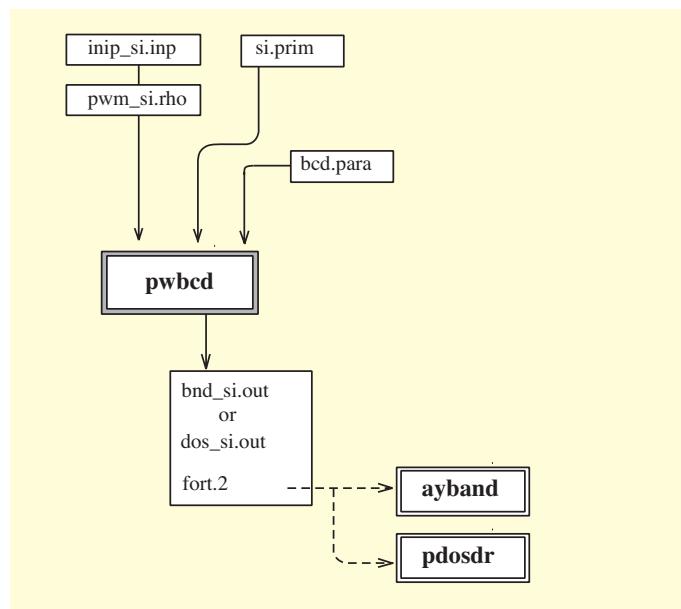


図 7.2: pwbcd 計算プログラムの流れ

```

JobType
dos
Input file name
si.prim
number of division (nkdiv)
8
number of levels you want to draw (NBUP) usually NEPC
12
scan zone only (iscan)
1
print control (ilp)
1
use symmetry (isymm)
1
energy unit (ienun=0 for Ry, 1 for eV)
0

```

となる。

以下そこに現れるパラメータの意味を挙げる。

JobType	ジョブタイプ = dos
xtl.name	結晶名
nkdiv	k 線の分割数
NBUP	描くバンド数
iscan	デバグのためのオプション。1 : デフォルト
ilp	プリントオプション 1 : デフォルト
isymm	対称化オプション 1: 対称化する、0: しない
ienun	エネルギー単位 0: Ry、1: eV

ここで一番重要な入力は DOS を計算するときのゾーンの分割数である。それを nkdiv に入力する。計算に取り入れるバンドの数 (NBUP) は平面波の数 (NHDIM) より小さければ何でも良いのだが、典型的には価電子バンド数の 2 倍、つまり基本単位格子あたりの電子数を取ればよい。しかしアルカリ金属のように基本格子あたりの電子数が 1 とか 2 の場合は、あまりにもバンド数が少なくなるので、少し多めにとっておいたほうが良い。

他のパラメータは主にデバッグ用であるので上の例のままで良い。

pwbcn は DOS 計算結果を dos_*.tbl あるいは fort.2 に出力する。それをプロットするには、簡単には線スペクトルそのままの dos_*.tbl を Mathematica のノートブック DOSshow.nb に掛ければ良い。より高度な処理として、既約表現ごとに分けられた線スペクトルデータ fort.2 を pdos (最新バージョンは pdosdr) に掛け、tetrahedron 法 [36] により滑らかな DOS 曲線を得ることができる。なお pdos は柳瀬により作成されたものである。

DOS 計算における k 点の取り方は、基本逆格子 G_1, G_2, G_3 で作られる平行六面体を、一様に nkdiv 分割する。例えば nkdiv=4 とすると、 G_1 方向には G_1 単位で、

$$0, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{2}{4}, \quad \frac{3}{4}$$

と 4 点取られることになる。Monkhorst-Pack の k サンプリングの時と異なり、ゾーン中心から始まることに注意。それらのうちブリルアン・ゾーンの外にはみ出たものは、自動的にその中に折り返される。また対称性で結ばれる点は消され、平行六面体は既約ゾーンに縮小される。従って最終的に決められた k 点には重みがつくことになる。

pwbcn はそれらの k 点、一点一点でハミルトニアンを対角化し固有値を下から並べて出力する。対角化の際、対称化オプション isymm=1 としてあると、あらかじめ平面波は対称化される。

最後に全電子を下のレベルから順番に詰め、フェルミレベル E_F を割り出す。

SGI pwbcn では、SGI マシンではコンパイラーオプションを付けるとき、オプティマイズレベルは基本レベル (-O) 以上に上げないようにして欲しい。TSPACE がときに壊れことがある。また、-static も付けたほうが安全だ。

7.1.2 DOS 構造の結果

DOS スペクトルの結果は dos_*.tbl あるいは fort.2 に書き出される。その結果を見る前に、計算条件がファイル dos_*.out に書かれているので、まずそれをチェックする。見出し

```
===== The calculation parameters =====
```

の後には計算条件がリストされる。それに続いて見出し

```
===== K space segmentation =====
```

の後には k 点サンプリングに関する情報があるで、確認すること。上の入力の場合、初めに 8 点作られるが、対称性により次の 3 点

Number of sampling points (NKPTS)							
No	NM	C	P	DK	Nstr	WTK	in/out
1	GM	0 0 0/ 2	0 0 0/ 4	0.0000	1	0.12500	1
2	L	-1 1 1/ 2	2 0 0/ 4	0.1688	4	0.50000	2
3	X	0 0 2/ 2	2 2 0/ 4	0.1949	3	0.37500	2
sum check over wtk =				1.000000			

にまで簡約される。 k 点の名前、conventional、primitive base の表現が与えられた後、その大きさ (DK)、星の数 (Nstr)、重み (WTK)、ゾーンの中か外かの指標 (TSPACE 参照) と並べられる。

その後、 k 点一点一点について、平面波を対称化して、既約表現ブロックごとに對角化する過程が記述される。前にも触れたが、pwm を始めとする「OSAKA2000」のプログラム群は基本的に primitive base で書かれており、対称化するために conventional base で書かれた TSPACE サブルーチンをコールしているため、その間の変換、逆変換が何度も挿入されている。それが正しく進行しているか途中経過のモニターをしている。一般ユーザーは無視してもらって結構である。

最後にフェルミレベル E_F を探索して締めくくる。

```
===== determin Ef =====
Determine the Fermi level
                           energy --- (eV)
Fermi energy =      6.2896
                  at 1 th-kpoint    0 0 0 / 4
Total piled up number =   8.000000
                           Number of electrons = 8
Sorting of HOMO
Valence Top:      6.2896 at 1      2 2 0 / 4
Sorting of LUMO
Conduction Bottom: 7.1785 at 3      0 0 0 / 4
Gap=      0.8889     from 0 0 0 / 4 to 2 2 0 / 4

final distribution of the valence bands
      kn   IP2 - IP3          E2 - E3          Occ2 - Occ3
      1     3   3 - 4       3.17028 - 3.17028    2.00000 - 2.00000
      2     2   3 - 4       4.91918 - 4.91918    2.00000 - 2.00000
      3     1   2 - 4       6.28963 - 6.28963    2.00000 - 2.00000
      Ef= 6.28963     nv= 3     kf= 1     del_n= 0.00000

Nel=     8.0000
Ef=     6.2896
```

刻まれたメッシュの分解能の中でエネルギーギャップも求められている。ギャップは 0.8889 [eV] でそれは、(000) の価電子帯上端から、(220)/4 の伝導帯下端までということが示されている。

次に価電子帯上端の電子占有状態が示される。Si では価電子帯は 4 本ある。従って縮退していなければ 4 番目のバンドが最上位占有バンドということになる。縮退がある場合は 4 本のうちいくつかが最上位占有バンドと見なされる。上のリストで、IP2 から IP3 までのバンドが最上位占有バンドである。E2 と E3 はそれぞれのエネルギーレベルである。この例では全て完全にエネルギーが等しく厳密に縮退しているが、前述したように、エネルギーがぴったり一致しなくとも、差が ERESO 以内であれば縮退しているとみなされる。この IP2 から IP3 までのバンドは均等に電子が割り振られる。

また、電子がそれぞれの k 点の IP3 まで占有して全電子数が期待通り 8 個となっている

かを Nel でチェックする。最後にフェルミレベルの位置が出力される。

7.1.3 表示

DOS 構造を図示したい場合 2 つの選択がある。

(i) 線スペクトル

簡単には線スペクトルデータ dos_*.tbl をそのままプロットすることである。このファイルは

```
1      -5.885658      0.125000
1      6.289627      0.125000
...
2      -3.384971      0.500000
...
```

というように k 点の番号、エネルギーレベル、 k 点の重みをリストしている。Mathematica の DOSshow.nb はこのデータを読み、各線を適当な幅の Gaussian 分布に直し、全ての分布を重ね合わせて DOS を描く。その例を図 7.3 (a) に示す。

メッシュが荒いと見せかけの突起点がたくさん出るので、van Hove 特異点を探すときは、 k 点のメッシュをかなり細かく刻まないとわからないことが理解できる。¹

(ii) tetrahedron 法

tetrahedron 法 [36] はサンプリング点間のバンドを内挿して DOS 曲線を滑らかにする。pdos は pwcdb の出力ファイル fort.2 を読み込んでこのことを実行する。² fort.2 のファイルフォーマットは 7.2.2 節で説明されるが、pdos で読み取られるように出力したものである。pdos はもともと別のバンドプログラム用だったので、DOS を書かせる考え方方が若干違う。一番大きな違いは、いつものように pwcdb が primitive base の k 点サンプリングをしているのに対し、pdos は conventional base のものであることだ。両者が一致する場合は問題ないが、FCC 格子などの場合はユーザーがその間を調整する必要がある。³

先の Si の例だと、pwcdb では k 空間のメッシュを primitive base で 2 分割した。G₁、G₂、G₃ が直交軸でないため、conventional base での (000) と (001) の他、(111)/2 とその半分の点も現れた ($2\pi/a$ 単位)。一方、pdos は conventional base であるので、直交軸 a*、b*、c* を一様分割する。そのためここで分割数を 2 とすると、上の 3 点以外に、(100)/2、(110)/2 などが現れる。これらの点に関しては pwcdb はサンプリングしていないので当然エラーとなる。

従って pdos では分割数は半分の 1 とすべきである。この場合 pdos 側では、サンプリングとして、(000)/1、(100)/1、(110)/1、(111)/1 の 4 点と取る。対称性により、(111)/1 は (000)/1 と、(110)/1 は (100)/1 とそれぞれ等価となる。ということは pwcdb の 3 点のうち 2 点のみのデータを使い、(111)/2 のデータは無駄になるということだ。このあたりは

¹ この点に関して柳瀬先生から御教示いただいた。

² 最新版は pdosdr である。これに関しては、スピンを入れた場合への拡張など記すべき事項が多くある。それらは部分 DOS の書き方との関係で Technical Report No. 61 を参照されたい。

³ この点での詳細は、Technical Report No. 83 「Osaka2k における pdosdr の使い方 – k 点メッシュの切り方 –」を参照のこと。

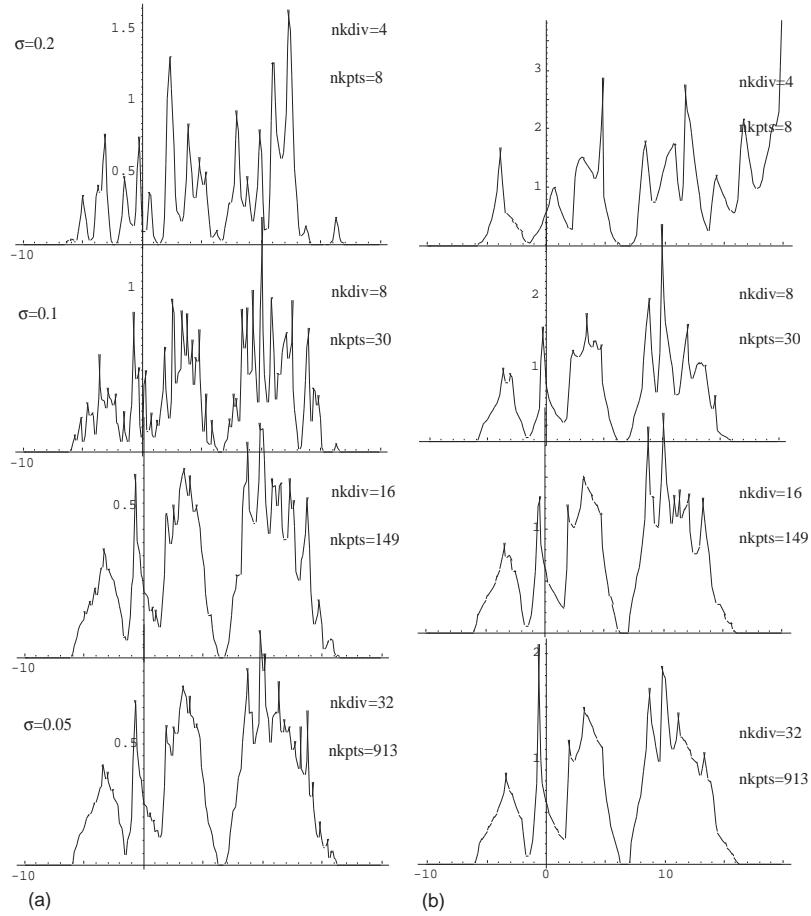


図 7.3: Si の DOS。 (a) 線スペクトルを Gaussian でぼやかした例。 (b) tetrahedron 法で滑らかにさせた例。

不合理だがどうしょうもない。

使い方は、まず入力ファイル pdos para を以下のように用意する。

```
NONMSPIN-ORBIT
1 1 1
0
-10.0 20.0 0.2
8
```

初めは磁性に関するもので、今の場合上のようにする。次の 3 つの数字が k 空間の分割数、NX、NY、NZ である。上で注意したように pwbcd の分割点と整合性を持たせる。次の数字は 0 とする。DOS を軌道による成分表示をするときに使う数字なので今は関係ない。次に来る 3 つの数字は、エネルギーの下限 (ESTART) 上限 (ENEND) 一つのセグメントの幅 (DE) である。従ってエネルギースペクトルの点数は (ENEND-ESTART)/DE+1 で与えられる。最後の数字はセル内の全電子数である。

出力ファイル fort.12 は

```
SPIN 1
 1 -10.0000   0.000   0.0000
 2 -9.8000   0.000   0.0000

150  19.8000   1.689  27.1343
151  20.0000   1.438  27.4481
electron number= 8   EF= 6.8000000000000000
```

のように最初と、最後のコメント行に挟まれ、線スペクトルデータがリストされる。各行はエネルギー・メッシュの番号、エネルギー、DOS の値、そのエネルギーまでの DOS の積分値の順でリストされる。

このデータはやはり Mathematica のノートブック PDOSshow.nb で図示化できる。fort.12 の最初と最後のコメント行を外し PDOSshow.nb に持っていく。図 7.3 (b) に例が示される。メッシュ点の数が少ない場合も DOS 曲線は滑らかになることがわかる。それでも van Hove 特異点を正確に求めるにはやはり多くのメッシュ点が必要であることには変わりない。

7.1.4 フェルミ面

金属の場合は、pwbcd の出力からフェルミ面を描くことができる。図 7.1 にあるように、pwbcd は出力ファイル dos_*.sum を出力するが、これはファイル fort.2 と違い、既約表現ごとではなく k 点ごとのバンドレベルを出力する。これを Mathematica ノートブック MakeFE.nb に読み込ませ、また dos_*.out に出力されるフェルミレベルを入力することでフェルミ面を描く。もっともこの作画プログラムはフェルミレベルを単なる入力パラメータとして扱っているので、フェルミレベルでなくとも、与えられたエネルギーでの等エネルギー面を描くことにも使える。

図 7.4 には、Al のフェルミ面の例がでている。表示は、第一ブリルアン・ゾーンにだけでなく、拡張ゾーンで描いた。作画には少し時間がかかるが、ショッちゅう使うのでなければ我慢できる。本当はこのフェルミ面に図 7.1 のようなブリルアン・ゾーンが重ね書きされるとわかり易いのだが、Mathematica の使い方の問題で今のところそれはうまくいっていない。図 7.1 のブリルアン・ゾーンと比較してみると、バンド 2 はゾーンの内と外で、球形の殻でなっていることがわかる。

7.2 バンド構造

pwbcd は指定された k 空間上の線（多くは対称線）に沿ってバンドを計算する。それらの線は一筆書きされるように取る。結果の表示には DOS の場合と同じく、2 通りの仕方を用意している。ひとつには、 k 点に対して対称性を抜きにしてバンドレベルを書き並べたファイル band_*.tbl を使うもので、それは簡単な XY プロッティングプログラムで図示化することができる。もう一つがプログラム ayband を用いたより高度な処理で、バンドを滑らかに描くことができる。ayband はその出力を PostScript ファイルとして出力する。これで Illustrator などで読むことができる。

なお ayband は柳瀬章により作成されたものである。

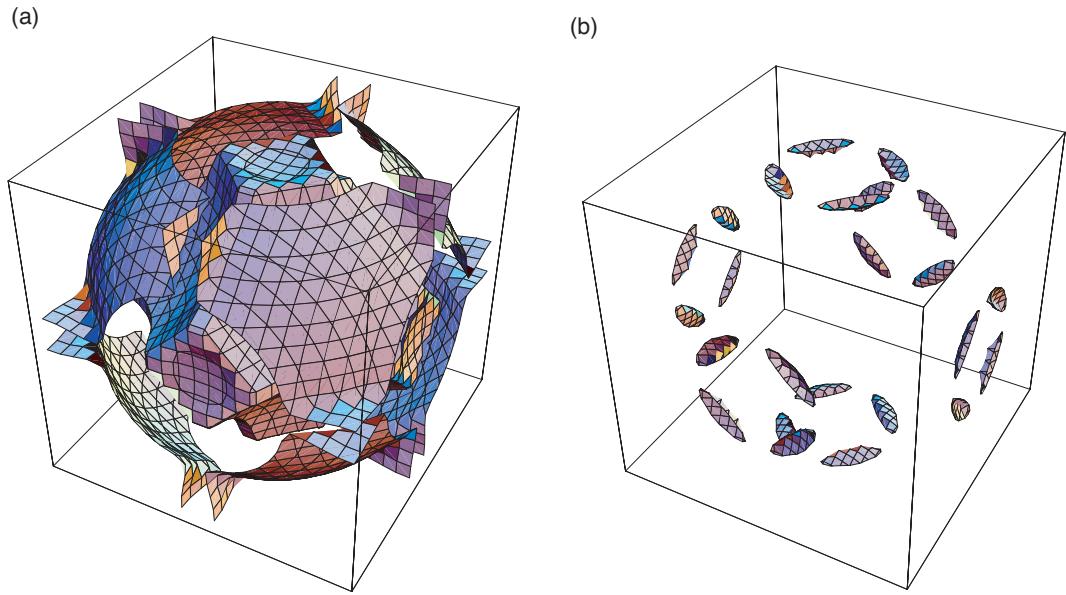


図 7.4: Al のフェルミ面。a) バンド 2。(b) バンド 3。

7.2.1 準備

バンド計算では bcd para は

```

JobType
bnd
Input file name
si.prim
number of k points specifying symmetry lines (NKPTS)
7
KB(3), ICB (in prim)
0 0 0 1 G
3 3 6 8 K
1 1 2 2 X
1 2 3 4 W
1 1 1 2 L
0 0 0 1 G
0 1 1 2 X
number of division per line (NDIV)
5
number of levels you want to draw (NBUP) usually NEPC
12
scan zone only (iscan)
1
print control (ilp)
1
use symmetry (isymm)
1

```

のようになる。

以下そこに現れるパラメータの意味を挙げる。

ここで一番重要な入力はバンドを描く対称線の指定である。pwbcd はバンドを描くときゾーンを一筆書きすることを前提としている。したがって、描く径路は

$$A \rightarrow B \rightarrow C \dots$$

JobType	ジョブタイプ = bnd
xtl.name	結晶名
NKPTS	バンドを描くときの対称線の数
KB, ICB	対称線の両端の k 点
NDIV	各対称線上の分割数
NBUP	描くバンド数
iscan	デバグのためのオプション 1 : デフォルト
ilp	プリントオプション 1 : デフォルト
isymm	対称化オプション 1 : 対称化する、0 : しない

となり、ノードの数が NKPTS で、以下ノードの k 点が KB(3)/ICB に primitive base で与えられることになる。この例では、 $L - \Gamma$ 、 $\Gamma - X$ 、 $X - W$ 、 $W - K$ 、 $K - \Gamma$ の 5 本の対称線が取られることになる。⁴NDIV には一本一本の対称線の分割数を入れる。

NBUP に描きたいバンドの数を指定する。DOS を計算するときと同様に、単位格子あたりの電子数くらいで良いが、それが 1 とか 2 くらいのときは少し多めに取る。ここでどのバンドまで描くかについて述べなければならない。DOS のときもそうだが、use symmetry を 1 にセットすると、各 k 点で、各対称ブロックごとにバンドを NBUP だけ計算し、積み上げる。であるので NBUP が少ないと、ある対称線から別の対称線に移ったときエネルギーが上のバンドが消えることがある。その時はこの NBUP を増やす。

後のパラメータはデバグ用なので、上の値のままで良い。

7.2.2 バンド構造の結果

pwbcd は指定された線に沿ってバンドを計算し、ファイル bnd_*.tbl および fort.2 に結果を出力する。しかし結果を見る前に DOS 計算のときと同じく、計算条件が正しく反映されているか、bnd_*.out で確かめておくのが良い。

手っ取り早くバンド図を見たければ、bnd_*.tbl を二次元プロッティングプログラムにかけるのが良い。そのフォーマットは

```

1   -0.248790244660327
1   -6.646822029304370E-002
...
2   -0.289100855937076
...

```

というように、 k 点の番号の後、エネルギーがリストされるのでプロッティングは容易である。その例は図 7.5 に示される。横軸は $L - \Gamma - X - W - K - \Gamma$ の順で各線が 5 分割でプロットされている。対称性に関する情報が欠けているだけでなく、点の集まりとして表されているので隣の点同士のつながりは人間の手で書かなければならない。今の例ではそれはそう難しくないが、バンド数が密集してくると横のつながりは簡単ではなくなる。ゾーン境界でのバンドの曲り具合も微妙で、メッシュ点の数を多くしてもなかなか難しい

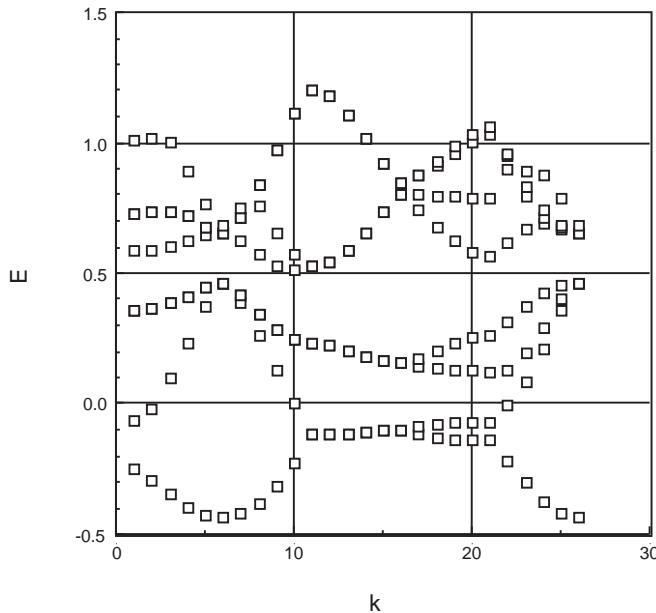


図 7.5: Si のバンド図。band の出力点をそのままプロットしているだけ。

ものである。

こうした問題は、バンドの対称性、ゾーン境界における異なる表現間の可換関係を利用すると解決される。これを行うのがaybandである。aybandは既約表現に従って各バンドをspline曲線で滑らかにつなぐ。またゾーン境界での曲りにも気を配っており、それが k について1次あるいは2次になるかを、わざわざゾーン境界を越えた点まで延長して調べている。

同じ既約表現ブロックに属しているバンドは「基本的」には交わらない(準位の不交差)のでaybandは、例えば一般点ではバンドが如何に近づこうが絶対交わらないように分散曲線を引く。プログラムとしてこの処置には、著者は不満はないが、概念的にそれが絶対正しいのか著者は今一つ確信が持てない。2つの縮退した準位は、その間に如何に小さくとも相互作用があれば、その縮退は解ける。しかし同じ既約表現ブロックに3つ以上の準位があるときでも絶対、縮退がないのかというと著者は確信を持っていない。「偶然縮退」というものがあっても良いと思うのだが。「偶然縮退」については、過去いろんな人が議論しているが、例えばHerringはゾーン内に「偶然縮退があったとしたなら」それはどういう状況になるか詳しく論じている[37]。しかしそれは「偶然縮退があった時」そうなるというもので、あるかどうかは問題にしていない。ともかくもaybandで描く限り「偶然縮退」は存在しないことになる。

aybandの入力ファイルとして k 点での小群の既約表現ごとにバンドレベルを分類したものがファイルfort.2である。

⁴柳瀬先生によると、もっと賢い取り方(対称線を全て通る)は、 $\Gamma \rightarrow K \rightarrow X(1,1,0) \rightarrow W \rightarrow L \rightarrow \Gamma \rightarrow X(1,0,0)$ と取ることである。

データは k 点ごと、一つの k 点については、その小群の既約表現ごとにブロックに分けられ出力される。その一つのブロックは次のようになる。

```
1      5   5   5   10   1   L   2   1   1   5  
2.793676    5.247479    6.851224    7.409376    8.271489
```

始めの数字は通し番号で、次の 4 つの数字で k 点が表されている。この例では $(5, 5, 5)/10$ 、つまり L 点となるが、この表現は conventional base のものである。次がスピンに関係した制御数 (IUD) で、 k 点の名前が続く。

残りの 4 つの数字は、順に既約表現番号 (MRN)、表現の次元 (MWET)、 k の星の数 (NST)、このブロックに属する固有値の数 (NEIG) となっている。

そして改行して、個々の固有値が小さい順に NEIG 個だけ並べられる。

この fort.2 を使って ayband はバンド図を描く。

ayband はもともと汎用のバンド図作成プログラムである。そのため様々な作図指示用のパラメータがある。それがファイル fort.3 に書き込まれる。その中身は

```
NONMSPIN-ORBIT  
0 0 50          NLCOMP NSPIN IFILE  
0 1 12          JPR     JMARM IPOINT(character)  
-1.0 1.2 100.0 150.0  
5  
4 4 4 8 0 0 0 8 LD  
0 0 0 8 8 0 0 8 DT  
8 0 0 8 8 4 0 8 W  
8 4 0 8 6 6 0 8 K  
6 6 0 8 0 0 0 8 SM  
0.5            Fermi level  
Si PseudoPotential
```

となる。上から順番に

MAGNET 磁性状態。pwm では NONMSPIN-ORBIT のみ有効。

NLCOMP, NSPIN, IFILE 角運動量による成分分解の数。スピン状態。これらはいずれも 0 とする。IFILE は出力ファイルの番号

IPR, JMARM, IPOINT 最初の 2 つは出力制御パラメータ。上の例のようにする。IPOINT はバンド図の中の表現ラベルの文字の大きさ。

E0, EM, YM, XM プロットするときの、エネルギー最小値、最大値、y 軸、x 軸スケールの大きさ (mm 単位)

NAXM 次の描こうとする k 空間上の線の数

線の指定 線の端点 k_1, k_2 により指定。 k は 3 つの分子とその後の共通分子で表される。以下これが NAXM まで繰り返される。端点の名前は便宜上のもので読まれない。

EF フェルミレベル

TITLE 図のタイトル

このように `ayband` では改めて、`pwbcd` とは独立にバンドを描く線を指定する。

図 7.6 にはこのようにして得られたバンド図を示す。

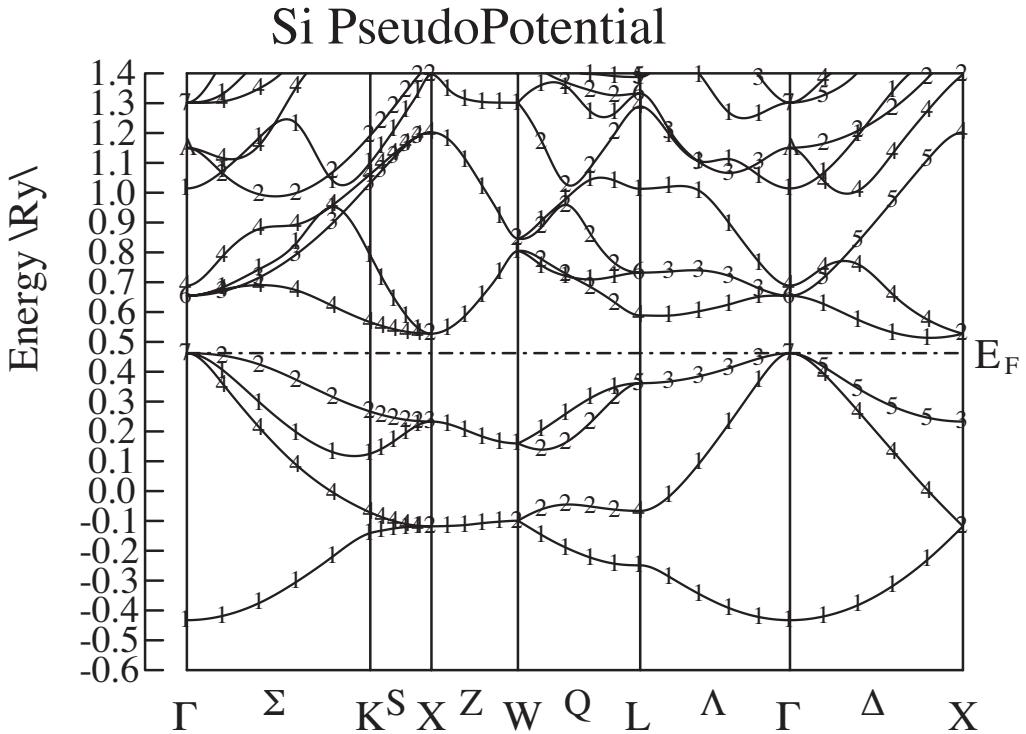


図 7.6: `ayband` を用いた Si のバンド図。 k 点間の長さも正しく与えられていることに注意。

このようにバンド線がスムーズに描かれ、ゾーン境界でのつながりも明確になった。

図中の番号は既約表現の番号であるが、それは TSPACE が機械的にかってに付けたものである。従って、よく文献で見かける既約表現のラベルと比較する時、その対応を調べる必要がある。

`ayband` は時間反転に関して縮退するものは、一方の既約表現の番号のみしか表示しない。例えば、閃亜鉛型の GaAs などでは (T_d^2) Δ 軸上の既約表現 3 番と、4 番のバンドは時間反転対称性のためくっつくが、`ayband` はラベルとして 3 のみを付ける。したがってバンド数、縮退度を見るときこの点注意が必要である。

このとき話をややこしくしているのが、文献の指標表が、通常の既約表現（ベクトル表現）のものと、射線表現（ray, projective, or multiplier representation）のものがあることだ。著者はどちらかというと、古い文献がベクトル表現で、新しいものが射線表現になっている印象を受ける⁵。TSPACE は射線表現になっている。作者の印象としては、固体のバンド計算論文ではベクトル表現のラベルが用いられるほうが多いと思うので（多分

⁵ベクトル表現の例が Koster[38] だが、230 の空間群全てを尽くしているわけではない。全てを網羅して

Koster のもの [38] が一番参照されているのではないかと思う) それとの対応について説明する。

TSPACE は既約表現の完全なリストを出力することができる (サブルーチン TSIRDS)。前述しましたように TSPACE の出力する表現は射線表現 $D(\alpha)$ である。それは元の、 k の小群のベクトル既約表現 $\Gamma(\alpha)$ に、位相因子を掛けたもの

$$D(\alpha) = \exp(i\mathbf{k} \cdot \tau_\alpha) \Gamma(\alpha) \quad (7.1)$$

となっている。ここに τ_α は回転 α に付随する格子周期を持たない並進 (nonprimitive translation) である。この $D(\alpha)$ 表現は、ゾーン内の対称線上では nonprimitive translation に伴う余計な位相因子が取り除かれ、点群の表現との対応が取り易くなるが、ゾーン境界では混乱の原因となり得る。

非共型 (nonsymmorphic) 空間群の具体例 Si で示すと、 Δ 軸上では、サブルーチン TSIRDS は

```

IMR NO 1 DIMENSION= 1
      1 2192227284042
1 1 + + + + + + +
IMR NO 2 DIMENSION= 1
      1 2192227284042
1 1 + + + + - - -
IMR NO 3 DIMENSION= 1
      1 2192227284042
1 1 + + - - + + - -
IMR NO 4 DIMENSION= 1
      1 2192227284042
1 1 + + - - - + +
IMR NO 5 DIMENSION= 2
      1 2192227284042
1 1 + - I J 0 0 0 0
2 2 + - J I 0 0 0 0

```

と出力する (ファイル fort.15)。この表では小群に含まれる全ての要素に対しての行列要素がリストされる (見やすいうように対角成分のみ抽出している)。この中の記号 (要素番号や指標の値) は TSPACE[24] 参照のこと。この射線表現の指標をクラスごとに見やすくしたものが表 7.1 の左側である。

これを見ると、射線表現 $D(\alpha)$ では、点群 C_{4v} の表現との対応が明白となる。一方通常の表現 $\Gamma(\alpha)$ では、半端な複素数 η が指標に現れる。 $k \rightarrow 0$ の極限を取ればこれは 1 となるので点群 C_{4v} の表現との対応を取るのにそんなに困難はないが、半端な複素数が現れない分、射線表現の方がすっきりしている。

しかし、非共型のゾーン境界では話はそう簡単ではない。表現が一次元の場合では点群と等価 (射影等価) となり点群の表現が使えるが、射線表現では指標に複素数が現れ通常の点群の指標表との対応が取りにくくなる。

2 次元以上の表現ではもはや対応する点群は存在しない。多分一番複雑なのは X 点だろうから、それを示す。その射影表現は

いるものは、射線表現のもので、Kovalev[39]、Bradley Cracknell[40] によるものがある。しかし後者は完全とはいえ、初心者 (著者も含まれる) が、その中から目的とする既約表現表を取りだすのは相当の忍耐が必要だ。そしてせっかく得られた既約表現のラベルも結局 TSPACE と同じく単なる機械的数字にしか過ぎない。少なくとも著者には Mulliken や BSW 記法の方が親しみ易い。

Table 7.1: Δ 軸上の既約表現指標表。左が射線表現 D 、右がベクトル表現 Γ のもの。二行目が回転に付随する非基本格子ベクトル $\tau = (1/4, 1/4, 1/4)$ を示す。左の第一列目が TSPACE の既約表現番号を示す。

D		E	C_2	$2C_4$	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$	Γ		E	C_2	$2C_4$	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$
				τ	τ					τ	τ		
1	Δ_1	1	1	1	1	1	Δ_1	1	1	η	η	1	
2	Δ'_1	1	1	1	-1	-1	Δ'_1	1	1	η	- η	-1	
3	Δ_2	1	1	-1	1	-1	Δ_2	1	1	- η	η	-1	
4	Δ'_2	1	1	-1	-1	1	Δ'_2	1	1	- η	- η	1	
5	Δ_5	2	-2	0	0	0	Δ_5	2	-2	0	0	0	

$$\eta = \exp[-i\mathbf{k} \cdot \tau]$$

```

IMR NO 1 DIMENSION= 2
 1 2 3 4161819222526272840424346
 1 1 + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
 2 2 + + - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - + +
IMR NO 2 DIMENSION= 2
 1 2 3 4161819222526272840424346
 1 1 + + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + +
 2 2 + + - - 0 0 0 0 0 0 0 0 + + - -
IMR NO 3 DIMENSION= 2
 1 2 3 4161819222526272840424346
 1 1 + - + - J I J I 0 0 0 0 0 0 0 0
 2 2 + - - + J I I J 0 0 0 0 0 0 0 0
IMR NO 4 DIMENSION= 2
 1 2 3 4161819222526272840424346
 1 1 + - + - I J I J 0 0 0 0 0 0 0 0
 2 2 + - - + I J J I 0 0 0 0 0 0 0 0

```

とでる。

前と同じように、指標表として書き並べると、表 7.2 の左側のようになる。

Table 7.2: X 点の既約表現指標表。左が射線表現 D 、右がベクトル表現 Γ のもの。指標が全て 0 となる要素は省略してある。左の第一列目が TSPACE の既約表現番号を示す。

D		E	C_{2x}	$2C'_2$	$2\sigma_d$	Γ		E	C_{2x}	$2C'_2$	$2\sigma_d$
				τ						τ	
2	X_1	2	2	0	2	X_1	2	2	0	2	
1	X_2	2	2	0	-2	X_2	2	2	0	-2	
4	X_3	2	-2	$2i$	0	X_3	2	-2	2	0	
3	X_4	2	-2	$-2i$	0	X_4	2	-2	-2	0	

前述したように、Koster[38] などの表では通常の既約表現しかでていないので（表 7.2 の右側）、式 (7.1) により通常の表現 $\Gamma(\alpha)$ に戻した指標を pwcdb の出力ファイル fort.18 に書き込んだ。そこには各点の既約表現の指標がリストされている。

```

11   1 th point =      40   0   0/  40    X   2       1.0000   0.0000   0.0000
Characters
#IR=  1      ND=  2      MG= 16
JG=      1      2      3      4      16     18     19     22     25     26     27     28
Re=    2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

```

```
Im= 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
JG= 40 42 43 46  
Re= -2.00 -2.00 0.00 0.00  
Im= 0.00 0.00 0.00 0.00
```

このように点群操作の番号とともにその指標が実部と虚部に別れて出力される。それと文献の指標表と照らし合わせて通常のラベルに直せばよい。この作業（群の要素番号の参照と指標の読み込み）はいささか疲れるが、そこまでやれば他人が読める立派なバンド図となる。

7.3 波動関数のプロット

実空間で波動関数をプロットさせたいときがある。Osaka2k では 2 種類の方法を提供する。それらは [42] を参照。

付 錄 A 結晶のMathematicaによるグラフィックス表示

A.1 グラフィックス座標の取り方

初めに述べたように、「OSAKA2000」のグラフィックス出力はほとんど Mathematica のノートブックに頼っている。その中で電荷密度を描く ChgDnst.nb に関して最低限のことを述べておく。本文では電荷密度分布の 2 次元へのマッピングを強調したが、その 2 次元の切断面の取り方についてである。波動関数の表示も同じだ。どちらにしろこれらの Mathematica ノートブックはパカチョンの使い方を想定してはいない。基本的にはソースコードの解読を前提としている。

ここでは trivial でない例として、单斜晶に属する結晶、 α 型酸素結晶を取り上げる。空間群は C2/m で、底心格子 (C-center) での結晶形は図 A.1 (a) に示されている。

基本的に、Mathematica では（多分他のグラフィックスプログラムでもそうだと思うが）密度分布は等方的、かつ直交している立方体メッシュを用いて描かれる。それゆえ斜交軸で表された結晶では、非常に面倒な変換が必要だ。ユーザーはその面倒な変換を知る必要はないが、自分が得たい切断面をどう指定するかを知らねばならない。それはどのような商用のプログラムでもそうで、結局座標系に対する理解なしではどうにもならない。

ChgDnst.nb では、セクション 2. Construct crystal structure までのところで実空間結晶は以下のように記述されている。まずセクション read *.prim の中で、

```
file = OpenRead["name.prim"]
```

と結晶データ*.prim を読み込むので、結晶ファイル名を入力する。

長さの単位は $\{a_0, b_0, c_0\}$ のうち一番大きいもの (Å 単位で a_{max}) に取られる。

- 基本単位格子は三つの基本並進ベクトル $\{t_1, t_2, t_3\}$ で表される（ノートブック中で $\{t1, t2, t3\}$ ）。
- 簡易単位格子は三つの基本並進ベクトル $\{t_{c1}, t_{c2}, t_{c3}\}$ で表される（同 $\{tc1, tc2, tc3\}$ ）。
- さらに Mathematica で図示化するためこのセット全てを含むグローバル領域を取る。グローバル領域の基本ベクトル $\{gp_1, gp_2, gp_3\}$ は必然的に直交デカルト座標系である（同 $\{gp1, gp2, gp3\}$ ）。

そのデータにより、ChgDnst.nb は図 A.1 (a) に示されるように、基本単位格子と簡易単位格子を描き、それら両方を含む直方体領域を取る（これを仮にグローバル領域と呼ぼ

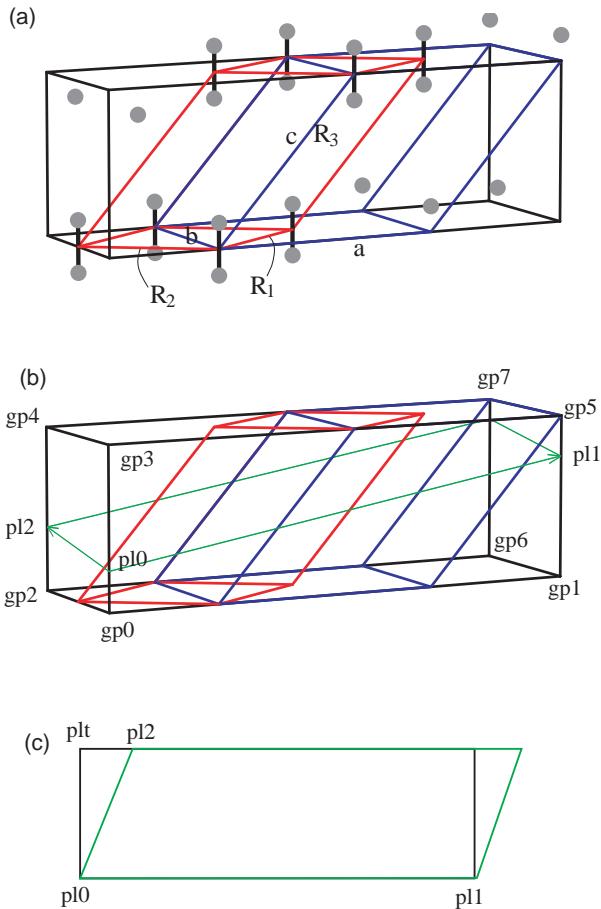


図 A.1: 結晶構造から 2 次元切断面の切り方。(a) α 型酸素結晶の基本単位格子(赤線)と慣用単位格子(青線)、いずれをも含む直方体を描く。(b) 切断面(緑線)は 3 点、pl0、pl1、pl2 で指定される。(c) 2 次元電荷密度分布は pl0、pl1、plt で張られる長方形の中で描かれる。

う。それらの各頂点の 3 次元座標は、gp0、…、gp7 と名付けられる(同図(b))。以下の座標系はこのグローバル座標系で記述されることになる。

この座標系で

- 基本単位格子の中の基本構造をつくる N_{atom} (`natom`) 個の原子の位置は `ba[i]` で表される。
- 三つの整数の組で表わされる格子は、`lattice` で

```
lattice[l_,m_,n_] := N[l t1+m t2+n t3]
```

で与えられる。しかしながらその内のいくつかは以下のようにシリアル番号で識別されている。

```
lattice[0]=lattice[0,0,0];
```

```

lattice[1]=lattice[1,0,0];
lattice[2]=lattice[0,1,0];
lattice[3]=lattice[0,0,1];
lattice[4]=lattice[1,1,0];
lattice[5]=lattice[0,1,1];
lattice[6]=lattice[1,0,1];
lattice[7]=lattice[1,1,1];
lattice[8]=lattice[-1,1,1];
lattice[9]=lattice[1,-1,1];
lattice[10]=lattice[1,1,-1];
lattice[11]=lattice[1,-1,0];
lattice[12]=lattice[1,0,-1];
lattice[13]=lattice[0,1,-1];
lattice[14]=lattice[2,0,0];
lattice[15]=lattice[0,2,0];
lattice[16]=lattice[0,0,2];

```

かつ

```
lattice[-#]=-lattice[#];
```

となる。

- したがって結晶中の原子位置は関数 atomPos により

```
atomPos[l_Integer,j_Integer]:=lattice[l]+ba[j]
```

となる。

以上が主要な変数のリストである。

ところで結晶の図で、今述べた gp0, ..., gp7 で作られる領域内にクリッピングしてしまうと、今の酸素結晶の場合、O₂ 分子の半分しか見えず、分子構造が見えにくくなる。そのため原子や最近接ボンドに関してはこれより少し広い領域で取る必要があるが、このあたりは物によって違うので、ユーザーがノートブックを解読して制御してもらうということに委ねたい。

その後、セクション read data file で

```
file = OpenRead["pwm_name.rho"]
```

と電荷密度分布のファイルを入力し、データを読み込む。この後、ChgDnst.nb は density statistics の見出しの後、

```

{ro3min, atmin}
{0.234258, {1, 1, 35}},

{ro3max, atmax}
{247.381, {12, 58, 56}}

```

と電荷密度の最大と最小値を割り出す。

3 次元の等電荷密度面は、先程の直方体のグローバル領域でのメッシュ点でデータを内挿しながら描かれる。ユーザーは最後のプロットコマンドの

```

Timing[ grf = ContourPlot3D[ fulst[l,m,n],
{ l,igxmin,igxmax}, {m,igymin,igymax}, {n,igzmin,igzmax},
Contours->{80}, PlotPoints->{8,4} ] ]

```

の中で、Contours のパラメータを、先程の電荷密度の最大と最小値をにらみながら、適当な電荷密度の値を入れるだけで済む。図 5.4 の 3 次元等電荷密度面はこのようにして、gp0, ..., gp7 で作られるグローバル領域内で描かれたものである。

次に、2 次元の切断面は、2 つのベクトルで指定する。同図 (b) のように、それは 3 点、 pl0, pl1, pl2 で指定される。この点の指定には、点 gp0, ..., gp7 を用いた相対座標を用いるよう薦める。すなわち、pl0 を線分 gp0-gp3 の 1/4 の点に取りたければ、

$$\vec{pl0} = \frac{3\vec{gp0} + \vec{gp3}}{4} \quad (A.1)$$

と取る。

このベクトルで作られる領域は一般には長方形ではないので、同図 (c) のように改めて pl0-pl1 と直角方向に plt が取られる。同図の黒の領域が最終的なプロット領域になる。ChgDnst.nb ではこの領域と、単位格子の混ざる交線や、あればその面上の原子も描く。その例が図 5.5 で示される。

A.2 電荷密度分布

実空間の電荷密度分布データ `rod.r` はデータ量が必要最小限になるよう、基本単位格子内の空間点でのみ与えられる。そして基本単位格子空間を `{na1, na2, na3}` で分割し、その「格子点」での電荷密度の値で与えられる。その規格化因子は

$$N_{el} = \sum_{i=1}^{NA3} \rho_i \times \frac{1}{NA3} \quad (A.2)$$

と取ってある。 N_{el} が基本単位格子中にある電子数である。

電荷密度分布データがノートブックに取り込まれた後、密度データは加工される。考慮すべき点が 2 点ある。

まず、密度分布のプロットなどほとんどの解析のためには、密度は直交座標空間での格子点で与えられないととても解析が複雑になる。一方で元となる基本単位格子は一般には直交座標ではない。たとえ結晶が立方晶で会ったとしても FCC や BCC の場合は基本単位格子はもはや立方体ではない

まず、密度分布のプロットなどほとんどの解析のためには、密度は直交座標空間での格子点で与えられないととても解析が複雑になる。一方で元となる基本単位格子は一般には直交座標ではない。たとえ結晶が立方晶で会ったとしても FCC や BCC の場合は基本単位格子はもはや立方体ではない

もう一つが、密度データは基本単位格子空間の中だけで展開されているので、3 次元空間の一般点の密度を求めるとき、その点を基本単位格子空間の等価な点に引き戻さなければならない。

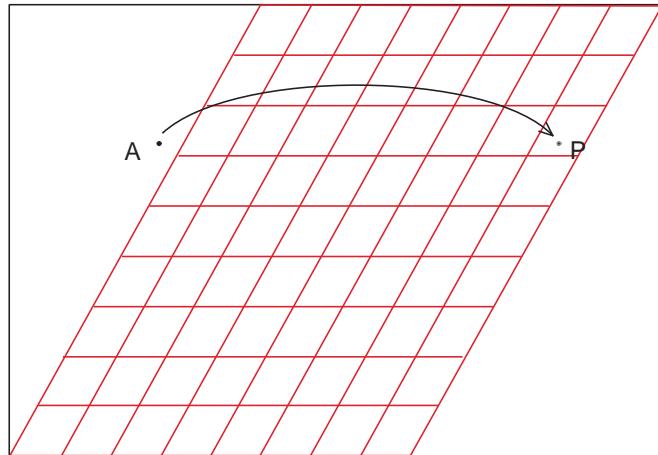


図 A.2: 電荷密度分布における座標変換。基本単位格子は赤線で示されている。電荷密度データはその「格子点」で与えられている。黒枠はグローバル領域。直交座標で与えられた点 A は基本単位格子空間の等価な点 P に引き戻される。

以上の要請から、3次元直交座標系から、電荷密度分布が与えられている基本単位格子空間との座標変換が必須である。その関係が図 A.2 で示されている。

その座標変換をし、ある点の密度を計算するものがノートブックの関数

`fd[l_,m_,n_]`

である。により参照する。この関数は3次元空間の任意の一点の電荷密度を与える。電荷密度を求めたい空間点 A は直交座標で $\{l, m, n\}$ で与える。その座標を図 A.2 に従い、 $\{na1, na2, na3\}$ 分割の基本単位格子空間内の等価な点 P に引き戻す。この P 点は一般には基本単位格子空間の「格子点」にはなっていないので、その電荷密度の値はその近くの「格子点」上の電荷密度から内挿する。その内挿値を `fd` は返す。

3次元や2次元切断面での電荷密度分布は全てこの `fd` を通じて描かれている。

謝辞

本プログラムを開発するに当たり、先駆者の貢献については序論の歴史で述べた。ここではそれ以外の人の貢献について述べたい。プログラム開発には、実践でのテストが必要不可欠だ。その意味では、特に、開発途上のプログラムで仕事をしてくれた二人の学生、藤田洋士、山崎勇治君には試験台になってもらって、ここにその貢献に対して感謝したい。

References

- [1] P. Hohenberg and W. Kohn, Phys. Rev. **136**, B864 (1964)
- [2] W. Kohn and L. J. Sham, Phys. Rev. **140**, A1133 (1965)
- [3] J. Callaway and N. H. March, *Solid State Physics* **38**, (1984) p. 135
- [4] R. O. Jones and O. Gunnarsson, Rev. Mod. Phys. **61**, 689 (1989)
- [5] *Adv. in Quantum Chemistry* **21**, S. B. Trickey ed., (Academic, San Diego, 1989)
- [6] D. M. Ceperley and B. Alder, Phys. Rev. Lett. **45**, 566 (1980)
- [7] J. P. Perdew and A. Zunger, Phys. Rev. B **23**, 5048 (1981)
- [8] V. Heine, *Solid State Physics* **24**, (1970) p. 1, and all the volume.
- [9] D. R. Hamann, M. Schlüter, and C. Chiang, Phys. Rev. Lett. **43**, 1494 (1979)
- [10] N. Troullier and J. L. Martins, Phys. Rev. B **43**, 1993 (1991)
- [11] L. Kleinman and D. M. Bylander, Phys. Rev. Lett. **48**, 1425 (1982)
- [12] G. B. Bachelet, D. R. Hamann, and M. Schlüter, Phys. Rev. B **26**, 4199 (1982)
- [13] N. W. Aschcroft and N. D. Mermin, "Solid State Physics", (Holt-Saunders, Philadelphia, 1976)
- [14] J. Ihm, A. Zunger, and M. L. Cohen, J. Phys. C: Solid State Phys. **12**, 4409 (1979)
- [15] M. Born and K. Huang, "Dynamical Theory of Crystal Lattices", (Oxford University Press, Oxford, 1954)
- [16] H. J. Monkhorst and J. D. Pack, Phys. Rev. B **13**, 5188 (1976)
- [17] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. R. Flannery, "Numeric Recipes", 2nd ed. (Cambridge, Cambridge, 1992)
- [18] M. P. Teter, M. C. Payne, and D. C. Allan, Phys. Rev. B **40**, 12255 (1989)
- [19] M. C. Payne, M. P. Teter, D. C. Allan, T. A. Arias, and J. D. Joannopoulos, Rev. Mod. Phys. **64**, 1045 (1992)
- [20] R. Car and M. Parrinello, Phys. Rev. Lett. **55**, 2471 (1985)

- [21] R. P. Feynman, Phys. Rev. **56**, 340 (1939)
- [22] O. H. Nielsen and R. M. Martin, Phys. Rev. B **32**, 3780 (1985)
- [23] O. H. Nielsen and R. M. Martin, Phys. Rev. B **32**, 3792 (1985)
- [24] 柳瀬章「空間群のプログラム」裳華房 (1995)
- [25] T. Hahn, ed. "International Tables for Crystallography", Vol. A (Kluwer Academic Pub., Dordrecht, 1996)
- [26] G. Burns and A. M. Glazer, "Space Groups for Solid State Scientists", 2nd. ed., (Academic, San Diego, 1990)
- [27] M. T. Yin and M. L. Cohen, Phys. Rev. B **26**, 3259 (1982)
- [28] J. Ihm and M. L. Cohen, Phys. Rev. B **21**, 1527 (1980)
- [29] J. Stoer and R. Bulirsch, "Introduction to Numerical Analysis", 2nd ed. (Springer, New York, 1992)
- [30] D. J. Chadi and M. L. Cohen, Phys. Rev. B **8**, 5747 (1973)
- [31] C. H. Park, B.-H. Cheong, K. H. Lee, and K. J. Chang, Phys. Rev. B **49**, 4485 (1994)
- [32] J. Callaway, "Quantum Theory of the Solid State", 2nd. ed., (Academic, San Diego, 1991).
- [33] C. -L. Fu and K. -M. Ho, Phys. Rev. B **28**, 5480 (1983)
- [34] M. R. Pederson and K. A. Jackson, Phys. Rev. B **43**, 7312 (1991)
- [35] M. T. Yin, *Proc. 17th Int. Conf. on the Physics of Semiconductors*, eds. J. D. Chadi and W. A. Harrison (Springer, NY, 1984) p. 927
- [36] O. Jepson and O. K. Anderson, Solid State Commun. **9**, 1763 (1971)
- [37] C. Herring, Phys. Rev. **52**, 365 (1937)
- [38] G. F. Koster, *Solid Stete Physics* **5**, (1957) p. 173. 指標表はとかくミスプリントがありがちだ。脈絡のない数字の羅列だから不思議はない。実際この Koster の論文にもそれがある。この Koster のも含めて、主要な指標表のミスプリントの正誤表は、J. L. Warren, Rev. Mod. Phys. **40**, 38 (1968) の付録にある。
- [39] O. V. Kovalev, "Representations of the Crystallographic Space Groups", 2nd ed., translated to English (Gordon adn Breach Scientific Pub., Yverdon, 1993)
- [40] C. J. Bradley and A. P. Cracknell, "The Mathematical Theory of Symmetry in Solids", (Clarendon Press, Oxford, 1972)

- [41] L. Verlet, Phys. Rev. **159**, 98 (1967)
- [42] Technical Report No. 21 「波動関数のプロット」
- [43] D. Frenkel and B. Smit, "Understanding Molecular Simulation", (Academic, San Diego, 1996)
- [44] S. E, Koonin and D. C. Meredith, "Computational Physics", (Addison Wesley, Massachusetts, 1990)